

*User's Guide***AM62L (AM62L32、AM62L31) 处理器系列原理图设计指南
和原理图审阅检查清单****摘要**

本用户指南包括电路板设计人员在使用 AM62L32 和 AM62L31 处理器时应遵循的原理图设计指南、实现建议和原理图审阅检查清单。本用户指南介绍了处理器配置、处理器外设和连接（外部）器件的接口。每个部分末尾都提供了原理图审核检查清单，该清单提供了每个外设和指南部分的完整审核点列表，可供电路板设计人员验证其定制电路板。

此外，还提供了以下项的链接：处理器产品页面、处理器相关资料、E2E 上发布的与处理器和处理器外设相关的常见问题解答，以及一些常用参考文档。电路板设计人员可在定制电路板设计过程中参考这些链接，以更大限度地减少设计错误、优化设计工作，并优化时间安排。

内容

1 简介	2
1.1 用户指南使用指南	2
1.2 处理器列表	3
2 相关配套资料	3
2.1 常用和适用配套资料的链接	3
2.2 定制电路板设计硬件设计注意事项	3
3 处理器选择	3
3.1 AM62Lx 处理器系列变更摘要（相对于 AM62x 处理器系列）	3
3.2 数据表用例和参考的版本	4
3.3 处理器选择（OPN 可订购器件型号）	4
3.4 外设实例命名约定	4
3.5 未使用的外设	4
3.6 处理器订购和质量	4
3.7 处理器选型检查清单	5
4 电源架构	5
4.1 生成电源轨	5
4.2 电源控制和电路保护	8
5 一般建议	8
5.1 处理器性能评估模块 (EVM)	8
5.2 处理器特定 EVM 与数据表	9
5.3 开始设计前	11
6 特定于处理器的建议	13
6.1 通用（处理器启动）连接	13
6.2 使用 JTAG 和 EMU 进行电路板调试	29
7 处理器外设	31
7.1 IO 组的 IO 电源的电源连接	31
7.2 存储器接口（DDRSS (DDR4/LPDDR4)、MMCS（eMMC/SD/SDIO）、OSPI/QSPI 和 GPMC）	32
7.3 外部通信接口（以太网 (CPSW3G0)、USB2.0、UART 和 MCAN）	45
7.4 板载同步通信接口（MCSPI、MCASP 和 I2C）	53
7.5 用户接口（DPI、DSI）、GPIO 和硬件诊断	57
7.6 模数转换器 (ADC)	62
7.7 验证电路板级设计问题	62
8 定制电路板原理图设计的自我审查	65

9 布局注释 (已添加到原理图中)	65
9.1 布局检查清单.....	65
10 定制电路板设计仿真.....	65
11 其他参考内容.....	66
11.1 有关 AM6xx 处理器系列的常见问题解答.....	66
11.2 常见问题解答 - 处理器产品系列和 Sitara 处理器系列.....	66
11.3 处理器连接器件.....	67
12 总结.....	67
13 术语.....	67

商标

WEBENCH® is a registered trademark of Texas Instruments.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc..

USB Type-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.

所有商标均为其各自所有者的财产。

1 简介

1.1 用户指南使用指南

用户指南 (原理图设计指南和原理图审阅检查清单) 提供了可在定制电路板原理图设计期间使用的定制电路板设计指南，并在每部分末尾提供了可用于审阅定制电路板原理图的原理图审阅检查清单，上述设计指南和原理图审阅检查清单均可由电路板设计人员使用。

1.1.1 定制电路板设计 - 实施参考

本用户指南提供了原理图设计指南和原理图审阅检查清单，可在使用所选处理器和外设 (板载或附加) (包括存储器、电源、接口和其他功能块) 的定制电路板硬件设计期间使用。

所选处理器的处理器参考、外部 (板载或附加) 外设的附加器件参考，以上根据所设计的终端设备和应用用例连接到处理器。

1.1.2 特定处理器系列用户指南

本用户指南适用于 AM62Lx (AM62L32、AM62L31) 系列处理器，内容涵盖涵盖定制电路板原理图设计指南和原理图审阅检查清单。本用户指南专为 AM62Lx 处理器系列定制，使用方便，适用于所选的处理器系列。

1.1.3 原理图设计指南

本用户指南为 AM62Lx 处理器系列支持的所有外设提供了原理图设计指南。在定制电路板原理图设计过程中，电路板设计人员可以查看并遵循原理图设计指南。除指南之外，还添加了指向常见问题解答的链接，以便在定制电路板原理图设计期间使用。

原理图设计指南有助于电路板设计人员减少设计工作量，并最大限度地减少可能影响功能和性能的设计错误。

1.1.4 原理图审阅检查清单

每个部分末尾的原理图审阅检查清单已经新增到用户指南中。该用户指南中的所有相关外设或电源部分都包含归为“一般”、“原理图审阅”和“其他”的检查清单。电路板设计人员可以使用检查清单对定制电路板原理图进行自我审查，以尽可能减少可能导致功能或性能问题的错误，从而增加定制电路板的数量。

有关可用检查清单和格式信息，请参阅常见问题解答：[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 - 原理图审阅检查清单](#)

1.1.5 用户指南使用指南的常见问题解答参考

[\[常见问题解答\] AM625 / AM623 / AM62A / AM62P / AM64x / AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 - 定制电路板原理图自检](#)

1.2 处理器列表

本用户指南适用于以下列出的所有处理器。所有相关文档可在 [TI.com](#) 的产品页面上找到。访问下面的处理器链接可访问产品页面。

1.2.1 AM62Lx 处理器系列

有关支持的 OPN 的信息，请参阅 AM62L 产品页面上的 [订购和质量](#) 部分：

- [AM62L](#)

2 相关配套资料

2.1 常用和适用配套资料的链接

[TI.com](#) 上的处理器特定产品页面提供了许多与所选处理器相关的文档。在开始定制电路板设计之前，强烈建议电路板设计人员阅读所有文档。

以下链接汇总了在开始进行定制电路板设计时可以参考的配套资料。

[[常见问题解答](#)] [AM62L : 定制电路板硬件设计 - 入门配套资料](#)

2.2 定制电路板设计硬件设计注意事项

在开始定制电路板设计之前，建议通读并注意下方链接的处理器特定 [定制电路板硬件设计注意事项](#) 用户指南中的建议：

[使用 AM62L \(AM62L32、AM62L31 \) 系列处理器进行定制电路板设计的硬件设计注意事项](#)

3 处理器选择

3.1 AM62Lx 处理器系列变更摘要 (相对于 AM62x 处理器系列)

以下是基于 AM62Lx 的定制电路板设计中需要注意的一些处理器实现要点，或从 AM62x 设计迁移到 AM62Lx 设计时需要注意的变化：

1. 核心电源电压固定为 0.75V
2. 复位输入和复位状态输出已优化
3. 除了双电压 1.8V/3.3V IO 之外，还实现了仅 1.8V 的 IO。已针对 IO 组导轨的 IO 电源进行了相应命名
4. 已实现缓冲器类型 1P8-LVC MOS 和 RTC-LVC MOS，并添加了电气特性
5. 一些处理器外设（包括 CPSW3G0 和 OSPI0）仅支持 1.8V IO 电平
6. DDR4 和 LPDDR4 支持的存储器范围缩小（支持单列）
7. OSPI0 接口支持 x2 接口（可连接到 2 个连接器件）
8. 不支持使用 GPMC0 的非多路复用接口（单独连接地址总线和数据总线）
9. 集成的 LDO 可生成 1.8V/3.3V SD 接口 IO 电源，以支持 UHS-I SD 卡
10. 集成 1 个 10 位的模数转换器 (ADC)，支持高达 1MSPS 的采样率，并配有 4 个模拟输入（时分复用）
11. 精简版引脚数目：仅使用其中 4 个自举引脚 BOOTMODE[15:12]，从电子保险丝引导并配置为减少引脚数量的模式；使用全部 16 个引导引脚 BOOTMODE[15:0]
12. 不支持以太网引导
13. 支持的显示接口包括 MIPI DSI (4 通道 DPHY) 或 DPI (24 位 RGB LVC MOS)（每次仅能主动支持其中一种显示接口）
14. 不支持摄像头串行接口 (CSI-2)
15. 支持仅 RTC 模式和 RTC + IO + DDR 自刷新低功耗模式（不支持用于 CAN/GPIO/UART 唤醒功能的部分 IO）
16. EXT_WAKEUP0 和 EXT_WAKEUP1 引脚用于外部唤醒输入
17. 包括开漏输出型 I2C 接口在内的 I2C 接口具均已优化
18. 为多个外设添加了 IOSET（请参阅处理器特定的数据表）
19. 提供了一个 VTM 温度传感器，即温度传感器 0 : DDR/A53
20. 不支持 VMON_VSYS 电压监测引脚

21. 不支持 3.3V 处理器电源的 VMON_3P3_SOC 电压监控器和 1.8V 处理器电源的 VMON_1P8_SOC 电压监控器
22. PMIC_LPM_EN0 有一个特殊的输出单元，上电后会立即开启弱上拉。弱内部上拉会在 RTC_PORz 的上升沿驱动输入为高电平时同时关闭（在 AM62Lx 处理器中，由于在复位位置为有效时 PMIC_LPM_EN0 IO 被关闭，因此需要外部上拉。在这种情况下，如果没有外部上拉电阻器，PMIC 永远不会开启）
23. 更新了具有开漏输出型 I2C 缓冲器的 I2C 接口的引脚连接要求。仅当使用 IO 时，才需要上拉

3.2 数据表用例和参考的版本

处理器特定数据表包括所有适用处理器外设的引脚属性（引脚到功能映射）、引脚说明、引脚连接要求、电气特性、时序和开关特性，以及所有处理器电源轨的时序图、建议工作条件、电源时序。

用户指南更新过程中引用的数据表列表及其修订编号：

AM62Lx

SPRSVA1 – 2025 年 3 月

如需更多信息，请参阅常见问题解答：[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 当前数据表的修订版本、更新和使用说明](#)

3.3 处理器选择 (OPN 可订购器件型号)

如需简要了解处理器架构以及如何选择处理器（基本生产器件型号）、特性、封装 (ANB) 和速度等级，请参阅处理器特定数据表的 功能方框图 和 器件比较 部分。

请参阅处理器特定数据表的 器件比较部分、器件及文档支持部分，选择所需的处理器 OPN。

建议使用所选的 OPN 更新原理图中所选处理器订购器件型号。

3.4 外设实例命名约定

对于外设命名和实例，处理器特定 TRM 往往是 通用的，而处理器特定数据表是 特定的。

在数据表中，即使是单个外设实例，也会分配后缀编号。引用外设名称的文档不需要根据处理器的不同而进行更改。

后缀以 0 开头。对于通用平台以太网交换机 3 端口千兆位 (CPSW3G) 端口名称，端口 0 是交换机的内部（通信端口编程接口 (CPPI) 主机）端口。

3.5 未使用的外设

在不使用时，具有专用功能的外设具有连接要求。有关连接未使用的外设的信息，请参阅处理器特定数据表的 引脚连接要求 一节。连接要求包括连接电源和接口信号的建议。

当未指定连接要求时，具有未使用的替代功能的外设（处理器 IO）可保持未连接状态。焊盘配置可以是复位状态配置。

如需更多信息，请参阅常见问题解答：[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 数据表引脚属性及引脚连接相关问题](#)

常见问题解答是通用的，也可用于 AM62Lx 处理器系列。

3.6 处理器订购和质量

有关所选处理器系列的订购和质量的信息，请访问以下链接：

[AM62L 在订购和质量 部分中查找 AM62L32。](#)

3.7 处理器选型检查清单

一般

在定制电路板原理图设计过程中、查看和验证以下配套资料和信息：

1. 器件选择（根据所需特性选择的处理器 OPN（可订购器件型号））
2. 引脚属性（焊球名称、信号名称和每一列的内容，包括功率）和引脚映射符合数据表
3. 引脚连接要求（针对已使用和未使用的外设）
4. RSVD（保留）引脚的连接建议
5. 用于探测的板载调试配置（OBSCLK n [n = 0-1] 和 CLKOUT0）
6. 有关支持的引导模式和相关外设的勘误表
7. 建议的运行条件、内核、存储器接口、模拟和 IO 电源的上电和断电时序
8. 所选外设的电气特性和时序信息
9. 所选外设的应用手册、实施建议和布局指南

4 电源架构

如需了解概述，请参阅 [TI 电源管理](#) 页面。

此外，[WEBENCH® 电路设计器工具](#) 还提供一个可视界面，用于创建定制电源和有源滤波器电路。

4.1 生成电源轨

可使用集成式或分立式电源架构生成所选处理器所需的电源轨。使用集成式电源架构 (PMIC) 可简化处理器特定电源架构（电源）的设计。PMIC 可生成常用的电源轨，以便为处理器和附加器件供电。管理上电时序、下电时序和电源压摆率控制，并满足处理器特定的电源要求。除了 PMIC，还使用其他直流/直流转换器和 LDO，以根据用例生成额外的板载电源。

分立式电源架构可让您在设计和元件选型方面具有灵活性。电路板设计人员负责选择能提供所需电流、所需输出电压、支持所需负载瞬态响应、控制压摆率和电源时序的电源器件。

处理器电源轨指定了压摆率要求。对于所有生成的电源轨或开关电源轨，请参阅处理器特定数据表的电源压摆率要求一节。

接下来的几节汇总了为使用不同电源架构生成板载电源而推荐的器件系列及相关配套资料。

4.1.1 AM62Lx

4.1.1.1 电源管理 IC (PMIC)

有关受支持或经过测试的基于 PMIC 的电源架构，请参阅 EVM 原理图。TPS65214x PMIC 系列支持 RTC + IO + DDR 自刷新低功耗模式。

对于使用 DDR4 的定制电路板设计，PMIC 的 NVM 配置、PMIC 生成的电源导轨以及支持低功耗模式的电源架构可能会有所不同。设计具有 DDR4 的定制电路板时，请参阅 TI.com 上 [AM62L](#) 处理器产品页面和 TPS65214 PMIC 产品页面上提供的文档，或使用 E2E 社区资源。

请参阅处理器产品页面上的 [AM62L 电源实现应用手册](#)，了解针对不同应用场景和低功耗模式的 AM62L 电源架构实现的说明。

请参阅与残余电压和检测相关的常见问题解答：

[[常见问题解答](#)] [AM625/AM623/AM62A/AM62D-Q1/AM62P/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 - 与残余电压和检测相关的疑问](#)

4.1.1.1.1 TPS65214x 基于 PMIC 的电源架构检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 基于 DDR 配置 (LPDDR4、DDR4) 的 PMIC 选择 (NVM 修订版的可订购器件型号)
3. 添加所需输入和输出电容器，包括值、反馈配置和引脚连接
4. 考虑降额时所选电容器的额定电压 (常用指南为最坏情况下施加电压的两倍)
5. 建议的 PMIC 控制和 IO 信号配置 (包括对负载开关或直流/直流控制)，用于对处理器 IO 电源序列进行排序
6. 电源导轨的命名 (指示配置的输出电压电平)
7. PMIC 电压电平与处理器和连接器件的电源要求相匹配
8. 处理器和连接器件 IO 电源的网络名称匹配 (同名)
9. 与处理器的连接以支持低功耗模式 (当使用低功耗模式时)

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 将定制 PMIC 实现方案与电容器和值、IO 连接和降压输出反馈连接的 EVM 原理图实现方案进行比较
2. 处理器到 PMIC 以及 PMIC 到处理器 IO 接口连接
3. 连接处理器 IO 电源时序所需的控制信号 (处理器和所连接器件 IO 电源输出电压转换率压摆率控制的负载开关 EN)
4. 在考虑用例的情况下，使用的处理器和 PMIC I2C 接口与建议使用的接口
5. SD 卡 IO 电压 (使用内部 LDO) 控制配置引脚连接 (在处理器或电路板复位时为 3.3V，之后切换到 1.8V)
6. 当 PMIC 的 nRSTOUT 直接连接到处理器的 PORz (及 RTC_PORz) 输入时，其转换率 (上拉值) 的要求 (建议使用分立式推挽输出缓冲器)
7. 中断、MODE/STBY 信以及 EN/PB/VSENSE 信号的连接
8. 与 PMIC 搭配使用的其他分立式直流/直流电源和 LDO 的配置
9. VPP 电源 (电子保险丝编程) 外部 LDO 的实施、输出控制，并在考虑负载电流瞬态的情况下增加大容量电容器和去耦电容器，并提供隔离电阻器来测试 VPP 使能时序
10. PMIC IO 所需上拉电阻的连接
11. 当配置为低功耗模式时，PMIC IO 连接到处理器 RTC_PORz

其他

1. 如果电源架构基于 TI PMIC，请通过 PMIC 业务部门或产品线审查电源架构的实现。
2. 建议在电源导轨 (降压和 LDO) 的输出端使用 0Ω 的电阻器或跳线，以便在初次制作电路板时进行隔离或电流测量。选择额定电压适用于电源导轨电流的电阻器
3. 分别显示用于降压输入和 VSYS 的 PMIC 输入大容量电容器连接，并且每个电容器应靠近各引脚，以便于放置和布线。
4. 请参考 EVM 实现
5. 已查看并遵循与残余电压相关的常见问题解答。

4.1.1.2 其他参考内容

有关更多信息，请参阅处理器特定数据表的以下章节。

- 器件连接和布局基本准则
- 电源
- 电源设计

4.1.1.2 分立式电源

请参阅 [TI.com](#) 上的 [AM62L](#) 产品页面，了解建议的分立式电源架构。

请参阅 EVM 原理图，了解如何使用 LDO 实现 RTC 电源和使用 DC/DC 转换器生成 3.3V 主电源。

AM62L 产品页面提供了有关可用电源架构的更新信息。

在考虑分立式电源架构实现时，可以参考以下部分：

电源架构基于分立式 DC/DC 转换器和 LDO。电源序列通过使用电源正常输出和离散逻辑来实现。

考虑使用定制分立式电源架构时，请注意数据表中指定的所有处理器电源斜升后振荡器启动的 PORz (L->H) 保持时间（延迟）要求。

PORz 需要在加电期间保持低电平（激活状态），直到所有处理器电源有效（使用外部晶体电路），并额外保持最短 9.5ms 的延迟；或 PORz 保持低电平（激活状态），直到所有处理器电源有效且外部时钟稳定（使用外部 LVCMS 时钟源时），并额外保持最短 1.2 μs 的延迟。

4.1.1.2.1 直流/直流转换器

考虑使用 [TPS63070](#) 或 [LM5141](#) 器件等直流/直流转换器。

有关可用直流/直流转换器的概述，请参阅[交流/直流和直流/直流转换器（集成 FET）](#)页面。

如需了解详情，请参阅以下链接：

[TI 降压开关直流/直流转换器快速参考指南应用手册](#)

[电源设计培训资源 - 视频库](#)

4.1.1.2.2 LDO

考虑使用 [TPS74501](#) 和 [TLV75518](#) 等 LDO 器件。

要了解可用的 LDO，请参阅 [TI 线性和低压降 \(LDO\) 稳压器](#) 页面。

如需了解详情，请参阅以下链接：

[低压降稳压器快速参考指南](#)

[LDO 线性稳压器设计指南](#)

[TI LDO 应用手册的主题索引](#)

4.1.1.2.3 分立式电源检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册
2. 所有电源轨配置的输出电压和所需的额定电流
3. 输出电压反馈连接和反馈分压电阻器容差
4. 精选的分立式直流/直流架构支持有源放电
5. 连接处理器的分立式直流/直流输出电源的转换率符合处理器电源转换要求，所有电源导轨的时序也符合处理器要求
6. 所有电源斜升后的 PORz 输入（PG 输出）转换率（通过分立式推挽输出缓冲器进行连接）和 L 至 H 延迟（PORz 输入低保持时间）实现
7. 考虑降额时所选电容器的额定电压（常用指南为最坏情况下施加电压的两倍）
8. 分立式直流/直流或 LDO 器件选择、包括输出电压电平和电流额定值、有源放电能力、残余电压检测（仅在断电后电源电压小于 0.3V 时才允许上电）
9. SD 卡接口 IO 电源的实现支持 UHS-I SD 卡和电子保险丝编程 VPP 电源
10. 电源导轨的命名（指示配置的输出电压电平）
11. 分立式直流/直流或 LDO 输出电压电平与处理器和连接器件的电源要求 (ROC) 相匹配
12. 处理器和连接器件 IO 电源的电源网络名称匹配（同名）

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 电阻分压器值（包括连接到反馈输入以生成所需输出电源电压的容差）与计算值匹配

2. PG 输出具有所需的上拉电阻，并连接到另一个分立式直流/直流或 LDO EN 以进行电源时序
3. 分立式直流/直流或 LDO 输出电源转换率
4. 电源斜升后的 PORz 输入低保持时间（如果分立式直流/直流 PG 输出直接连接到处理器 PORz 输入）

其他

1. 如果电源架构基于 TI 电源，请通过相关业务部门或产品线审查电源架构的实现
2. 建议在电源轨的输出端使用 0Ω 电阻器或跳线进行隔离或电流测量，以实现初始电路板构建。选择额定电压适用于电源导轨电流的电阻器

4.2 电源控制和电路保护

4.2.1 负载开关（电源开关）

使用负载开关控制（打开和关闭）由同一电源导轨供电的特定外设或子系统的电源，而不是使用多个直流/直流转换器或 LDO 生成电源。在某些应用中，建议遵循建议的上电和下电序列。负载开关简化了实现电源时序控制，以满足上电和下电要求。负载开关使能由 PMIC 或直流/直流转换器 PG 控制，以满足处理器电源时序要求。

考虑 [TPS22965](#)、[TPS22918](#)、[TPS22902](#) 和 [TPS22946](#) 等负载开关。

要了解可用负载开关的概述，请参阅 TI [负载开关](#) 页面。

4.2.1.1 负载开关检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 负载开关电流额定值
3. 负载开关使能时序控制（PMIC GPIO 或直流/直流 PG）
4. 输出电压压摆率配置
5. 考虑降额时所选电容器的额定电压（常用指南为最坏情况下施加电压的两倍）

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 输入和输出电容器值和额定电压
2. 根据处理器 IO 电源压摆率要求配置输出电压压摆率（电容器值选择）

4.2.2 电子保险丝 IC（电源开关和保护）

电子保险丝电源开关和保护 IC 是集成的电源路径保护器件，用于在故障情况下将电路电流和电压限制在安全电平。电子保险丝为设计提供了许多优势，并且包含通常难以使用分立式元件实现的保护功能。要了解可用的电子保险丝，请参阅 TI [电子保险丝和热插拔控制器](#) 页面。

5 一般建议

以下一般建议部分包含电路板设计人员在设计定制电路板时应熟悉的建议和指南。

5.1 处理器性能评估模块 (EVM)

处理器（硬件）性能评估模块和平台 (EVM) 不是参考设计，这些模块和平台并不代表正确或完整的电路板或系统实现。在许多情况下，EVM 在处理器设计完成之前便已进行了部分或完全设计并发布进行制造。设置时间表是为了在首批器件到手后便可使用硬件平台。在处理器启动和基准测试期间会出现新的处理器要求。硬件评估平台可能并未考虑到所有这些新要求。因此，TI 希望电路板设计人员在设计定制电路板时仔细检查并遵循处理器特定数据表、器件勘误表和 TRM 中定义的所有要求。

处理器（硬件）性能评估平台的设计并未涵盖 EMI 或 EMC 目的（减少辐射发射）、噪声敏感性、热管理等所有电路板或系统特定要求。

有关设计更新说明，电路板设计人员可以参考以下常见问题解答以及 EVM 原理图：[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM62A 定制电路板硬件设计的常见设计错误/建议 - SK 原理图设计更新说明](#)

常见问题解答是通用的，也可用于 AM62Lx 处理器系列。

5.1.1 评估模块检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 以 EVM 为基准与选定的处理器系列匹配
3. 基准 EVM 板上的处理器封装与为定制电路板设计选择的处理器相匹配
4. 基准 EVM 原理图修订版本包括设计说明 (D-Note)、修订说明 (R-Note) 和 CAD 说明 (CAD Note)

5.2 处理器特定 EVM 与数据表

如果在评估或定制电路板设计期间处理器特定 EVM 和数据表之间存在任何差异，请遵循数据表。尽管电路板设计人员已经尽了很大努力，但 EVM 还是包含仍然起作用但不完全符合数据表规范的错误。

5.2.1 有关元件选择的注意事项

EVM 元件选型并非总是经过优化。查看 BOM，并根据数据表建议、应用要求和电路板电路设计来优化元件选型。

建议在最终确定元件参数值和额定值（例如电压和功率）之前，根据需要进行设计计算、设计审查并执行板级测试和测量。

5.2.1.1 串联电阻

电路板设计人员可以将串联电阻的建议值作为起点。验证定制电路板设计上的值并进行相应调整（引脚上出现的阶跃函数不接近 $1/2 \text{ Vs}$ ）。

5.2.1.2 并联拉电阻

提供配置，向处理器 IO 添加并联拉电阻。并联拉电阻的极性和值取决于特定的外设连接建议、处理器性能提升建议以及相关接口或标准要求。

处理器特定 EVM 拉电阻值可用作起点，电路板设计人员可根据处理器和连接器件或特定电路板设计实现的建议选择适当的拉电阻值。

当布线连接到处理器 IO 焊盘且未被主动驱动时，建议使用并联拉电阻。拉电阻极性取决于设计用例。复位期间，处理器 IO 缓冲器关闭，IO 处于高阻抗状态，实际上是用作拾取噪声的天线。如果没有任何端接，则 IO 均为高阻抗状态。高阻抗使得噪声很容易将能量耦合到悬空信号布线上，并产生可能超出建议工作条件的电势，从而在 IO 上产生电气过应力 (EOS)。处理器内部的静电放电 (ESD) 保护电路设计用于在将器件安装到 PCB 组件上之前防止对其进行处理。

5.2.1.3 驱动强度配置

TI 当前不支持为 SDIO 和 LVCMS 缓冲器配置除标称（默认）值以外的任何其他驱动强度，因为标称值是唯一已关闭芯片级 STA（静态时序分析）的配置。标称值对应于 SDIO 的 40Ω 和 LVCMS 的 60Ω 。IBIS 模型已更新为仅包含已在内部关闭时序的那些驱动强度。

有关驱动强度配置支持相关信息，请参阅常见问题解答：[\[常见问题解答\] AM625 / AM623 / AM62A / AM62P / AM62D-Q1 / AM64x / AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 - SDIO 和 LVCMS 的 I/O 驱动强度配置](#)

常见问题解答是通用的，也可用于 AM62Lx 处理器系列。

5.2.1.4 数据表建议

电路板设计人员负责实现任何必要的预防措施，以确保定制电路板设计不会违反处理器特定数据表中指定的要求。示例处理器要求包括 I₂C 开漏和失效防护 (I₂C OD FS) 电气特性 - 输入压摆率。

当没有数据表建议时，可以先参照以下检查清单中提供的建议，或使用 EVM 原理图中的实现作为起点。

5.2.1.5 处理器 IO - 外部 ESD 保护

由于内部 ESD 保护电路并非专为满足电路板级 ESD 要求而设计，因此建议为直接连接到外部连接器或暴露在外部输入下的任何处理器 IO 提供外部 ESD 保护。要了解 ESD 保护器件，请参阅 TI [ESD 保护](#) 页面。

5.2.1.6 外设时钟输出串联电阻器

由于时钟输出也用于重定时，因此建议对处理器时钟输出引脚附近的时钟输出使用串联电阻器来解决时钟源处的信号失真问题。对于 MMCx 和 OSPI，由于使用非接合焊盘，因此不需要串联电阻器。在某些情况下，出于信号完整性目的，需要使用低值串联电阻器。建议保留串联电阻器作为占位器件，以防需要提高信号完整性。

5.2.1.7 元件选型检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册
2. 选择电阻值、容差、尺寸和功率
3. 只有特定电阻器需要 1% 的容差（请参阅处理器或连接器件数据表、EVM 原理图）
4. 标准容差电阻器可用于其他用例，例如：上拉、下拉或串联电阻器
5. 将定制电路板上的拉电阻值与 EVM 原理图进行比较
6. 包含降额的所用电容器的额定电压（常用准则是最坏情况下施加电压的两倍以上）
7. 考虑直流偏置影响的电容器的额定电压（处于建议值范围内）
8. 封装选择（取决于应用和用例，考虑电压和温度范围）
9. 选择兼容的连接器件（DDR 和闪存、EPHY）
10. 建议的存储器大小、选择所需的存储器大小 (DDR) 并根据需要提供扩展存储器的配置
11. 查看与无源器件参数值、容差和额定电压相关的常见问题解答

有关在 EVM 和 SK 上使用的关键元件、元件值和容差的信息，请参阅常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM62A/AM62P/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 入门套件/EVM 型号 \(版本\) 和关键元件列表](#)

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM62A/AM62P/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 与无源元件参数值、容差和额定电压相关的疑问](#)

常见问题解答是通用的，也可用于 AM62Lx 处理器系列。

5.2.2 有关重复使用 EVM 设计的额外信息

5.2.2.1 更新了 EVM 原理图（添加了设计、审核和 CAD 注解）

在定制电路板设计过程中，设计人员经常重复使用 EVM 设计文件，并修改设计文件。此外，设计人员也会重复使用常见实现方式，包括处理器、存储器以及通信接口等。EVM 被寄予实现更多附加功能的厚望，所以设计人员会对 EVM 实现进行优化，以符合电路板设计的要求。在对 EVM 原理图进行优化时，会在定制设计中引入误差，这类误差会导致功能、性能或可靠性方面的问题。优化过程中，如设计人员对 EVM 实施存在疑惑，可能会导致设计错误。许多这类优化和设计错误在各种设计中很常见。根据诸多电路板设计人员的意见和数据表中的引脚连接建议，我们在 EVM 原理图的各部分附近添加了全面的设计要点 (D-Note)、审核提示 (R-Note) 和 CAD 注解 (CAD-Note)，供设计人员查看并遵循，以便更大限度减少设计中的错误。

此外，设计文件下载包中还包含了一系列附加文件，以支持评估工作。

TMDS62LEVM：<https://www.ti.com/lit/zip/sprcal6>

可下载的文档列表包含在上述 zip 文件中附带的产品概述文档中。

请参阅常见问题解答，其中包含 PDF 原理图以及与 EVM TMDS62LEVM 相关的其他信息：

[\[常见问题解答\] AM62L : 定制电路板硬件设计 - 关于重复使用 EVM TMDS62LEVM 原理图的设计和审阅说明](#)

5.2.2.2 EVM 设计文件重复使用

根据定制电路板设计期间遵循的设计方法和项目进度，可以重复使用 EVM 设计文件，以此为起点进行所需的更新。建议验证 EVM 实现和元件选型。

以下常见问题解答中汇总了电路板设计人员在重复使用 TI EVM 设计文件时必须熟悉的注意事项。

[\[常见问题解答\] AM62L : 定制电路板硬件设计 - 重复使用 TI EVM 设计文件](#)

5.2.2.2.1 模块化原理图部分

EVM 原理图中的页面数量已增加。现在，每个页面都设有专门的部分，便于查看和重复使用。页面按照使用优先级的顺序排列。原理图的起始页中列出了 EVM 原理图的常用部分。常用原理图部分下方列出了能够增强性能或对于定制电路板设计为可选的部分。

5.2.2.2.2 重复使用 EVM 设计检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引用所选或所需 EVM 设计的最新版本
3. 考虑了 D-Note 和 R-Note
4. 当另存为不同项目时，可重置元件 DNIS 配置，或者重新排列原理图页面或电路部分
5. 将原理图设计转换为替代 CAD 工具时，连接（包括端口连接）的变化

5.3 开始设计前

5.3.1 文档

在定制板设计周期中，建议参考或使用最新版本的文档，示例包括处理器特定数据表、器件勘误表、TRM 和其他常用参考设计资料。在处理器特定产品页面上查看是否有最新可用文档或添加的新文档。

文档搜索提示：在文档中搜索 *recommended*、*Required*、*do not*、*note*、*pin connectivity* 等字词。处理器的重要条件通常包含其中一个或多个词语。

获取更新信息的技巧：在 TI.com 的处理器产品页面上，有一个 *Notifications* 按钮。在此按钮处注册便可启用关于处理器文档更改的自动通知。

5.3.2 处理器引脚属性（引脚排列）验证

验证以下引脚属性：

- 处理器引脚标签对应于处理器特定数据表的引脚属性部分中列出的正确引脚编号。在符号中保留数据表名称，并根据应用用例更改功能（网）名称。
- 连接到处理器电源引脚的电源电压处于建议运行条件内。
- 原理图中显示了处理器的所有引脚（按功能分组并具有单独的符号块，包括保留的引脚），以更大程度地减少工具相关错误和功能错误。
- 大多数处理器 IO TX（输出）和 RX（输入）缓冲器和上拉电阻器在复位期间关闭。建议使用外部拉电阻将任何所连接器件的输入保持在有效逻辑状态，直到软件在连接了 TP 或布线并且未主动驱动 IO 时初始化 IO。是否使用拉电阻取决于所连接器件的 IO 能力。
- 为了提高定制电路板的性能，建议实现对电压、电流或温度的外部监控。

有关处理器特定数据表引脚属性的相关问题，请参阅常见问题解答。

[常见问题解答] AM625/AM623/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 数据表引脚属性及引脚连接相关问题

常见问题解答是通用的，也可用于 AM62Lx 处理器系列。

5.3.3 器件比较、IOSET 和电压冲突

请参阅处理器特定数据表的器件比较一节中有关共享 IO 引脚的注释。IOSET 是特定于某个接口的信号分组，这些信号作为一个集合进行计时，包括电源导轨电压电平。IOSET 确保 IO 组的相同 IO 电源用于信号对。IOSET 由 SysConfig 工具强制执行。该处理器使用 IOSET 进行时序闭合。建议任何具有 IOSET 的接口都从同一 IOSET 中选择所有接口信号。某些接口信号可以通过多个 IOSET 共享。SysConfig-PinMux 工具中详细介绍了有效的引脚组合。请注意，根据具体使用情况，用于特定接口的 IO 之间可能存在 IO 组 IO 电源不匹配问题。

有关电压冲突和 IOSET 的信息，请参阅常见问题解答：[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 - 与 SysConfig-PinMux IOSET 和电压冲突相关的疑问](#)

常见问题解答是通用的，也可用于 AM62Lx 处理器系列。

5.3.4 RSVD 预留引脚（信号）

名为 RSVD 的引脚被预留。按照数据表中的建议，将 RSVD 引脚保持未连接状态（无 TP 连接）。

建议不要将任何 PCB 布线或测试点连接到 RSVD 引脚。

如需更多信息，请参阅常见问题解答：[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM625SIP/AM625-Q1/AM620-Q1 定制电路板硬件设计 - RSVD 引脚连接建议](#)

常见问题解答是通用的，也可用于 AM62Lx 处理器系列。

5.3.5 PADCONFIG 寄存器注意事项

许多处理器 IO 都支持功能的多路复用。可以从多种功能中选择 IO 功能。处理器特定数据表的引脚属性表的信号名称列中枚举了每个焊盘上可用的功能列表。

通过相关焊盘配置寄存器的 MUXMODE 字段选择所需的功能。这些寄存器

(PADCFC_CTRL0_CFG0_PADCONFIG0 到 PADCFC_CTRL0_CFG0_PADCONFIG146) 控制处理器主域中 IO 信号的多路复用。

处理器特定 TRM 的焊盘配置寄存器一节中的焊盘配置 PADCONFIG 寄存器表汇总了所有 PADCONFIG 寄存器的位字段复位值。配置 PADCONFIG 寄存器时，请遵循表末尾列出的注释。在与相应 PADCONFIG 寄存器关联的引脚没有有效逻辑状态的情况下，切勿设置 RXACTIVE 位。悬空输入可能会损坏处理器或影响可靠性。

5.3.6 针对失效防护操作的处理器 IO（信号）隔离

当处理器和所连接器件或额外处理器由不同的电源供电时，建议进行信号隔离，因为大多数处理器 IO 都不具有失效防护功能。建议通过 FET 总线开关电路来路由信号，该电路设计用于在 IO 电源对两个器件均无效时自动隔离这两个器件。建议 FET 总线开关和控制逻辑由常开电源供电，并且仅由不同电源的电源正常信号的“与”函数启用。

5.3.7 处理器特定 EVM 的参考

当处理器特定的数据表中没有提供具体建议时，有关实现示例和值，请参阅处理器特定的 EVM [TMDS62LEVM](#) 原理图。

5.3.8 高速接口设计指南

有关 USB2.0 信号连接和布线的详细建议，请参阅 [高速接口布局布线指南](#)。包括要在定制电路板设计中遵循的适当约束或布线要求。

对于 USB 接口，在恶劣的工业环境中运行时，可添加共模扼流圈来提高定制电路板的性能。添加共模扼流圈会降低信号振幅并降低性能。为使用 0Ω 电阻绕过共模扼流圈添加配置。应考虑根据应用要求添加外部 ESD 保护。

5.3.9 LVC MOS (GPIO) 输出的推荐拉电流或灌电流

直流拉电流输出需要保持小于定义的最大 I_{OH} 和 I_{OL} 值，以实现相应电气特性表中定义的 V_{OL} 最大值和 V_{OH} 最小值。建议拉电流或灌电流不应超过处理器特定数据表中定义的限制，并且首选直流拉电流或灌电流应明显小于这些限制，以免增加散热或带来其他问题。

这些高电流电平的开关会产生电气噪声，这些噪声会耦合到其他电路，从而需要在相应的 IO 电源导轨上使用额外的去耦电容器。

5.3.10 将慢速斜升输入或电容器连接到 LVC MOS IO (输入或输出)

LVC MOS 输入指定了压摆率要求。不建议将慢速斜升信号直接连接到 LVC MOS 输入或 LVC MOS 输入端的电容器。当施加慢速斜升输入时，CMOS 输入会产生击穿电流，当输入为 $1/2 V_S$ 时，该电流将从 VDD 通过部分导通的 P 沟道晶体管和部分导通的 N 沟道晶体管流向 VSS 。累积的慢速斜升会导致性能或可靠性问题。

LVC MOS 输出缓冲器不适用于驱动大型容性负载。当 LVC MOS 类型 IO 配置为输出并连接到电容器时，请遵循数据表建议的允许电容值或添加串联电阻器以限制 IO 电流或执行仿真。

5.3.11 定制电路板设计过程中与处理器相关的疑问和说明

有关处理器选择、功能和指南的疑问和说明，TI 建议使用 [E2E](#) 论坛。使用 E2E 提问或参考相关问题和先前的答案。

5.3.12 开始设计前检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 定制电路板原理图上使用的处理器原理图符号遵循相应的处理器特定数据表引脚属性部分中针对特定外设的焊球名称、引脚编号和 IOSET 分组建议
3. 考虑了所需的 IO 功能和焊盘配置
4. 考虑了处理器 IO 的失效防护运行和负载要求
5. 根据用例缓冲处理器 IO (输出) 以驱动更高的负载
6. 所选 EVM 设计的最新版本被引用

其他

1. 请参阅 TI.com 上的相关配套资料，更大限度地减少设计误差并优化设计工作量
2. 经常查看 TI.com 上的产品文件夹以了解最新文档修订版（针对感兴趣的文档）
3. 使用 E2E 寻求解释

5.3.13 器件建议

TI 不提供器件建议。

选择 DDR4、LPDDR4 内存时，建议参考数据表 DDR 电气特性部分。

与 MMC0 关联的 MMCSD 主机控制器和 PHY 的设计符合数据表和 TRM 中所述的标准。

建议在选择 eMMC 或 SD 卡时，参考数据表的 MMC0 - eMMC/SD/SDIO 接口部分。

有关 EVM 和 SK 上使用的关键元件的信息，请首先参阅常见问题解答：[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM62A/AM62P/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 入门套件/EVM 型号 \(版本 \) 和关键元件列表](#)

6 特定于处理器的建议

6.1 通用 (处理器启动) 连接

6.1.1 电源

请遵循下列建议：

- 每个电源轨的电源要求因使用的接口和工作环境而异。
- 处理器电源轨的电流消耗可以通过功耗估算工具 (**PET**) 进行估算。如果电源轨为其他板载连接 (外设) 器件供电，则考虑这些器件的最大电流消耗。
- 有关不同处理器电源导轨的电源尺寸和最大电流额定值的信息，请参阅 **AM62L 最大电流额定值应用手册**。（请访问 [TI.com](#) 上的处理器特定 (**AM62L**) 产品页面）。
- 验证所选电源架构（包括 PMIC、直流/直流转换器和 LDO）的输出电流额定值是否满足处理器和所有连接器件的最大电流需求。针对设计差异添加额外的裕度。
- 验证是否遵循了建议的电源序列（上电和下电）。有关建议的电源时序要求，请参阅处理器特定数据表的电源时序一节。

有关处理器的建议运行条件 (**ROC**)，请参阅常见问题解答：[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM62A/AM62P/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 - SOC ROC 建议运行条件](#)

常见问题解答是通用的，也可用于 **AM62Lx** 处理器系列。

以下是选择或设计处理器电源架构时需要考虑的一些指南：

1. 电源配置为所需的电压电平、并且电源在 **ROC** 内
2. 电源架构遵循处理器特定数据表规定的上电与下电序列
3. 电源架构符合处理器特定数据表规定的所有电源导轨的转换率要求
4. 在 **PORz** 释放之前，所有电源均可用
5. 监控所有电源导轨。确保仅在下电上电后电压低于 0.3V（无残余电压）时才启用电源（没有与该要求相关的时间或范围。在允许任何电源导轨斜升前，每个电源导轨必须降至 0.3V 以下）
6. 电源斜升和 **PORz** 高电平之间的延迟应符合数据表建议（最小值为 9.5ms）
7. **PORz** 的输入转换率应尽可能小，以避免内部复位电路干扰

请参阅与残余电压和检测相关的常见问题解答：[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM62A/AM62D-Q1/AM62P/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 - 与残余电压和检测相关的疑问](#)

6.1.1.1 内核和外设的电源

为确保正常运行，请将所有电源引脚（焊球）连接到处理器特定数据表建议运行条件一节中建议的电源电压。处理器特定数据表的引脚连接要求一节指定了具有特定连接要求的电源引脚。

6.1.1.1.1 电源斜升（转换率）要求和动态电压调节/更改

与处理器相关的所有电源都应允许受控的电源斜升（电源压摆率）。有关更多信息，请参阅处理器特定数据表的电源转换率要求部分。

处理器（系列）不支持动态电压调节。

有关动态电压调节 (**DVS**) 和动态频率调节 (**DFS**) 的更多信息，请参阅常见问题解答：

[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM62A/AM62P/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 - 动态电压调节](#)

常见问题解答是通用的，也可用于 **AM62Lx** 处理器系列。

6.1.1.1.2 AM62Lx

根据建议操作条件 (**ROC**) 表中定义的有效的操作范围，**VDD_CORE**、**VDDA_CORE_DSI**、**VDDA_CORE_DSI_CLK**、**VDDA_CORE_USB** 和 **VDDA_DDR_PLL0** 应设置为在 0.75V 下工作，并且这些电源导轨应当由同一个电源提供。请务必注意确保 **VDD_CORE** 和 **VDDA_CORE_USB** 之间的电压差处于 +/- 1% 之内。

建议始终连接 **VDDS_OSC0** 电源。

该处理器包含多个模拟电源引脚，这些引脚可为 **VDDS_OSC0**、**VDDA_PLL0**、**VDDA_PLL1**、**VDDA_ADC**、**VDDA_1P8_DSI** 和 **VDDA_1P8_USB** 等敏感模拟电路供电。建议使用滤波铁氧体电源。

更多信息，请参阅处理器特定数据表的建议运行条件部分和电源时序部分。

6.1.1.3 其他信息

有关处理器电源时序要求的更多信息，请参阅常见问题解答：[\[常见问题解答\] AM625/AM623 定制电路板硬件设计 - 上电和下电的处理器电源时序要求](#)

有关使用铁氧体进行处理器电源导轨滤波的更多信息，请参阅常见问题解答：[\[常见问题解答\] AM625/AM623 定制电路板硬件设计 - 针对 SoC 电源导轨的铁氧体 \(电源滤波器\) 建议](#)

常见问题解答是通用的，也可用于 AM62Lx 处理器系列。

6.1.1.4 处理器内核和外设内核电源检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引脚属性、信号说明和电气规范
3. 对 VDD_CORE 电源导轨施加建议的电压 (0.75V)
4. 根据引脚连接要求，当未使用特定外设时的内核电源连接

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 根据 EVM 原理图比较所有电源轨的大容量电容器和去耦电容器的实现
2. 根据 EVM 原理图，为外设内核电源 (USB、DSI) 提供了铁氧体滤波器
3. 电源轨连接遵循 ROC

其他

1. 对于所有电源轨，请放置一个 0Ω 电阻器或跳线，以便在电源轨的输出端进行隔离或电流测量
2. 器件从复位状态释放后，不允许更改内核电压。如果内核电源关闭，则根据断电序列关闭并斜降所有电源轨，并等待所有电源轨衰减至 300mV 以下，然后再次接通电源
3. 当 USB 驱动程序未初始化且 USB 校准过程未发生时，连接电源并保留所有 USB 引脚对于 USB0 和/或 USB1 是可以接受的。当两个 USB 接口都未使用时，根据引脚连接要求将 USB 电源接地可节省电力（如果低功耗是一项关键要求）
4. 按照处理器特定 EVM 的说明来实现铁氧体和电容器
5. 不建议也不允许对内核电源进行动态电压调节 (DVS)

6.1.1.5 外设模拟电源检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引脚属性、信号说明和电气规范
3. 建议的电压施加到外设模拟电源轨 1.8V
4. 电源轨连接基于处理器系列

AM62Lx : VDDS_OSC0、VDDA_PLL0、VDDA_PLL1、VDDA_ADC、VDDA_1P8_DSI、VDDA_1P8_USB

5. 电源轨 VDDA_3P3_USB 3.3V 模拟电源连接，用于支持 USB2.0 接口
6. 根据引脚连接要求，当未使用特定外设时的外设模拟电源连接

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 根据 EVM 原理图比较所有电源轨的大容量电容器和去耦电容器
2. 根据 EVM 原理图，为外设模拟电源 (PLL、USB (1.8V)) 提供了铁氧体滤波器
3. 电源轨已连接且遵循 ROC

其他

1. 对于所有电源轨，使用 0Ω 电阻器或跳线在电源轨输出端进行隔离或电流测量
2. 当 USB 驱动程序未初始化且 USB 校准过程未发生时，连接电源并保留所有 USB 引脚对于 USB0 和/或 USB1 是可以接受的。当两个 USB 接口都未使用时，根据引脚连接要求将 USB 电源接地可节省电力（如果低功耗是一项关键要求）
3. 按照处理器特定 EVM 的说明来实现铁氧体和电容器
4. 不建议也不允许模拟电源进行动态电压调节 (DVS)

6.1.1.2 IO 组的 IO 电源

常见问题解答提供了有关 CAP_VDD_S_xxx、电容器值以及电容器安装或短路状态的影响的建议：[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM62A/AM62P/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 - CAP_VDD_Sn CAP_VDD_S](#)

该处理器系列为 IO 组提供双电压 1.8V/3.3V IO 电源，为 IO 组提供固定电压 1.8V IO 电源导轨。

IO 组的双电压 1.8V/3.3V IO 电源有两种类型，包括用于 IO 组的固定 1.8V/3.3V IO 电源和用于 IO 组的动态切换 1.8V/3.3V IO 电源。

6.1.1.2.1 IO 组的双电压 1.8V/3.3V IO 电源

该处理器包含 5 个 IO 组的双电压 IO 电源 (VDDSHV_x [x = 0-4])，其中每个域为一组固定的 IO 供电。对于 IO 组的双电压 IO 电源，每个 IO 组的 IO 电源可单独配置为 3.3V 或 1.8V，这决定了由相应 IO 组的 IO 电源供电的整体 IO 的通用工作电压。VDDSHV0 和 VDDSHV1 是 IO 组的固定 1.8V/3.3V IO 电源、而 VDDSHV2、VDDSHV3 和 VDDSHV4 是 IO 组的动态切换 1.8V/3.3V IO 电源。

标记为 CAP_VDD_S_xxx [共 5 个引脚] 和 CAP_VDDSHV_MMC 的处理器焊盘 (引脚) 在 IO 组连接到 3.3V 电源时，将外部电容器连接到 IO 组 LDO 的内部 IO 电源 (当 IO 组电源连接到 1.8V 时为可选)。建议在 CAP_VDD_S_xxx 引脚和 VSS 之间连接一个 $1\mu F$ 的电容器 (详见处理器特定的数据表)。有关建议的电容器额定电压和允许的电容范围，请参阅处理器特定数据表。当 IO 组的 IO 电源连接到 3.3V 时，用于考虑电容器直流偏置效应降额的电压是稳态直流输出，即施加到 CAP_VDD_S_xxx 引脚 (VDDSHV_x/2) 的电压。对于 CAP_VDDSHV_MMC，建议使用 $3.3\mu F$ 的电容。

为了最小化环路电感要求，请将电容器放置在 BGA 阵列 PCB 背面。电容器额定电压的选择会影响电容器封装和尺寸选择。选择 $ESR < 1\Omega$ 的电容器，将布线环路电感保持在 $< 2.5nH$ 。

6.1.1.2.1.1 IO 组的双电压 IO 电源检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引脚属性、信号说明和电气规范
3. 电气特性和其他可用信息
4. 根据 ROC，有效的固定电源连接到 (VDDSHV0、VDDSHV1) 所有 IO 组的 IO 电源
5. 根据处理器特定数据表的 ROC，有效电源 (可动态切换) 连接至 VDDSHV2、VDDSHV3 和 VDDSHV4
6. 遵循 IO 组 IO 电源轨的转换率要求
7. 内部 LDO 输出引脚已连接建议的电容器 (在 CAP_VDD_S_xxx 引脚和 VSS 之间)
8. 遵循了根据处理器特定数据表的电源序列建议

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 将建议电容器连接到 CAP_VDDS_xxx 引脚和 VSS
2. CAP_VDDS_xxx 电容器封装（使用尽可能小的封装（尽可能接近 0201，但不小于 0201），以最小化环路电感）
3. 电容值在 0.8 μF 至 1.5 μF 范围内所选电容器的额定电压（包括：老化、温度以及直流偏置效应）
4. 无论使用何种 IO，IO 组的所有 IO 电源轨都有一个有效的电源
5. 电源轨连接遵循 ROC
6. 每个 CAP_VDDS_xxx 引脚都需要一个相对于 VSS（接地）连接的单独 1 μF 电容器
7. 选择小于 1 Ω ESR 的 CAP_VDDS_xxx 电容器，将布线环路电感保持在 2.5nH 以下

其他

1. 对于所有电源轨，请使用一个 0 Ω 电阻器或跳线，以便在电源轨的输出端进行隔离或电流测量。根据电源轨电流和电阻载流电容器选择电阻器的封装。
2. 当任何 VDDSHVx 电源导轨均由 3.3V 电源供电时，所有以 VDDSHVx 为基准的 IO 必须在 3.3V IO 电平下运行。如果 VDDSHVx 电源导轨由 1.8V 电源供电，则所有以 VDDSHVx 为基准的 IO 必须在 1.8V IO 电平下运行。
3. 一些接口跨越多个 VDDSHVx。使用任意一个接口时，所有支持特定接口的 VDDSHVx 域都必须共用相同的电压源。
4. 大多数处理器 IO 都没有失效防护功能。不建议或不允许在相应 VDDSHVx 电源关闭时向 IO 施加输入电压。
5. 验证每个 VDDSHVx 上的所有 IO 引脚仅连接单个电压电平。
6. 按照处理器特定 EVM 的说明来实现铁氧体和电容器。
7. 不建议将 VDDSHVx 导轨保持未连接状态。根据使用情况和 ROC，将电源引脚连接到 1.8V 或 3.3V。

6.1.1.2.2 用于（外设）IO 组的固定电压 1.8V IO 电源

该处理器包含 3 个用于 IO 组电源（VDDS_WKUP、VDDS0、VDDS1）的固定电压 1.8V IO 电源，其中每个域为一组固定的 IO 供电。

这些是 1P8-LVC MOS 缓冲器类型。电路板设计人员负责将 IO（以 IO 组的固定电压 1.8V IO 电源为基准）连接到具有 1.8V IO 电平的连接器件。

6.1.1.2.2.1 用于（外设）IO 组的固定电压 1.8V IO 电源检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引脚属性、信号说明和电气规范
3. 电气特性和其他可用信息
4. 根据 ROC，将有效的 1.8V 固定电源连接到（VDDS0、VDDS1、VDDS_WKUP、VDDS_RTC）所有（外设）IO 组的 IO 电源
5. 遵循了处理器电源导轨的 IO 电源导轨的转换率要求
6. 遵循了根据处理器特定数据表的电源序列建议

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 无论使用何种 IO，IO 组的所有 IO 电源导轨都连接了有效的电源
2. 电源导轨连接遵循了处理器 ROC
3. IO 的电源电平与 VDDS0、VDDS1、VDDS_WKUP、VDDS_RTC IO 组匹配
4. 按照处理器的要求，遵循了转换率要求

5. 遵循了根据处理器特定数据表的电源序列建议

其他

1. 所有以 VDDS0、VDDS1、VDDS_WKUP、VDDS_RTC 为基准的 IO 都需要在 1.8V IO 电平下运行
2. 大多数处理器 IO 都没有失效防护功能。不建议也不允许在相应 VDDS0、VDDS1、VDDS_WKUP、VDDS_RTC 电源关闭时向 IO 施加输入电压
3. 验证每个 VDDS0、VDDS1、VDDS_WKUP、VDDS_RTC 上的所有 IO 引脚是否仅连接到 1.8V 电压电平。
4. 按照处理器特定 EVM 的说明来添加铁氧体和电容器
5. 不允许使 VDDS0、VDDS1、VDDS_WKUP、VDDS_RTC 电源导轨保持未连接状态。将电源引脚连接至 1.8V

6.1.1.2.3 其他信息

大多数处理器 IO 都没有失效防护功能。有关失效防护 IO 的信息，请参阅处理器特定数据表。建议使用连接到 IO 组相应处理器 IO 电源 (VDDSHVx 或 VDDSx 或 VDDS_WKUP 电源导轨) 的同一电源为连接器件的 IO 电源供电，以确保电路板不会对未供电的 IO 施加电位。建议执行失效防护操作，以保护处理器和所连接器件的 IO。

有关处理器和连接器件之间的电源时序的更多要求，包括用于失效防护操作的信号隔离的信息，请参阅常见问题解答：[\[常见问题解答\] AM625/AM623 定制电路板硬件设计 - SOC \(处理器\) 和连接器件之间的电源时序](#)。

常见问题解答是通用的，也可用于 AM62Lx 处理器系列。

备注

确保在将输入施加到相关处理器 IO 或外设之前，VDDSHVx、VDDSx 或 VDDS_WKUP 存在有效的电源电压。

无论是否使用处理器 IO 或外设，都应连接 VDDSHVx 电源及其相关的 CAP_VDDS_xxx 电容器（当 IO 电源为 3.3V 时需要连接，1.8V 时为可选）。

6.1.1.3 VPP 电源 (电子保险丝 ROM 编程)

在电子保险丝编程期间，处理器 VPP (电子保险丝 ROM 编程电源) 必须保持在 ROC 范围内，是一项重要要求。建议使用由更高输入电源电压 (2.5V 或 3.3V) 供电的 LDO，通过其串联导通晶体管来补偿压降，并在高负载电流瞬态期间保持正确的工作电压。建议在处理器 VPP 引脚附近使用本地大容量电容器来支持 LDO 瞬态响应。

由于高负载电流瞬变以及 VPP 电源轨要匹配电源电压范围的要求，使用变化为 $\pm 5\%$ 的电源轨，或使用负载开关或 FET 为 VPP 供电可能会出现问题。负载开关或 FET 拓扑未考虑通过负载开关的压降。如果电路板设计人员使用变化较小的电源，则可以选择负载开关，以便确保电源变化加上通过负载开关的压降不会超过 VPP 的建议工作范围。

如需更多信息，请参阅常见问题解答：[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM625SIP/AM625-Q1/AM620-Q1 定制电路板硬件设计 - 有关 VPP 电子保险丝编程电源选择和应用的问题](#)。

常见问题解答是通用的，也可用于 AM62Lx 处理器系列。

6.1.1.3.1 VPP 检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引脚属性、信号说明和电气规范
3. 电气特性和其他可用信息
4. 实现板载电源或提供连接外部电源的配置
5. 建议使用 LDO (不建议或不允许使用 FET 开关或负载开关)

6. 所选板载 LDO 支持最小 400mA 电流，具有出色的负载电流瞬态响应和快速输出放电（有源放电）
7. 提供所需的大容量电容器和旁路电容器（遵循 EVM 原理图）
8. 板载 LDO 具有通过处理器 IO 启用的配置
9. 连接外部电源后，在处理器板上靠近处理器 VPP 引脚处添加大容量电容器和去耦电容器配置，并提供一个 TP 以连接外部电源
10. 外部电源遵循数据表中建议的电源序列和压摆率要求
11. 外部电源时序由处理器 IO 控制
12. 在上电序列、断电序列和器件正常运行期间，使处理器 VPP 电源引脚悬空 (HiZ) 或接地

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 使用专用 LDO 或 PMIC 输出
2. 连接到 VPP 的标称电压为 1.8V，支持符合数据表要求的电流要求
3. 所选的 LDO 规格（包括负载电流瞬态响应）与 EVM 原理图中使用的 LDO 类似
4. 处理器 IO 用于控制 LDO 的 EN，并提供所需的拉电阻
5. 验证 EN 拉电阻是否会在下电上电期间使 LDO 保持关断状态
6. 使用可调 LDO 时，请验证输出电压配置、输出电压压摆率和过压保护的使用
7. 该器件配有关联电阻器，用于将处理器 VPP 电源与 LDO 输出隔离开，以测试时序或 LDO 输出
8. 电源导轨连接遵循处理器 ROC

其他

1. 始终在处理器板上提供配置来连接 VPP 电源（板载或外部电源）。
2. 选择具有快速瞬态响应的 LDO，并将 LDO 输出连接到具有低环路电感路径的处理器 VPP 引脚，以提供高瞬态负载电流，其中 VPP 引脚绝不会降至最低工作电压以下。
3. 仅在电子保险丝编程期间启用 VPP。不建议、不允许或不支持将 VPP 电源连接到连续 1.8V 电源导轨。
4. 由于电子保险丝编程期间的瞬态负载电流要求，不推荐使用负载开关或 FET 开关。负载开关或 FET 开关的压降可能太大，在使用 LDO 时无法进行补偿。
5. 如果用例需要使用负载开关或 FET 开关，请在编程期间测量处理器 VPP 引脚上的电压来表征电路板，并验证电源是否会低于 ROC 最小限值。在使用负载开关或 FET 时，VPP 路径中的多个变量可能会导致电源超出 ROC，这些变量在实施前需要进行特性分析。检查或测试负载开关或 FET 开关是否违反数据表中定义的最大 VPP 电源转换率限制（每秒 6000V）。

6.1.1.4 用于配置低功耗模式的电源连接

下方列出了该处理器系列支持的低功耗模式：

6.1.1.4.1 仅 RTC 低功耗模式

请参阅 EVM 原理图，了解如何使用分立式电源实现仅 RTC 低模式电源架构。

请参阅处理器特定数据表中的电源序列图（仅 RTC 低功耗模式时序），了解如何实现仅 RTC 低功耗模式。

6.1.1.4.1.1 使用仅 RTC 模式

建议将常开电源连接到 VDDS_RTC (1.8V) 和 VDD_RTC (0.75V)。VDDS_RTC 和 VDD_RTC 需要在 RTC_PORz 释放之前通电。VDDS_RTC 和 VDD_RTC 的时序控制：VDDS_RTC 和 VDD_RTC 之间没有时序要求。

AM62Lx 处理器唯一的严格排序要求是 VDD_RTC 应在 VDD_CORE 之前上电，并在 VDD_CORE 之后下电。

根据处理器特定数据表建议，需要将有效时钟源连接到 LFOSC0_XI 和 LFOSC0_XO（晶体）或 LFOSC0_XI（LVCMOS）。

6.1.1.4.1.1.1 使用仅 RTC 模式时的 RTC_PORz 延迟

在电源导轨释放 RTC_PORz 之前，必须确保 VDD_RTC 和 VDDS_RTC 电源导轨有效。由于没有特定的延迟要求、因此电源的 PG (电源正常) 输出可以连接到 RTC_PORz 输入。

6.1.1.4.1.1.2 仅 RTC 模式电源架构的 EVM 实施

这要求 VDD_RTC 在 VDD_CORE 之前斜升并在 VDD_CORE 之后斜降。用于生成 VDD_RTC 的分立式 LDO 的输入端使用了一个二极管。如果没有二极管，当出现不受控制的断电 (例如系统电源断电或与电路板断开连接) 时，VDD_RTC 电源导轨可能会与 VDD_CORE 同时下降或在其之前下降。

VDD_RTC 电源域消耗的功率不大，因此当通过二极管将 VDD_RTC 与输入电源隔离时，VDD_RTC LDO 上的输入电容器可以长时间维持 VDD_RTC 导轨的有效性。

6.1.1.4.1.2 仅 RTC 模式未使用

对于未使用任何低功耗模式 (仅 RTC 或 RTC + IO + DDR 自刷新) 的定制电路板设计：

VDD_RTC 连接到为 VDD_CORE 供电的同一 0.75V 电源。

VDDS_RTC 连接到为 VDDS_OSC0 供电的同一 1.8V 电源。

RTC_PORz 连接到为 PORz 供电的同一复位源。

6.1.1.4.1.2.1 不使用 RTC 模式时，使用 32kHz LFOSC0 时钟

当没有使用任何 RTC 低功耗模式时，无需连接低频振荡器。当不使用 LFOSC0 时，请遵循处理器特定数据表中的连接建议。

6.1.1.4.1.3 仅 RTC 低功耗模式检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引脚属性、信号说明和电气规范
3. 对 VDD_RTC 和 VDDS_RTC 使用常开型分立式 LDO 电源
4. 将 VDD_RTC 和 VDDS_RTC 的组合 PG 输出连接到 RTC_PORz
5. 设置连接到 RTC_PORz 的分立式 LDO PG 输出的转换速率
6. VDD_RTC 电源相对于 VDD_CORE 进行排序

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 对 VDD_RTC 和 VDDS_RTC 电源使用分立式 LDO
2. 根据处理器特定的数据表，电源输出在 ROC 范围内
3. VDD_RTC 电源在 VDD_CORE 之前斜升
4. VDD_RTC 和 VDDS_RTC 的电源转换率应遵循数据表规范
5. 将 VDD_RTC 和 VDDS_RTC 的分立式 LDO 的 PG 输出的连接在一起
6. 将分立式 LDO 的 PG 输出连接到 RTC_PORz 输入
7. 分立式 LDO PG 输出的转换率

其他

1. 请注意在分立式 LDO 输入端使用二极管对 VDD_RTC 电源进行排序

6.1.1.4.2 RTC + IO + DDR 自刷新低功耗模式

6.1.1.4.2.1 使用 RTC + IO + DDR 自刷新模式

请参阅处理器特定数据表中的电源序列图 (*RTC + IO + DDR 低功耗模式时序*)，以了解如何实现 RTC + IO + DDR 自刷新低功耗模式。

在实现基于 TI PMIC 的电源架构时，NVM 配置和 PMIC 为 LPDDR4 和 DDR4 生成的电源导轨会发生变化。

请参阅 EVM 原理图，了解使用 PMIC 和分立式逻辑为 LPDDR4 实现 RTC + IO + DDR 自刷新功能的电源架构。

6.1.1.4.2.2 未使用 RTC + IO + DDR 自刷新模式

对于未使用任何低功耗模式（仅 RTC 或 RTC + IO + DDR 自刷新）的定制电路板设计：

VDD_RTC 连接到为 VDD_CORE 供电的同一 0.75V 电源。

VDDS_RTC 连接到为 VDDS_OSC0 供电的同一 1.8V 电源。

RTC_PORz 连接到为 PORz 供电的同一复位源。

6.1.1.4.2.3 RTC + IO + DDR 自刷新低功耗模式检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引脚属性、信号说明和电气规范
3. 根据 LPDDR4 或 DDR4 存储器的使用情况选择 PMIC 版本
4. VDD_RTC 和 VDDS_RTC 电源的连接（根据 PMIC 版本，使用 PMIC 输出、分立式 LDO 或直流/直流转换器）
5. 将 PMIC 的电源正常输出（根据 PMIC 版本选择 RTC_PORz 的 IO）连接到处理器的 PORz 和 RTC_PORz
6. 将处理器 PMIC_LPM_EN0 连接到 PMIC STBY 输入

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 根据 PMIC 版本将分立式 LDO 用于 VDD_RTC 和 VDDS_RTC
2. 使用分立式 LDO 时，VDD_RTC 和 VDDS_RTC 电源转换率应遵循数据表要求
3. 将 VDD_RTC 和 VDDS_RTC 的分立式 LDO 的 PG 输出的连接在一起
4. 从 PMIC 输出或分立式 LDO PG 输出连接到 RTC_PORz 输入
5. 分立式 LDO PG 输出的转换率
6. 供电输出应符合处理器特定数据表中的 ROC
7. VDD_RTC 电源在 VDD_CORE 之前斜升

6.1.1.4.3 深度睡眠和待机

使用软件实现。如需获取可用的应用手册，请参阅处理器特定 TRM 或 TI.com 上的处理器特定 (AM62L) 产品页面。

6.1.1.5 其他信息

对于初始 PCB 原型构建，建议放置与内核电源及其他电源导轨一致的 0Ω 电阻（分流器）或跳线。 0Ω 电阻器（分流器）或跳线的放置有助于在电路板启动和调试期间隔离电源或测量电流。分流电阻器用于测量 EVM 中的电源轨电流。

验证添加 0Ω 电阻器配置对定制电路板性能的影响。

6.1.2 电源轨的电容器

6.1.2.1 AM62Lx

执行 PDN 分析，确保已为包括双电压 IO 组电源轨 IO 电源在内的所有电源轨提供了所需数量的去耦电容器和大容量电容器。

将去耦电容器放置在尽可能靠近电源引脚的位置。较大的大容量电容器可以放置在更远的位置。

使用低 ESL 电容器，并在安装它们时尽可能缩短布线以降低安装电感。更多信息，请参阅 [Sitara 处理器配电网络：实现与分析](#) 应用手册。

当未执行 PDN 分析或结果不可用时，EVM 中的大容量电容器和去耦电容器的容值可用作参考。要实现滤波（铁氧体）电源，请遵循处理器特定 EVM。

6.1.2.2 其他信息

6.1.2.2.1 AM62Lx

若未使用处理器外设（DDR 子系统（DDRSS0）、DSI0 和 USB2.0（USB0 和 USB1）），与这些外设相关的电源（内核、模拟）有特定的连接要求。有关更多信息，请参阅处理器特定数据表的引脚连接要求一节。可以优化电源滤波器（铁氧体）和电容器（大容量）。

6.1.2.3 电源轨电容器检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引脚属性、信号说明和电气规范
3. 使用低 ESL 电容器和用短布线连接的 3 端电容器来最大限度地减小电路板环路电感
4. 所用电容器的额定电压（常用准则是最坏情况下施加电压的两倍以上）

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 将用于所有电源轨的电容器与 EVM 原理图进行比较
2. 验证每个电源轨引脚都有一个去耦电容器，每个电源轨组都有一个大容量电容器

其他

1. 电源去耦已足够。所有处理器电源轨都使用大容量和高频去耦电容器。最需要引起注意的关键电源域是低电压、高电流域（VDD_CORE）
2. 作为起点，建议遵循经过验证的 EVM 去耦策略
3. 在不执行静态和动态 PDN 分析以验证是否满足 **Reff**、**Cap LL** 和阻抗目标的情况下，不建议采取偏差
4. 由于低电感封装和高性能，EVM 在某些情况下使用 3 端电容器。确保 EVM 原理图中的 3 端电容器未作为直列式或滤波器元件实现
5. 显示了电容器靠近相关引脚的连接，以便于放置和布线

6.1.3 处理器时钟

6.1.3.1 时钟输入

6.1.3.1.1 高频振荡器 (WKUP_OSC0_XI/WKUP_OSC0_XO)

为确保处理器运行，请选择晶体时钟源或 1.8V LVC MOS 方波数字时钟源。

连接到内部高频振荡器 (WKUP_HFOSC0) 的 25MHz 外部晶体是内部基准时钟 HFOSC0_CLKOUT 的时钟源。

将用于实现晶体振荡器电路的分立式元件尽可能靠近 WKUP_OSC0_XI 和 WKUP_OSC0_XO 引脚放置。对于晶体，在选择负载电容器时，请遵循处理器特定数据表的 *WKUP_OSC0* 晶体电路要求表。

使用 1.8V LVC MOS 方波数字时钟源时，应根据处理器特定数据表建议连接处理器 XO 引脚。

如需更多信息，请参阅常见问题解答：

[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM625SIP/AM625-Q1/AM620-Q1 定制电路板硬件设计 - 晶体选型相关问题](#)

[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM625SIP/AM625-Q1/AM620-Q1 定制电路板硬件设计 - 有关 MCU_OSC0 启动时间的问题](#)

常见问题解答是通用的，也可用于 AM62Lx 处理器系列。

备注

AM62x 的 MCU_OSC0 (高频振荡器) 对应于 AM62Lx 的 WKUP_OSC0。

备注

当前唯一支持的晶体频率是 25MHz。有关晶体参数的更多详细信息，请参阅处理器特定的数据表。

对于 LVC MOS 时钟的要求，请参阅处理器特定数据表的 *WKUP_OSC0 LVC MOS 数字时钟源* 和 *WKUP_OSC0 LVC MOS 数字时钟源要求* 章节。

6.1.3.1.2 低频振荡器 (LFOSC0_XI、LFOSC0_XO)

LFOSC0 的用例有限，是可选的。根据用例，选择 32.768kHz 晶体作为时钟源或 1.8V LVC MOS 方波数字时钟源。

如需更多信息，请参阅常见问题解答：[\[常见问题解答\] AM625 : LFOSC 在器件中的使用](#)。

常见问题解答是通用的，也可用于 AM62Lx 处理器系列。

用于实现振荡器电路的分立式元件尽可能靠近 LFOSC0_XI 和 LFOSC0_XO 引脚放置。对于晶振，所选的负载电容必须处于处理器特定数据表的 *LFOSC0 晶振电气特性* 表中建议的范围内。

如果未使用 LFOSC0_XI/LFOSC0_XO，建议将 XI 直接连接到 VSS，并使 XO 保持未连接状态。

有关连接未使用的 LFOSC0 的有关更多信息，请参阅处理器特定数据表的 *未使用 LFOSC0* 一节。

备注

AM62x 的 WKUP_LFOSC0 (低频 (32.768kHz) 振荡器) 对应于 AM62Lx 中的 LFOSC0。

6.1.3.1.3 EXT_REFCLK1 (主域的外部时钟输入)

EXT_REFCLK1 引脚通过布线连接至时钟多路复用器，作为计时器模块 (DMTIMER/WDT)、安全子系统中的 DMTIMER (SMS)、MCAN 和 CPTS (时间戳模块) 的可选输入时钟源。EXT_REFCLK1 适用于应用需要将特定时钟频率馈送到计时器模块的情况。一个应用示例是时间同步或由于时钟质量原因。

当 EXT_REFCLK1 用作时钟源时，根据外部时钟的可用性，建议下拉电阻。

6.1.3.1.4 其他信息

WKUP_OSC0_XI/WKUP_OSC0_XO 有特定的布线要求。请参阅处理器特定数据表的 *时钟布线指南* 部分。

6.1.3.1.5 时钟输入检查清单 - WKUP_OSC0

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引脚属性、信号说明和电气规范

3. 电气特性、时序参数和任何其他可用信息
4. 选择处理器时钟输入源、晶体或振荡器
5. 25MHz 是当前支持的时钟输入频率，有关支持的时钟输入频率，请参阅处理器特定数据表
6. 晶体负载电容器选型与数据表建议
7. WKUP_OSC0 的 PCB 电容包含在晶体负载电容值的计算中
8. 使用振荡器时，在振荡器电源引脚附近添加一个去耦电容器和大容量电容器

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 必须连接 25MHz WKUP_OSC0 时钟
2. 晶体电路连接 (WKUP_OSC0) 符合数据表中的建议
3. 无需串联或并联电阻即可直接连接晶体
4. 选择晶振负载和负载电容，包括大约 4pF 的电路板电容
5. 建议负载电容器是晶体负载的两倍，包括板电容
6. 使用外部振荡器时 XO 的连接，将 XO 接地

其他

1. 有关时钟布线指南，请参阅数据表的应用、实施和布局部分
2. 选择晶体和负载电容器，使负载电容器值可以为标准值
3. 将 25MHz 晶体直接连接到处理器 XI 和 XO 引脚，不建议串联或并联电阻。内部振荡器实现自动增益控制 (AGC) 以进行振幅控制
4. 仅使用 25MHz (当前仅支持的频率) 时钟源验证处理器。
5. 处理器特定数据表显示，WKUP_OSC0 不会在内核电压斜坡之前启动，因为在某些情况下，振荡器可能不会启动，直到 VDD_CORE 斜坡。大多数情况下，振荡器会在 VDDS_OSC0 斜升时启动，但并不是每次振荡器都会在 VDDS_OSC0 电压斜升时启动。数据表中的振荡器启动图显示了最大启动时间，其中包括基于 VDD_CORE 有效的延迟情况
6. 建议将 HFOSC0 寄存器保留为默认状态
7. 请参阅处理器特定数据表，以选择晶体电路元件

6.1.3.1.6 时钟输入检查清单 - LFOSC0

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引脚属性、信号说明和电气规范
3. 电气特性、时序参数和任何其他可用信息
4. 选择 LFOSC0 时钟输入源 - 晶振或振荡器
5. 32.768kHz 是支持的 LFOSC0 时钟输入频率。有关支持的时钟输入频率的更多信息，请参阅处理器特定数据表
6. 晶体负载选型与数据表建议
7. 负载电容器选型与数据表中的建议
8. LFOSC0 的用例有限，当不使用时钟选项时，提供将 XI 输入接地的配置

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下内容：

1. 时钟电路 (LFOSC0) 的连接符合数据表中的建议
2. 选择晶体负载和负载电容，负载电容是晶体负载的两倍

3. 使用外部振荡器 (XO 接地) 时的时钟电路连接
4. 未使用 LFOSC0 (XI 接地) 时的 XI 输入连接

其他

1. 晶体负载电容与 LFOSC0 寄存器。电路板设计人员更改的唯一 LFOSC0 寄存器位是 BP_C、PD_C 和 CTRLMMR_WKUP_LFXOSC_TRIM[18:16]，其中 PD_C 复位 (0) 以启用振荡器，并且仅设置 (1) BP_C 位以在使用 LVCMOS 时钟源时将振荡器置于旁路模式。CTRLMMR_WKUP_LFXOSC_TRIM[18:16] 位是根据施加到晶体上的实际电容负载设置的，由负载电容公式定义。
2. 有关预量产 PCB 和量产 PCB 期间的建议电路配置，请参阅处理器特定数据表

6.1.3.2 时钟输出

名为 CLKOUT0 和 WKUP_CLKOUT0 的处理器 IO (引脚) 可配置为时钟输出。时钟输出可用作附加器件 (外部外设) 。

6.1.3.2.1 时钟输出检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引脚属性、信号说明和电气规范
3. 连接 WKUP_CLKOUT0

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 将时钟输出连接到单个或多个负载。当连接到多个输入 (负载) 时，建议通过缓冲器连接每个输入
2. 在所连接器件时钟输入附近提供所需的拉电阻

其他

1. CLKOUT0 : EXT_REFCLK1 用作 CLKOUT0。始终点对点连接时钟信号，不使用任何分支。将 CLKOUT0 连接到多个时钟输入时，请使用缓冲器 (具有一个输入和多个输出或基于用例的单独缓冲器)

6.1.4 处理器复位

6.1.4.1 外部复位输入

PORz 是处理器的外部 WKUP 域冷复位输入。建议在电源斜升和振荡器启动期间将 PORz 拉至低电平。请遵循处理器特定数据表的上电时序图中建议的 PORz 时序。

对于 PORz (3.3V 容差、失效防护输入)，可以施加 3.3V 输入。输入阈值是 1.8V IO 电源电压 (VDDS_OSC0) 的函数。

慢速上升复位输入会导致内部处理器复位电路出现干扰。建议使用快速上升时间分立式推挽输出缓冲器作为 PORz 输入，并添加电容器 (22pF) 滤波器配置。

使用 PMIC 输出时，通过推挽输出型逻辑门或分立式缓冲器 (具有快速上升时间) 将输出连接到 PORz 输入，而不是连接缓慢上升开漏 PMIC 输出 (这可能干扰内部复位电路) 。

建议在 PORz 输入端连接滤波电容器。电容器值和安装取决于用例。验证电容值是否不会因慢速斜坡而导致 LVCMOS 输入违反压摆率要求或在内部产生干扰。

必须将有效输入连接到 PORz，否则可能会导致不可预测的随机行为。由于器件没有进行有效复位，因此内部电路可能处于随机 (未定义) 状态。

根据处理器特定数据表的引脚连接要求一节的说明，连接外部热复位输入 **RESETz**。热复位输入 (LVC MOS 输入) 有指定的输入压摆率要求。由于斜坡输入较慢，因此不建议直接在输入端连接电容器。建议使用基于施密特触发的去抖电路。有关实现去抖逻辑的信息，请参阅处理器特定 EVM 原理图。

6.1.4.2 复位状态输出

RESETSTATz 是主域热复位状态输出。当复位状态输出 **RESETSTATz** 用于驱动所连接器件的复位输入 (/reset) 时，建议为复位状态输出采用下拉电阻器，以便在上电与复位期间将所连接器件置为有效 (保持所连接器件处于复位状态) 。

备注

在所连接器件均不具有内部上拉电阻的使用情况下，外部下拉电阻器将保持所连接器复位输入在低电平。如果所连接器件具有内部上拉电阻，则复位信号会被拉至 $1/2 V_{DD}$ 电压。验证具体用例并在复位状态输出上添加下拉电阻。

RESETSTATz 可用于通过复位功能 (eMMC、OSPI 或 EPHY) 或 SD 卡电源开关来复位板载存储器或外设。

RESETSTATz 可用于在复位期间锁存硬件搭接配置，包括锁存以太网 PHY 搭接配置。

在不使用时将复位状态输出连接到测试点以进行测试或用于未来优化。可选择提供一个下拉电阻，并且此下拉电阻可以是 DNI。

6.1.4.3 其他信息

用于配置处理器引导模式的 **BOOTMODE00..15** 输入 (取决于所使用的引导模式引脚映射选项) 需要保持在已知状态，以便选择处理器特定 TRM 中定义的合适引导模式配置，直至在 **RESETSTATz** 的上升沿期间锁存引导模式配置。

6.1.4.4 处理器复位输入检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引脚属性、信号说明和电气规范
3. 电气特性、时序参数和任何其他可用信息
4. 仅当断电后电压低于 $0.3V$ 后，处理器才需要重新启动 (释放复位) (没有与该要求相关的时间或范围。在允许任何电源导轨斜升前，每个电源导轨必须降至 $0.3V$ 以下)
5. 当处理器电源斜升或斜降时，复位输出被置为有效 (低电平)
6. **PORz (POR)** 输入可耐受 $3.3V$ 电压且具有失效防护功能。阈值遵循 **VDDS_OSC0** IO 电平
7. 热复位 **RESETz (VDDSHV1)** 的 IO 电平与 IO 组的 IO 电源 ($1.8V$ 或 $3.3V$) 匹配
8. 复位输入遵循压摆率要求 (FS RESET、LVC MOS)
9. 漏极开路输出直接连接 (建议通过分立式推挽输出进行连接) 到复位输入时的转换率
10. 使用非 TI 电源架构时，应遵循复位要求，包括转换率和 **PORz** 保持时间

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 考虑了冷复位和热复位输入压摆率要求
2. 根据数据表要求提供所有电源斜升后，冷复位输入 (PORz) 取消置位保持时间 (所有电源斜升后的 PORz 输入延迟，最少 $9.5ms$)
3. 在复位输入的输入端提供滤波电容器 (添加 $22pF$ (占位值) 电容器作为滤波器选项和 DNI)
4. 未根据引脚连接要求使用时复位输入的连接
5. 通过去抖电路连接按钮热复位输入 (基于施密特触发缓冲器输出)

其他

1. PORz 输入指定了转换率要求。将 PMIC_POWERGOOD (漏极开路输出) 连接到 PORz 是唯一可用的选项时，请调整上拉电阻以优化上升时间 (< 200ns)
2. PORz 具有失效防护输入功能且可耐受 3.3V
3. 将分立式推挽输出缓冲器的输出 (快速上升时间) 连接到 PORz 输入，而不是缓慢上升开漏输出
4. 未连接有效的 PORz 会导致不可预测的随机行为，因为处理器未获得有效复位输入，且内部电路处于随机状态。慢速斜升复位输入会导致内部处理器复位电路出现干扰
5. LVC MOS 输入指定了压摆率要求。建议为连接到处理器热复位输入的慢速斜坡按钮 RC 使用基于施密特触发的去抖电路。建议在使用按钮或 RC 时使用基于施密特触发的去抖电路
6. 为靠近复位信号添加的手动复位输入提供外部 ESD 保护
7. 连接到外部复位输入时的失效防护运行情况。在电源斜坡之前施加外部输入会导致馈电并影响处理器性能

6.1.4.5 处理器复位状态输出检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引脚属性、信号说明和电气规范
3. 电气特性、时序参数和任何其他可用信息
4. RESETSTATZ 用作输入，以在复位期间锁存处理器引导模式配置或连接器件的启动配置
5. RESETSTATZ 输出用于复位当处理器进行任何类型的全局复位 (冷或热) 时需要复位的所连接器件。
6. 处理器复位状态输出和所连接器件复位输入之间的 IO 级兼容性 (可能会导致影响性能的残余电压)
7. 加载复位状态输出 (直接连接到输出的电容器 > 22pF (占位值))

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. RESETSTATZ 添加了下拉功能，可在电源斜升和复位期间将所连接器件保持在复位状态。
2. 将电容器直接连接到靠近所连接器件复位输入的复位输出端 (电容器 > 22pF)。执行仿真以使用值更高的电容器

其他

1. 当连接到载板或外部连接器时，为复位状态输出提供外部 ESD 保护

6.1.5 处理器引导模式的配置

该处理器系列支持两种不同的 BOOTMODE 引脚映射选项，如下所示：

1. 精简版引脚数目：仅使用其中四个自举引脚 BOOTMODE[15:12]
2. 完整版引脚数目：使用全部 16 个自举引脚 BOOTMODE[15:0]

精简版引脚数目的引导模式映射具有需要更少自举引脚的优势，这意味着需要的上拉或下拉元件也会减少。精简版引脚数目的引导模式会限制通过引脚选择的引导模式选项的数量。

但是，通过将新值编程到电子保险丝中，可以将 BOOTMODE 引脚映射 (精简版) 表中可选的两个引导模式选项自定义为任意一个完整的 16 位选项。电子保险丝值也使用 SECDED 纠错编码方案进行保护；22 个保险丝位用于对 16 位引导模式值进行编码。

为了达到减少所需上拉或下拉元件的目的，在 POR 期间会禁用引脚 BOOTMODE[11:0] 的输入缓冲器，除非 BOOTMODE[15:14] 为“00”。禁用这些缓冲器可以避免由于引脚数目选项减少，引脚上的悬空输入导致的功耗。

如果使用 DIP 开关配置引导，建议使用 470Ω (上拉电阻) 和 $47k\Omega$ (下拉电阻) 的电阻分压比来提高噪声性能。

当仅使用电阻配置引导模式时，标准电阻 (上拉和下拉的值相同) 值。例如，如果已经安装了上拉或下拉电阻，可以使用 $10k\Omega$ 或类似的电阻器。

建议将上拉或下拉电阻连接到标记为“保留”或未使用的引导模式引脚。

为实现调试、设计灵活性和未来增强功能，为所有具有配置功能的引导模式引脚添加上拉和下拉电阻配置。为每个引导模式引脚安装上拉或下拉电阻。不建议也不允许将引导模式引脚直接接地或连接到 IO 电源轨，因为 IO 具有备用配置，可能会被软件有意或无意地配置为输出。

引导模式输入引脚不具有失效防护功能，当通过外部输入或基板驱动引导模式配置时，需要考虑这一点。

根据应用要求，可以使用仅在复位 (PORz) 置为有效 (低电平) 时才驱动的缓冲器，来向处理器提供引导配置。

如果在正常运行期间将引导模式引脚配置为输出，则建议在缓冲器的输出端使用串联电阻 (约 $1k\Omega$)。如需实现的更多信息，请参阅处理器特定 EVM。

6.1.5.1 处理器引导模式输入隔离缓冲器用例和优化

在 EVM 中，引导模式引脚 BOOTMODE[15:12] 和 BOOTMODE[11:00] 通过 1 个 8 位和 2 个 4 位隔离缓冲器置为有效。当处理器锁存引导模式信号 (在 RESETSTATz 上升沿附近) 时，缓冲器可确保 SYSBOOT 拉电阻 (使用电阻配置的引导模式) 控制信号 IO 电平。由于引导模式信号用于处理器引导后的其他功能并连接到附加器件或外设。引导模式配置电阻器与连接的其他外设隔离，以便其他连接的外设不会与预期的引导模式配置 (IO 电平) 相冲突。

当 RESETSTATz 由处理器驱动为低电平时，才会启用缓冲器。RESETSTATz 置为有效后，缓冲器输出为高阻态，因此信号不会被引导模式电阻拉动或影响。

为了优化设计 (包括 BOM)，可以根据用例优化或删除这些缓冲器。可选择引导模式拉电阻值，使这些电阻不会影响附加器件的运行。

6.1.5.2 引导模式选择

如需配置所需处理器引导模式，请参阅处理器特定 TRM 的 初始化一章中的 ROM 代码引导模式表。

6.1.5.2.1 USB 引导模式注意事项

USB0 接口支持 USB DFU 引导模式。当 USB0 配置为器件固件升级 (DFU) 引导模式时。不建议将永久或开关式 $3.3V$ 电源直接连接到 USB0_VBUS 引脚。由于在没有电阻分压器的情况下连接电源会违反失效防护运行，因此不建议将永久电源 (等于分压器值) 连接到 USB0_VBUS 引脚。

根据处理器特定数据表中的建议，建议通过 USB 连接器连接的主机的 $5V$ 电源 (开关式) 通过电阻分压器连接到 USB0_VBUS 引脚。如果定制电路板设计中的 VBUS 电势不会 $> 5.5V$ ，且电源为板载电源，则可删除齐纳二极管，将两个电阻合并为一个 $20k\Omega$ 电阻，用于 USB VBUS 检测分压器、钳位电路。

6.1.5.3 引导模式实现方法

下面的常见问题解答介绍了使用和未使用引导模式缓冲器时的引导模式实现方法。

[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM644x/AM243x/AM62A/AM62P - 有缓冲器的引导模式实现](#)

[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM644x/AM243x/AM62A/AM62P - 无缓冲器的引导模式实现](#)

常见问题解答是通用的，也可用于 AM62Lx 处理器系列。

6.1.5.4 其他信息

当外部输入驱动引导模式配置时，建议在处理器 PORz (冷复位) 释放之前稳定引导模式配置输入。

6.1.5.5 引导模式的配置 (针对处理器) 检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引脚属性、信号说明和电气规范
3. 电气特性以及任何其他可用信息
4. 所有 **BOOTMODE** 引脚 (取决于使用的 **BOOTMODE** 引脚映射选项) 都具有外部上拉电阻器或一个用于驱动所需引导模式的电路。不建议或允许将任何引导模式输入保持未连接状态
5. 不建议将引导模式输入直接连接到电源或 **VSS**。不建议将多个引导模式输入短接在一起并连接一个公共电阻器。(电路板设计人员可能遇到固件配置问题，即用作输入的 **LVC MOS GPIO** 被错误地配置为输出，驱动逻辑高电平信号，而不是保持高阻抗状态)
6. 引导模式输入使用电阻分压器或根据 **EVM** 实现通过缓冲器连接到处理器
7. 使用 **DIP** 开关或电阻器的引导模式配置。当仅使用电阻器时，电阻分压器是可选的。可以使用上拉或下拉电阻
8. IO 兼容性 (以 **VDDSHV0** 为基准的 1.8V 或 3.3V，引导模式输入不具有失效防护)
9. 在冷复位状态输出被拉高之前，引导模式输入保持稳定
10. 引导模式引脚通过 0Ω 连接到替代功能，用于隔离或测试

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 不将 **DIP** 开关用于引导模式配置时，请使用常见的电阻值 ($10k\Omega$ 或类似值)
2. 使用 **DIP** 开关来配置引导时，请使用 470Ω 和 $47k\Omega$ 电阻器
3. 当使用缓冲器实现引导模式或由外部控制信号驱动时，串联电阻器 $1k\Omega$ 用于缓冲器的输出
4. **PLL** 时钟、主引导和次级引导的引导模式配置

其他

1. 对于早期的设计，建议 **PD** 根据所需的引导模式，将所有引导模式引脚引出至一个具有爆音和无爆音选项的可选 **PU/PD** 对。有关完整引导模式定义，请参阅处理器特定 **TRM**。
2. 在上电复位释放时锁存引导值。如果在运行期间重新配置引导模式引脚用于另外的功能，则必须释放引导模式引脚或将其设置回适当的配置，以便在器件进入上电复位状态时选择引导模式。如果信号由外部外设驱动，引导模式配置尤其值得关注。
3. 添加外部 **ESD** 保护，以防在不受控制的环境中配置引导模式开关。
4. 引导模式输入不具有失效防护功能。在处理器 **IO** 电源斜升之前，不得施加任何输入。在电源斜升之前施加外部输入会导致馈电并影响定制电路板功能。
5. 引导模式缓冲器是可选的，在 **EVM** 上提供，用于测试自动化
6. 使用缓冲器或逻辑门配置引导模式时，请验证所用器件是否具有 **OE** (输出使能特性)。

6.2 使用 JTAG 和 EMU 进行电路板调试

6.2.1 使用 JTAG 和 EMU

建议根据处理器特定数据表的引脚连接要求一节的说明连接 **JTAG** (**TDI**、**TCK**、**TMS** 和 **TRSTn**) 和 **EMU** (**EMU0** 和 **EMU1**) 信号。

或者，在 **TDO** (靠近处理器) 信号上连接串联电阻 (22Ω)，以匹配缓冲器阻抗。当信号连接到外部连接器时，建议为所有 **JTAG** 和 **EMU** 信号添加外部 **ESD** 保护。**EMU 0/1** 信号支持冷复位 (**PORz**) 后的引导顺序调试。

TDO 的上拉为可选项，取决于所使用的调试器。

请参阅处理器特定 **TRM** 的片上调试一章。

欲了解更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625 / AM623 / AM625SIP / AM625-Q1 / AM620-Q1 / AM62A7 / AM62A3 / AM62P / AM62P-Q1 / AM6442 / AM2432 定制电路板硬件设计 - JTAG

[常见问题解答] AM625 : JTAG 下拉/上拉

常见问题解答是通用的，也可用于 AM62Lx 处理器系列。

6.2.2 未使用 JTAG 和 EMU

如需连接 JTAG 和 EMU 信号，请参阅处理器特定数据表的引脚连接要求一节。

在定制电路板设计期间，为支持早期原型调试，TI 建议至少配置一个连接到测试点的最小 JTAG 端口（包括 EMU0/1）或配置一个接头封装。JTAG 元件在电路板的量产版本中可以是 DNI 状态。此外，还需提供相应配置，以便根据引脚连接要求一节添加建议拉电阻以及外部 ESD 保护。

6.2.3 其他信息

当 JTAG 接口连接到不止一个附加器件时，建议对时钟和信号进行缓冲。即使对于单个器件的实现，也建议进行时钟缓冲。有关实现的信息，请参阅处理器特定 EVM。

如果使用跟踪操作，请将 TRC_DATA_n 信号直接连接到仿真连接器。所有 TRC_DATA_n 信号都与其他信号进行引脚多路复用。使用跟踪功能或 GPMC 接口。TRC_DATA_n 信号的短连接和偏差匹配连接（电路板引线）用于跟踪功能。跟踪信号基于 VDDSHV0，并且可能具有与其他 JTAG 信号不同的电源电压。更多有关 TRC/EMU 设计和布局的建议，请参阅 [仿真和跟踪接头技术参考手册](#)。[XDS 目标连接指南](#) 中提供了摘要。

如果使用边界扫描，请将 EMU0 和 EMU1 引脚直接连接到 JTAG 连接器。

要确保 JTAG 接口的正确实施，请参阅 [仿真和跟踪接头技术参考手册](#) 和 [XDS 目标连接指南](#)。

6.2.4 使用 JTAG 和 EMU 检查清单进行电路板调试

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引脚属性、信号说明和电气规范
3. 电气特性、时序参数和任何其他可用信息
4. JTAG 信号 IO 兼容性（IO 电源以 VDDS0 为基准）
5. 所需上拉电阻靠近处理器 JTAG 引脚的连接符合引脚连接要求

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 将电源电压连接到 JTAG 连接器（包括滤波电容器）（连接到 VDDS0 的电压源）
2. 上拉和下拉值（使用 47kΩ 或 10kΩ）

其他

1. TI 建议所有定制电路板设计至少包含与测试点或接头的最低 JTAG 端口连接，以实现早期原型调试。最低连接为 TCK、TMS、TDI、TDO 和 TRST_n。如果需要，请在电路板的量产版本中删除 JTAG 布线和元件封装（TRST_n 上的下拉电阻以及 TMS 和 TCK 上的上拉电阻除外）
2. 建议配置 EMU0 和 EMU1 信号
3. 如果需要跟踪操作，必须将 TRC_DATA_n 信号连接到仿真连接器。所有 TRC_DATA_n 信号都与其他信号进行引脚多路复用。如果实现跟踪连接，请勿在引脚上使用其他多路复用接口。为 TRC_DATA_n 信号使用尽可能短的布线。跟踪信号位于单独的电源域上，并且可能具有与其他 JTAG 信号不同的电压
4. 提供外部 ESD 保护。使用 JTAG 接口时组装

- 验证连接到外部信号时的失效防护运行情况。在电源斜升之前施加外部输入会导致馈电并影响定制电路板功能

7 处理器外设

7.1 IO 组的 IO 电源的电源连接

该处理器支持固定 1.8V IO 和 1.8V/3.3V 固定或动态切换 IO。验证与所连接器件的 IO 电平兼容性。建议使用同一电源为 IO 组的处理器 IO 电源和连接的器件 IO 电源供电。电路板设计人员必须确保设计中施加的电位不超过绝对最大额定值表中定义的值。

7.1.1 用于 IO 组的双电压 IO 电源和固定电压电源

每个双电压 IO 组的 IO 电源 (VDDSHVx [x = 0-4]) 为一组固定的 IO (外设) 供电。将 3.3V/1.8V 电源电压连接到 IO 组的每个双电压 IO 电源 (VDDSHV0、VDDSHV1)；或将动态切换的 3.3V/1.8V 电源电压连接到 IO 组的每个双电压 IO 电源 (VDDSHV2、VDDSHV3、VDDSHV4)。

VDDSHV2、VDDSHV3 和 VDDSHV4 旨在支持在不依赖于其他电源导轨的情况下完成上电、下电或动态电压切换。动态电压切换功能是支持 UHS-I SD 卡所必需的。

为处理器 IO 实现了 SDIO 或 LVC MOS 类型 IO 缓冲器。IO 电源要求取决于 IO 缓冲器类型。

根据所选的存储器类型 (DDR4 或 LPDDR4)，DDR PHY 的 IO 电源应按照 ROC 进行连接。

7.1.2 固定 1.8V

每个 IO 组的固定电压 IO 电源 (VDDS0、VDDS1、VDDS_WKUP) 为一组固定的 IO (外设) 供电。固定的 1.8V 电源电压连接到 IO 组 (VDDS0、VDDS1 和 VDDS_WKUP) 的固定电压 IO 电源。

IO 组的固定电压 IO 电源通过 1P8-LVC MOS IO 缓冲器实现。

设计电源架构，确保电源电压不会瞬间或持续超出 ROC。

7.1.3 IO 组的 IO 电源的电源连接检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

- 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
- 引脚连接要求、引脚属性和信号说明
- 电气特性中引用的标准包括建议的运行条件和任何其他可用信息
- 实现的 IO 缓冲器类型和允许的电源配置 (LVC MOS 固定 (1.8V 或 1.8V/3.3V) 或 SDIO 动态电压开关)
- 将有效电源连接到所有 IO 组的 IO 电源 (VDDSHVx、VDDSx 或 VDDS_WKUP)
- IO 电源时序控制
- 基于所选存储器连接处理器 DDRSS PHY IO 电源

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

- 以接口信号为基准的所连接器件 IO 电源和 IO 组的 IO 电源连接到同一电源
- 上拉电阻连接到与处理器 VDDSHVx、VDDSx 或 VDDS_WKUP 和所连接器件相连的同一电源导轨
- 不建议将连接到 PMIC 输入端的 3.3V 电源直接连接到 IO 组 VDDSHVx 的处理器 IO 电源，因为如果 PMIC 未启动并生成其他处理器电源导轨，IO 电源将在未定义的时间内可用

其他

- 请注意基于使用的 IO 组 IO 电源电压电平的电源时序要求
- IO 组的特定 IO 电源 (VDDSHV2、VDDSHV3 和 VDDSHV4) 支持动态电压切换
- 不允许对以 LVC MOS IO 缓冲器为基准的 IO 组的 IO 电源进行动态电压变化 (VDDSHV0 和 VDDSHV1)

7.2 存储器接口 (DDRSS (DDR4/LPDDR4)、MMCSD (eMMC/SD/SDIO)、OSPI/QSPI 和 GPMC)

7.2.1 DDR 子系统 (DDRSS)

请参阅以下常见问题解答：

[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM62A/AM62P 定制电路板硬件设计的设计建议/常见错误 - DDR4/LPDDR4 存储器接口](#)

有关支持的 DDR4 和 LPDDR4 存储器大小，请参阅处理器特定的数据表。与其他处理器系列相比，支持的存储器大小和 DDRSS 接口引脚排列可能会有所不同。建议在设计定制电路板原理图时查看支持的存储器大小和建议的连接。

7.2.1.1 DDR4 SDRAM (双倍数据速率 4 同步动态随机存取存储器)

7.2.1.1.1 AM62Lx

有关实现指南和布线拓扑，请参阅 [AM62x DDR 电路板设计和布局布线指南](#)。

7.2.1.1.1.1 存储器接口配置

允许的存储器配置为 1×16 位或 2×8 位。

1×8 位存储器配置不是有效配置。

根据所选的存储器大小验证 DDRSS 存储库组 (DDR0_BG0、DDR0_BG1) 的连接。

根据存储器选择 (单列) 验证 DDRSS 芯片选择 (DDR0_CS0_n) 的连接。

7.2.1.1.1.2 布线拓扑和端接

当使用一个存储器 (DDR4) 器件 (1×16 位) 时，可考虑点对点拓扑。

点对点拓扑实现总结：

- 地址和控制信号的外部 VTT 端接是可选项 (非必需)。
- 对于差分时钟 DDR0_CK0, DDR0_CK0_n，建议采用如下配置：使用交流差分端接 2 个 R 串联 (值 = Zo - 单端阻抗)，并在两个电阻中间连接一个滤波电容器 $0.01 \mu F$ (或存储器制造商推荐的值)，同时连接到 DDR PHY 的 IO 电源 VDDS_DDR。
- VREFCA (VDDS_DDR/2) 是用于存储器 (DDR4) 器件的控制、命令和地址输入的基准电压。VREFCA 可以使用电阻分压器 (连接到 VDDS_DDR 和 VSS 的 2 个电阻 (建议电阻值为 $1k\Omega$, 1%)) 以及与两个电阻并联的滤波电容器 (建议值为 $0.1 \mu F$) 从 VDDS_DDR 导出。VREFCA 引脚连接额外的去耦电容器 (靠近存储器 (DDR4) 器件)。

或者，可以使用一个存储器 (DDR4) 器件的地址和控制信号上的 VTT 端接，以及用于生成 VTT 电源的灌电流或拉电流 DDR 端接稳压器。

使用两个存储器 (DDR4) 器件 (2×8 位) 时，建议采用飞越式拓扑。

飞越式拓扑实现总结：

- 建议为地址、控制和时钟信号使用外部端接 (VTT)。
- 建议使用灌电流或拉电流 DDR 端接稳压器生成 VTT 电源。
- 灌电流或拉电流 DDR 端接稳压器生成基准电压 VREFCA (VDDS_DDR/2)。
- 为基准电压添加去耦电容器。

7.2.1.1.1.3 用于控制和校准的电阻

为 DDR0_RESET0_n (DDR_RESET#)、DDR0_CKE0 (DDR_CKE，可选) 连接下拉电阻并为 DDR0_ALERT_n (DDR_ALERTn) 连接上拉电阻 (靠近存储器 (DDR4) 器件)。为 DDR4 器件测试使能 (TEN) 提供下拉电阻 (靠近存储器 (DDR4) 器件)。有关实现和电阻值，请参阅处理器特定 EVM。

为 DDR0_CAL0 (靠近处理器校准引脚) 与 ZQn (n=0-1，靠近内存 (DDR4) 器件) 连接推荐电阻。

7.2.1.1.4 电源轨的电容器

验证是否为处理器 DDR 电源轨和存储器 (DDR4) 器件电源轨提供了足够的大容量电容器和去耦电容器。

如果没有可用的建议，请遵循处理器特定 EVM 实现。

7.2.1.1.5 数据位或字节交换

如果在定制电路板设计期间需要进行位交换，则允许在数据字节内进行位交换，以及在某些限制条件下交换 0/1 字节。请勿将 DM 和 DQS 位与任何其他信号交换。不允许对地址位或控制位进行位交换。

有关更多信息，请参阅 [AM62x DDR 电路板设计和布局布线指南](#) 的 **DDR4 电路板设计和布局布线指南**一章中的位交换一节。

根据位交换的变化更新原理图，以供今后参考或重复使用。

7.2.1.1.6 VTT 端接原理图参考

使用两个存储器 (DDR4) 器件 (2×8 位) 时，每个器件将连接到各自的数据字节。地址信号或控制信号以飞越式拓扑连接，并采用 VTT 端接。

请参阅 [AM64x Sitara 处理器评估模块](#)，了解如何实现 VTT 端接。

建议执行板级仿真以确保信号完整性。

7.2.1.1.7 DDR4 实现检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引脚属性、信号说明和电气规范
3. 电气特性、时序参数和任何其他可用信息
4. 地址、时钟、控制和数据信号连接，请遵循处理器特定的 DDR 设计指南
5. 基于连接的存储器器件数量的路由拓扑（数据总线拓扑始终为点对点拓扑）。允许的配置为 1×16 (点对点) 和 2×8 (菊花链)
6. 根据所选的存储器大小连接信号 (CS0、BG0-1)
7. 使用 2 个电阻器和滤波电容器的差分时钟端接，用于点对点和菊花链存储器接口配置
8. DDR0_CAL0、DDRSS IO 焊盘校准电阻 (240Ω 、1%) 连接到 VSS
9. 用于 DDR 基准时生成 DDR_VREFCA 的电阻分压器配置 ($1k\Omega$ 、1%)。将去耦电容器 $0.1\mu F$ 放置在电阻分压器上并靠近存储器引脚的位置
10. 使用 2 个存储器器件时地址和控制信号的端接 (VTT) (对于点对点连接是可选的)
11. VTT 电阻器和电容器 (每 2 个 VTT 电阻器 1 个) 数量和值 - 遵循 EVM 和设计指南
12. 使用 2 个存储器器件时的 VTT 端接 LDO 实现和配置
13. ZQ0-1、存储器器件 IO 校准电阻 (240Ω 、1%) 连接到 VSS
14. 连接 ALERT ($10k\Omega$ 上拉) 和 TEN ($1k\Omega$ 下拉)
15. 将 ODT 从 DDRSS 连接到存储器器件 - 外部拉电阻是可选的
16. 将处理器 DDRSS RESETn 信号直接连接到 DDR_RESETn 存储器复位输入。要在上电初始化期间将信号设置为低电平，请添加一个下拉电阻 ($10k\Omega$) 并将其放置在存储器器件复位引脚附近
17. 根据引脚连接要求连接未使用的 DDRSS 接口信号
18. 有关数据组信号交换的 DDR 设计指南
19. 连接存储器扩展所需的 DDRSS 信号

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 根据 EVM 原理图比较使用的大容量电容器和去耦电容器以及值
2. 用于校准电阻的值和容差

3. VTT 电阻器和电容器的值
4. DDR 基准分压器值和容差
5. 复位下拉值和 ALERT 连接，TEN 下拉电阻
6. 所选存储器符合 JEDEC 标准
7. 电源轨连接遵循 ROC

其他

1. 请参阅 TMDS64EVM，了解如何为 DDR4 地址和控制信号实现 VTT 端接，以及如何生成 VTT 电源实现 LDO
2. 在原理图上添加布局注释（对于 DDR 布线，应遵循建议的指南）

7.2.1.2 LPDDR4 SDRAM (低功耗双倍数据速率 4 同步动态随机存取存储器)

7.2.1.2.1 AM62Lx

有关实现指南和布线拓扑，请参阅 [AM62x DDR 电路板设计和布局布线指南](#)。

7.2.1.2.1.1 存储器接口配置

允许的存储器配置为 1×16 位。

7.2.1.2.1.2 布线拓扑和端接

时钟 (CK)、地址、控制 (ADDR_CTRL) 和数据信号遵循点对点拓扑。

VTT 端接不适用于 LPDDR4。地址和控制信号所需的端接由内部（片上）处理。

7.2.1.2.1.3 用于控制和校准的电阻

为 DDR0_RESET0_n (LPDDR4_RESET_N) 连接下拉电阻（靠近存储器 (LPDDR4) 器件）。有关实现和电阻值，请参阅处理器特定 EVM。

为 DDR0_CAL0 (靠近处理器校准引脚)、ODT_CA_A (靠近内存 (LPDDR4) 器件) 以及 ZQ (靠近内存 (LPDDR4) 器件) 连接推荐电阻器。

7.2.1.2.1.4 电源轨的电容器

验证是否为处理器 DDR 电源轨和存储器 (LPDDR4) 器件电源轨提供了足够的大容量电容器和去耦电容器。

如果没有可用的建议，请遵循处理器特定 EVM 实现。

7.2.1.2.1.5 数据位或字节交换

在定制电路板设计过程中，如果需要位交换，则允许在数据字节内进行位交换，以及交换 0/1 字节。不允许地址位或控制位交换。

建议根据位交换的变化更新原理图，以供今后参考或重复使用。

7.2.1.2.1.6 LPDDR4 实现检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引脚属性、信号说明和电气规范
3. 电气特性、时序参数和任何其他可用信息
4. 地址、时钟、控制和数据信号连接 - 请遵循处理器特定的 DDR 设计指南
5. DDR0_CAL0 和 DDRSS IO 焊盘校准电阻 (240Ω 、1%) 连接到 VSS
6. ZQ0-1、存储器器件 IO 校准电阻 (240Ω 、1%) 连接到 VDD_LPDDR4
7. 通过电阻器 ($2.2k\Omega$ 或类似器件，与 DDRSS 无连接) 上拉的存储器器件片上端接 (ODT)
8. 连接片选 CSn0

9. 对于 LPDDR4 , x16 是支持的数据总线宽度
10. 将 DDRSS RESETn 信号直接连接到 LPDDR4_RESET_N 存储器复位输入。要在上电初始化期间将信号设置为低电平，请添加一个下拉电阻 ($10k\Omega$) 并将其放置在存储器器件复位引脚附近
11. 将 DDRSS 连接到 16 位存储器器件 - 请参阅 DDR 设计指南
12. 根据 DDR 设计指南端接未使用的 DDRSS 接口信号

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 根据 EVM 原理图比较使用的大容量电容器和去耦电容器以及值
2. 用于校准电阻的值和容差
3. 复位下拉值和连接 ODT 上拉
4. 所选存储器符合 JEDEC 标准
5. 电源轨连接遵循 ROC

其他

1. 在原理图上添加布局注释 (对于 DDR 布线，应遵循建议的指南)

7.2.2 多媒体卡/安全数字 (MMCSD)

该处理器支持三个 MMCSD 实例。MMCSD 主机控制器提供了一个连接 1 个 eMMC (8 位) 实例和 2 个 SD/SDIO (4 位) 实例的接口。

7.2.2.1 MMC0 - eMMC (嵌入式多媒体卡) 接口

请参阅以下常见问题解答：

[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM62A/AM62P 定制电路板硬件设计的设计建议/常见错误 - eMMC 存储器接口](#)

[\[常见问题解答\] AM62A7 : MMC0 拉电阻器要求](#)

常见问题解答是通用的，也可用于 AM62Lx 处理器系列。

7.2.2.1.1 AM62Lx

有关更多信息，请参阅处理器特定数据表的 **MMC0 - eMMC/SD/SDIO 接口** 一节。

7.2.2.1.1.1 IO 电源

用于 MMC0 接口的处理器 IO 由 VDDSHV2 电源导轨 (MMC0 IO 组的 IO 电源) 供电。

VDDSHV2 旨在支持不依赖于其他电源导轨的上电、下电或动态电压切换。

建议将所连接器件的 VDDSHV2 和 IO 电源轨连接到同一电源。

连接器件的 VDD (内核电压) 可由独立电源供电。

7.2.2.1.1.2 eMMC (连接器件) 复位

建议使用双输入“与运算”逻辑来实现所连接器件的复位。处理器通用输入/输出 (GPIO) 连接到与门输入，在输入端附近提供上拉电阻 (以支持引导) 和 0Ω 配置，以隔离 GPIO 用于测试或调试。与门的另一个输入是主域热复位状态输出 (RESETSTATz) 信号。

如果不使用“与运算”逻辑且使用处理器主域热复位状态输出 (RESETSTATz) 来复位所连接器件，请将所连接器件的 IO 电压电平与 RESETSTATz IO 电压电平匹配。建议使用电平转换器来匹配 IO 电压电平。

7.2.2.1.1.3 信号连接

与所连接器件进行以下连接

- 在尽可能靠近处理器时钟输出引脚的位置为 **MMC0_CLK** 信号添加一个 0Ω 串联电阻器，以最大限度地减少反射（在读取事务时使用 **MMC0_CLK** 信号/在内部环回信号，并且需要使用串联电阻器最大限度地减少可能导致错误时钟转换的信号反射。最初使用 0Ω 的串联电阻值，并根据需要调整该值以匹配 PCB 布线阻抗）
 - 为 **MMC0_CLK** 信号连接外部下拉电阻（靠近 eMMC 器件时钟输入引脚）。（为了防止 eMMC 器件输入悬空，直到软件初始化与 **MMC0** 关联的主机控制器和处理器 IO，并且时钟以低电平逻辑停止或暂停，并且下拉选项与逻辑状态一致）
- 将数据线 **MMC0_DAT0** 的外部上拉电阻连接到靠近 eMMC 器件的位置（以防止 eMMC 器件输入悬空，直到软件初始化主机控制器和处理器 IO）。
 - 为外部上拉电阻提供可选的 DAT1-7。（eMMC 器件（只要 eMMC 器件符合 eMMC 标准）为数据信号 **MMC0_DAT1-7** 启用了上拉电阻。进入 4 位模式时，eMMC 器件会关断 **MMC0_DAT1-3** 上拉电阻，进入 8 位模式时则关断 **MMC0_DAT1-7** 上拉电阻。在更改软件模式时，eMMC 主机软件会打开相应的 DAT 上拉电阻）
- 为 **MMC0_CMD** 信号连接上拉电阻（ $10k\Omega$ 或 $47k\Omega$ ），为 DS 信号连接下拉电阻（可选）（靠近 eMMC 器件）

7.2.2.1.4 电源轨的电容器

验证是否为 VDDSHV2 电源导轨和连接器件（内核和 IO 电源）提供了要求的大容量电容器和去耦电容器。

如果没有可用的建议，请遵循处理器特定 EVM 实现。

7.2.2.1.5 MMC0 (eMMC) 检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接。
2. 引脚属性、信号说明和电气规范。
3. 电气特性、时序参数和任何其他可用信息。
4. **MMC0** 接口符合 JEDEC eMMC 电气标准 v5.1 (JESD84-B51)
5. AM62Lx 处理器系列实现了软 PHY。建议在外部实现 **DAT0**、时钟和控制信号所需的拉电阻。
6. 在 **MMC0_CLK** 上包含一个串联电阻器 (0Ω)，该电阻器应尽可能靠近处理器时钟输出引脚放置以最大限度地减少反射。**MMC0_CLK** 在读取事务时在内部环回，并且串联电阻器会最大限度地减少可能的信号反射，这会导致时钟转换错误。最初使用 0Ω 并根据需要进行调整，以匹配 PCB 布线阻抗。
7. 为 **DAT0** 和 **CMD** 信号添加上拉电阻（ $10k\Omega$ 或 $47k\Omega$ ）。将上拉电阻连接到 IO 组 VDDSHV2 的 IO 电源（**MMC0** IO 组的 IO 电源）。对于 **DAT1-7** eMMC 器件应在复位期间启用上拉电阻。eMMC 主机/PHY 会禁用 eMMC 器件上拉电阻，并启用处理器内部上拉电阻。为外部上拉电阻器提供的配置是可选的，或者删除上拉电阻器。
8. 建议 VDDSHV2 (1.8V 或 3.3V) 和连接的 eMMC 器件 IO 电源使用同一电源供电。
9. 为靠近时钟输入引脚的 eMMC 连接器件添加下拉电阻 ($10k\Omega$)。
10. 要实现 eMMC 器件复位，请在存储器用于引导时使用双输入“与运算”逻辑。连接 **RESETSTATz** 作为一个输入，并将处理器 IO 作为另一个输入。在与门输入引脚附近为处理器 IO 输入添加上拉电阻，在处理器 IO 输出附近添加隔离电阻。或者，**RESETSTATz** 用作复位源。当 **RESETSTATz** 用作复位源时，请验证 IO 电压电平与 eMMC IO 电源是否兼容。根据需要使用电平转换器。
11. 当未配置 eMMC 引导时，连接到 eMMC 的器件复位可由处理器 IO 控制。建议在电路板电源复位期间下拉 eMMC 存储器器件的复位。
12. 根据需要为连接的存储器器件添加额外的去耦电容器。请参阅 EVM 原理图。

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 为处理器和所连接器件电源轨提供了所需的大容量电容器和去耦电容器。与 EVM 原理图进行比较
2. 数据、命令和时钟信号的拉电阻值。与相关的 EVM 原理图进行比较

3. 在靠近处理器时钟输出引脚的时钟输出信号上的串联电阻器的电阻值与位置
4. 复位逻辑的实现，包括 IO 电平兼容性。当直接连接 **RESETSTATz** 或处理器 IO 以控制复位时，不建议在 eMMC 所连接器件的复位输入端添加电容器。不建议使用独立的复位连接来复位 eMMC 存储器器件
5. 电源轨连接遵循 ROC

其他

1. 在 **CLK** 上连接一个外部下拉电阻、在 **CMD** 和 **DAT0** 上连接一个外部上拉电阻，以防止 eMMC 器件输入悬空，直到软件初始化与 **MMC0** 关联的主机控制器和处理器 IO。eMMC 标准要求 eMMC 器件在 **DAT1-7** 信号的复位期间启用内部上拉电阻，**DAT1-7** 信号不需要外部上拉电阻。当总线宽度从 1 位模式增加到 4 位或 8 位模式时，软件会开启相应的内部 DAT 上拉电阻。需要外部拉电阻，因为与 **MMC0** 关联的 IO 是通过标准双电压 LVC MOS IO 单元实现的，并且能够将额外的信号功能多路复用到相应的器件引脚。由于连接到 **MMC0** 引脚的接口未知，因此在复位期间禁用 **MMC0** IO 缓冲器。
2. 验证 eMMC 器件 (eMMC 非易失性配置空间) 中是否启用了 **eMMC_RSTn** 复位输入，以便复位逻辑正常工作。利用 **GPIO** 复位选项，软件可以在外设变得无响应的情况下复位所连接器件 (eMMC、OSPI、SD 卡或 EPHY)，而无需复位整个处理器。替换 **GPIO** 选项并使用复位输出 (热或冷)。如果外设无响应，软件会强制进行热复位。但是，使用热复位会复位整个器件，而不是尝试恢复特定外设而不复位整个器件。当使用 **RESETSTATz** 复位所连接器件时，请验证所连接器件的 IO 电压电平是否与 **RESETSTATz** IO 电压电平匹配。建议使用电平转换器来匹配 IO 电压电平。或者，使用电阻分压器并选择理想阻抗值。eMMC 复位输入的缓慢上升或下降时间会导致延迟过大。低复位输入会导致处理器在正常运行期间提供过多的稳态电流。
3. “与运算”逻辑还会执行 IO 电平转换。在优化复位“与运算”逻辑之前，请验证复位 IO 电平兼容性。IO 电平不匹配会导致电源泄漏并影响处理器运行
4. 为 eMMC、SD 卡或其他外设选择下拉电阻，因为在某些情况下，时钟在低逻辑状态下停止或暂停，并且下拉电阻选项与逻辑状态一致。

7.2.2.1.2 有关 eMMC PHY 的额外信息

请参阅处理器特定数据表的信号说明、MMC、MAIN 域一节中的注释。

备注

请注意不同处理器系列上使用的 eMMC 控制器和 eMMC PHY IP 可能的实现方式差异。请注意接口，包括迁移到其他处理器系列时建议的端接。

建议查看处理器特定数据表、TRM，并遵循针对处理器和连接器件的连接建议。

可以根据需要遵循处理器特定 EVM 实现。

7.2.2.1.3 MMC0 - SD (安全数字) 卡接口

MMC0 接口上没有 CD (卡检测) 和 WP (写保护) 引脚。MMC0 可用于连接固定的 SDIO 器件 (板载)。有关更多信息，请参阅处理器特定数据表的 **MMC0 - eMMC/SD/SDIO 接口** 一节。

7.2.2.2 MMC1/MMC2 - SD (安全数字) 卡接口

有关更多信息，请参阅处理器特定数据表的 **MMC1/MMC2 - SD/SDIO 接口** 一节。

7.2.2.2.1 IO 电源

处理器 MMC1 (CMD、CLK 和数据) 接口 IO 由 VDDSHV3 电源导轨 (MMC1 IO 组的 IO 电源) 供电，MMC2 (CMD、CLK 和数据) 接口 IO 由 VDDSHV4 电源导轨 (MMC2 IO 组的 IO 电源) 供电。

VDDSHV3 和 VDDSHV4 旨在支持不依赖于其他电源导轨的上电、下电或动态电压切换，允许工作电压随着传输速度的增加从 3.3V 更改为 1.8V。

VDDSHV3 和 VDDSHV4 电源必须初始为 3.3V，并允许在软件准备好更改 IO 电源电压时更改为 1.8V。

为了生成动态变化的 3.3V 或 1.8V 电源，AM62Lx 支持集成 LDO SDIO_LDO (处理器内部的 LDO，可优化设计)。当 MMC1 配置为 SD 卡接口时，可以使用集成的 SDIO_LDO 为 VDDSHV3 电源供电。下文复位部分所述

的 SD 卡供电控制电源开关的输出作为输入连接到 SDIO_LDO (VDDA_3P3_SDIO)。SDIO_LDO 的输出在复位期间为 3.3V，当软件准备好更改电源电压时，允许将该输出更改为 1.8V。SDIO_LDO 的输出由 V1P8_SIGNAL_ENA 位控制。

确保将建议的电容器连接到 CAP_VDDSHV_MMC 引脚。

处理器 MMC1 SD 卡检测 (CD) 和写保护 (WP) 信号由 VDDSHV1 电源导轨 (GENERAL1 IO 组的 IO 电源) 供电。建议将 MMC1_SDCD、MMC1_SDWP 的上拉电阻从 SD 卡连接到同一电源轨 VDDSHV1。

插入 SD 卡时，处理器的 SD 卡检测 (CD) 输入直接连接到接地端。建议使用一个 ($100\ \Omega$) 串联电阻器限制电流，以防因编程错误导致 IO 被配置为输出。

处理器 MMC2 SD 卡检测 (CD) 和写保护 (WP) 信号由 VDDSHV4 电源导轨或 VDDSHV1 电源导轨供电。

备注

未使用 SDIO_LDO 为 MMC1 或 MMC2 IO 供电时，请参阅处理器特定数据表的 引脚连接要求一节，了解如何连接 VDDA_3P3_SDIO 和 CAP_VDDSHV_MMC 引脚。

7.2.2.2 SD 卡电源复位和引导配置

建议配置由软件启用 (控制) 的电源开关 (负载开关) 为 SD 卡电源 (VDD) 供电。一个固定的 3.3V 电源 (处理器 IO 电源) 连接作为电源开关的输入。

使用电源开关可以对 SD 卡进行下电上电 (因为复位电源开关是复位 SD 卡的唯一方法)，并将 SD 卡复位为默认状态。

建议使用双输入 “与运算” 逻辑来实现所连接器件的复位。处理器通用输入/输出 (GPIO) 连接到与门输入，在输入端附近提供上拉电阻 (以支持引导) 和 $0\ \Omega$ 配置，以隔离 GPIO 用于测试或调试。与门的另一个输入是主域热复位状态输出 (RESETSTATz)。

如果 SD 卡配置为引导器件，建议将为 SD 卡电源供电的外部电源开关默认设为 ON (供电状态)。

有关实现的详细信息，请参阅处理器特定 EVM。

7.2.2.3 信号连接

进行以下连接：

- 为 MMC1_CLK 和 MMC2_CLK (靠近处理器时钟输出引脚) 连接串联电阻器 ($0\ \Omega$)，为 MMC1_CLK 和 MMC2_CLK (靠近所连接器件或 SD 卡插槽时钟输入引脚) 连接外部下拉电阻。
- 为连接到 IO 组的相应双电压 IO (MMC1 = VDDSHV3、MMC2 = VDDSHV4) 电源导轨的数据线路 (MMC1_DAT0-3 和 MMC2_DAT0-3) 和 CMD 信号 (MMC1_CMD 和 MMC2_CMD) 添加外部上拉电阻器 ($47k\ \Omega$) (靠近所连接器件或 SD 卡插槽)。
- 为 MMC1_SDCD 和 MMC1_SDWP 信号添加外部上拉电阻器，并连接到 VDDSHV1 电源导轨 (靠近所连接器件或 SD 卡插槽)。
- 要支持 SD 卡接口，请配置以 VDDSHV1 为基准的 MMC2_SDCD 和 MMC2_SDWP 信号。为 MMC2_SDCD 和 MMC2_SDWP 信号添加外部上拉电阻器，并连接到 VDDSHV1 电源导轨 (靠近所连接器件或 SD 卡插槽)。

请参阅以下常见问题解答：

[[常见问题解答 AM62A7 : 为什么 MMC1 由 VDDSHV0 和 VDDSHV5 这两个不同的电压电源供电？](#)]

[[常见问题解答 AM62A7-Q1 : 如果未使用 SD 卡，如何连接引脚网络 VDDSHV4、VDDSHV5 和 VDDSHV6](#)]

[[常见问题解答 AM6442 : AM6442 MMC1](#)]

[[常见问题解答 AM625 : MMC 接口](#)]

常见问题解答是通用的，也可用于 AM62Lx 处理器系列。

备注

AM62x 的 VDDSHV0 对应于 AM62Lx 的 VDDSHV1

AM62x 的 VDDSHV5 对应于 AM62Lx 的 VDDSHV3

AM62x 的 VDDSHV6 对应于 AM62Lx 的 VDDSHV4

7.2.2.2.4 ESD 保护

建议为数据、时钟和控制信号提供外部 ESD 保护。内部 ESD 保护不能满足板级或系统级 ESD 要求。

7.2.2.2.5 电源轨的电容器

验证是否为 VDDSHV3 和 VDDSHV4 电源导轨和连接器件提供了所需的大容量电容器和去耦电容器。

如果没有可用的建议，请遵循处理器特定 EVM 实现。

备注

请遵循对于数据和控制信号的处理器特定连接建议。建议将时钟输出的串联电阻放置在靠近处理器时钟输出引脚的位置。

7.2.2.2.6 MMC1 SD 卡接口检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接。
2. 引脚属性、信号说明和电气规范。
3. 电气特性、时序参数和任何其他可用信息。
4. 在 MMC1_CLK 上包含一个串联电阻器 (0Ω)，该电阻器应尽可能靠近处理器时钟输出引脚放置以最大限度地减少反射。MMC1_CLK 在读取事务时被内部环回，串联电阻器能够最大限度降低潜在的可能导致错误时钟转换的信号反射情况。最初使用 0Ω 并根据需要调整该值，以匹配 PCB 布线阻抗。
5. MMC1 的 CLK、CMD 和 DAT0-3 信号接口使用连接到 VDDSHV3 供电引脚上的 SDIO 缓冲器实现（该电源可根据传输速度切换到较高数据传输模式而将工作电压从 3.3V 调整到 1.8V）。
6. MMC1 SD_CD 和 SD_WP 信号功能通过由 VDDSHV1（在固定 1.8V 或 3.3V 下运行）供电的引脚上的 LVCMOS 缓冲器实现。
7. SDIO 缓冲器旨在支持动态电压切换。由于 UHS-I SD 卡开始时以 3.3V 信号运行，并在切换到较高数据传输模式时将信号电压变为 1.8V，因此必须进行动态电压切换。

复位期间处理器 IO 缓冲器关闭。对于任何处理器或可悬空的所连接器件 IO，建议使用外部上拉电阻。所有数据和命令信号都建议使用上拉电阻。当使用（提高抗噪性）外部上拉电阻时，验证是否未配置内部上拉电阻。

8. 为了满足 SD 卡规格，当内部上拉电阻意外启用时，建议使用 $47k\Omega$ 上拉电阻。 $47k\Omega$ 上拉电阻可验证产生的拉电阻是否在指定范围内。
9. 当需要 UHS-I SD 卡接口支持时，必须实现能在 3.3V 和 1.8V 之间切换输出的 LDO 电源。开关 IO 电源可以是外部分立式实施，也可以是 PMIC 内部的。将可切换电压输出连接到 IO 组的 IO 电源，并参考 SD 接口信号 (VDDSHV3)。
10. 当需要 UHS-I SD 卡接口支持时，虽然 SD 卡接口的 IO 电压可以是 1.8V 或 3.3V 时，但 SD 卡 VDD 电源应连接到固定的 3.3V 电源。
11. 当需要 UHS-I SD 卡接口支持时，必须通过负载开关切换 3.3V SD 卡电源，以允许将 SD 卡 IO 电源重置为 3.3V。需要进行相应配置，以在复位期间启用 SD 卡负载开关。
12. 必须提供一种机制，使得在热复位和正常运行期间，可以通过处理器的 IO 控制 SD 卡负载开关的 EN 信号来重置负载开关。使用 2 输入“与运算”逻辑。
13. 在启动期间，ROM 代码会检查卡检测引脚 (SD_CD) 的状态。该信号预计为低电平，以指示检测到（插入的）SD 卡。

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 提供所需的大容量电容器和去耦电容器。与 EVM 原理图进行比较。
2. 用于数据、命令和时钟信号的拉电阻值。与相关的 EVM 原理图进行比较。
3. 串联电阻器值和靠近处理器的时钟输出信号上的放置。
4. 当需要 UHS-I SD 卡接口支持时，需验证 IO 组的 IO 电源导轨切换 (3.3V/1.8V) 和 SD 卡电源切换，并确保包含电源开关重置电路。
5. 电源轨连接到 SD 卡电源（使用 SYS 电压）。
6. 实现用于复位 SD 卡电源控制负载开关的复位逻辑。此外，还提供了 SD 卡电源控制电源开关的压摆率控制功能。
7. 电源轨连接遵循 ROC。
8. 为 SD 接口信号提供所需的外部 ESD 保护。

其他

1. 当 UHS-I SD 卡更改 IO 工作电压时，主机的 MMC1_SDCD 和 MMC1_SDWP 输入的逻辑状态不需要改变。如果信号通过会改变电压的双电压 SDIO 单元的输入缓冲器进行传播，则无法保持有效的逻辑状态。信号功能被分配给不动态改变电压的 IO。信号仅连接到 SD 卡连接器中的开关，因此当 SD 卡信号改变工作电压时，信号不会无端改变电压。必须使用 MMC1_SDCD 和 MMC1_SDWP 信号连接到 SD 卡连接器开关，并通过连接到 VDDSHV1 的外部拉电阻器将其上拉至高电平。其他具有上拉电阻的 MMC1 SD 卡信号需要由动态改变电压的 VDDSHV3 源供电。
 2. MMC2_SDCD 和 MMC2_SDWP 引脚以其他 MMC2 引脚的 IO 组的同一 IO 电源组为基准。将 UHS-I SD 卡连接到 MMC2 时需要避免使用 MMC2_SDCD 和 MMC2_SDWP 信号功能的控制。对于 SD 卡用例，需要使用其他引脚多路复用选项之一来实现信号功能，该选项使用由固定电压源供电的 IO 电池。因为 MMC2 最初旨在与板载固定电压 SDIO 器件（例如，Wi-Fi® 或 Bluetooth® 收发器）一起使用，所以 MMC2 分配是不同的。
 3. SD 卡电源开关（具有电源开关电源 EN 引脚复位逻辑）和 IO 组电源的处理器 IO 电源开关电路需要支持 UHS-I SD 卡，以使用 3.3V IO 电平开始通信，然后在更改为更快的数据传输速度之一时更改为 1.8V IO 电平。
- 由于 SD 卡没有复位引脚，因此对 SD 卡进行下电上电是将其恢复到 3.3V 模式的唯一方法。IO 组电源的处理器 IO 电源应与 SD 卡一起断电、上电和切换电压。操作为电路提供信号的电路和软件驱动程序可验证两个器件是否关断或导通，以及是否同时在相同的 IO 电压下运行。
4. 由于处理器 IO 在插入 SD 卡时直接连接到接地端，请在 SDCD 引脚上添加一个 100Ω 的串联电阻器。

7.2.2.3 MMC1/MMC2 SDIO (嵌入式) 接口

有关更多信息，请参阅处理器特定数据表的 **MMC1/MMC2 - SD/SDIO 接口** 一节。

7.2.2.3.1 IO 电源

处理器 MMC1 (CMD、CLK 和数据) 接口 IO 由 VDDSHV3 电源导轨 (MMC1 IO 组的 IO 电源) 供电，MMC2 (CMD、CLK 和数据) 接口 IO 由 VDDSHV4 电源导轨 (MMC2 IO 组的 IO 电源) 供电。

处理器 MMC1 SD 卡检测 (CD) 和写保护 (WP) 信号由 VDDSHV1 电源导轨 (GENERAL1 IO 组的 IO 电源) 供电。建议将 MMC1_SDCD、MMC1_SDWP 的上拉电阻从 SDIO 卡连接到同一电源轨 VDDSHV1。

处理器 MMC2 SD 卡检测 (CD) 和写保护 (WP) 信号由 VDDSHV4 (MMC2 IO 组的 IO 电源) 电源导轨或 VDDSHV1 电源导轨 (GENERAL1 IO 组的 IO 电源) 供电。建议将 MMC2_SDCD、MMC2_SDWP 的上拉电阻从 SDIO 连接到同一电源轨 VDDSHV4 或 VDDSHV1。

7.2.2.3.2 信号连接

进行以下连接：

- 在 MMC1_CLK 和 MMC2_CLK (靠近处理器时钟输出引脚处) 连接串联电阻 (0Ω)，并在 MMC1_CLK 和 MMC2_CLK (靠近连接设备的时钟输入引脚处) 外接下拉电阻。

- 为连接到 IO 组的相应双电压 IO 电源 ($\text{MMC1} = \text{VDDSHV3}$ 、 $\text{MMC2} = \text{VDDSHV4}$) 电源导轨的数据线 (MMC1_DAT0-3 和 MMC2_DAT0-3) 和 CMD 信号 (MMC1_CMD 和 MMC2_CMD) 添加外部上拉电阻 (靠近所连接器件)。
- 为连接到 VDDSHV1 电源导轨的 MMC1_SDCD 和 MMC1_SDWP 信号添加外部上拉电阻 (靠近所连接器件)。
- 为连接到 VDDSHV4 或 VDDSHV1 电源导轨的 MMC2_SDCD 和 MMC2_SDWP 信号添加外部上拉电阻 (取决于所选的引脚 (IO)) (靠近所连接器件)。

7.2.2.3.3 MMC2 SDIO (嵌入式) 接口检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

- 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接。
- 引脚属性、信号说明和电气规范。
- 电气特性、时序参数和任何其他可用信息。
- 在 MMC2_CLK 上包含一个串联电阻器 (0Ω)，该电阻器应尽可能靠近处理器时钟输出引脚放置以尽可能减少反射。为了防止信号反射和错误时钟转换，请使用一个串联电阻器来最大限度地减少 MMC2_CLK 上可能的信号反射， MMC2_CLK 在读取事务时在内部环回。最初使用 0Ω 并根据需要进行调整，以匹配 PCB 布线阻抗。
- 对于 MMC2 CLK 、 CMD 以及 DAT0-3 信号功能，通过由 VDDSHV4 (在 1.8V 或 3.3V 下工作) 供电的引脚上的 SDIO 缓冲器实现。
- MMC2 SDCD 和 SDWP 信号功能通过由 VDDSHV4 或 VDDSHV1 (在固定 1.8V 或 3.3V 下运行) 供电的引脚上的 LVC MOS 缓冲器实现。
- SDIO 缓冲器旨在支持动态电压切换。使用 SDIO 接口时，建议连接固定的 IO 电压 (1.8V 或 3.3V)。
- 复位期间处理器 IO 缓冲器关闭。对于任何处理器或可悬空的所连接器件 IO，建议使用外部上拉电阻。

所有数据和命令信号都建议使用上拉电阻。当使用 (提高抗噪性) 外部上拉电阻时，验证是否未配置内部上拉电阻。作为一种良好的设计实践，当内部拉电阻意外启用时，建议使用 $47\text{k}\Omega$ 上拉电阻以使上拉电阻值处于 SDIO 规格范围内。对于 $47\text{k}\Omega$ ，产生的拉电阻仍在指定范围内。

- 使用处理器 IO 实现所连接器件复位。验证 IO 级兼容性和所需拉电阻的连接 (极性取决于所连接器件)。

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

- 提供所需的大容量电容器和去耦电容器。与 EVM 原理图进行比较。
- 用于数据、命令和时钟信号的拉电阻值。与相关的 EVM 原理图进行比较。
- 串联电阻器值和靠近处理器的时钟输出信号上的放置。
- 复位逻辑的实现。
- 电源轨连接遵循 ROC，是固定电源。

其他

- 验证通过附加卡连接时，是否为接口信号提供了所需的外部 ESD 保护。
- 使用 MMC1 时请遵循类似的指南。使用 MMC1 时，需要进行软件更改，因为 EVM 仅在 MMC2 上实现 SDIO 接口。
- 关于 SDIO 器件提供还是不提供内部拉电阻，没有特定指南。实现嵌入式 SDIO 器件的电路板设计人员应该了解 SDIO 器件提供的功能，并在 SDIO 器件未提供时应用适当的外部拉电阻。大多数处理器 IO 缓冲器在复位期间处于关闭状态，在电路板启动并配置软件之前不会启用。为了防止输入悬空，请对连接到所连接器件输入端的任何信号使用外部拉电阻。
- 对于嵌入式 SDIO 应用，建议通过同一固定式 1.8V 或 3.3V 电源，为 IO 组的 IO 电源供电，该电源用于为 SDIO 接口所连接器件 (例如：Wi-Fi 模块) 的 IO 供电。

7.2.2.4 其他信息

请参阅处理器特定数据表的信号说明、MMC、MAIN域一节中的注释。

7.2.3 八路串行外设接口(OSPI)或四路串行外设接口(QSPI)

备注

OSPI0 接口支持固定的 1.8V IO 接口。验证与所连接器件的 IO 电平兼容性。建议使用同一电源为 IO 组的处理器 IO 电源和连接的器件 IO 电源供电。电路板设计人员必须确保设计中施加的电位不超过绝对最大额定值表中定义的值。

该处理器系列支持 1 个 OSPI、QSPI 接口，最多允许通过 OSPI0 接口连接两个器件。OSPI0 IO 以 VDDS1 为基准，支持固定的 1.8V IO 电平。

有效组合如下所示：

- OSPI + OSPI (更快 - DQS)
- QSPI + OSPI (更快 - DQS)
- OSPI (更快 - DQS)
- QSPI (更快 - LBCLKO)

验证处理器外设的 IO (固定) 所参考的 IO 组的 IO 电源是否与所连接器件的 IO 电压电平兼容。建议将所连接器件的 IO 电源和由所连接处理器外设 IO 所参考的 IO 组的 IO 电源连接到同一电源。

有关详细信息，请参阅处理器特定数据表中的 **OSPI/QSPI/SPI 电路板设计和布局布线指南**一节，或参阅 TI.com 上的相关资料。

请参阅以下常见问题解答：[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM62A/AM62P 定制电路板硬件设计的设计建议/常见错误 - OSPI/QSPI 存储器接口](#)

常见问题解答是通用的，也可用于 AM62Lx 处理器系列。

7.2.3.1 OSPI0 连接到单个器件

建议在使用 1 个器件时，遵循 AM62x 或其他系列处理器的 OSPI0 实现。

7.2.3.1.1 IO 电源

用于 OSPI 或 QSPI 的处理器 IO 由 VDDS1 电源导轨 (OSPI0 IO 组的 IO 电源) 供电。

建议将所连接器件的 VDDS1 和 IO 电源轨连接到同一电源。

连接器件的 VDD (内核电压) 可由独立电源供电。

7.2.3.1.2 OSPI 或 QSPI 器件复位

建议使用双输入“与运算”逻辑来实现所连接器件的复位。处理器通用输入/输出 (GPIO) 连接到与门输入，在输入端附近提供上拉电阻 (以支持引导) 和 0Ω 配置，以隔离 GPIO 用于测试或调试。与门的另一个输入是主域热复位状态输出 (RESETSTATz) 信号。

如果不使用“与运算”逻辑且使用处理器主域热复位状态输出 (RESETSTATz) 来复位所连接器件，请将所连接器件的 IO 电压电平与 RESETSTATz IO 电压电平匹配。建议使用电平转换器来匹配 IO 电压电平。

7.2.3.1.3 信号连接

进行以下连接：

- 为 OSPI0_CLK (靠近处理器时钟输出引脚) 提供串联 (0Ω)，为 OSPI0_CLK 信号 (靠近所连接器件时钟输入引脚) 提供外部下拉电阻。
- 为 OSPI0_LBCLKO (靠近处理器时钟输出引脚) 提供串联电阻 (0Ω)
- CS 引脚和 INT# 引脚连接外部上拉电阻 (靠近所连接器件) 。
- 数据线 (DAT0:7) 连接外部上拉电阻。根据所连接器件内部拉电阻的可用性，组装外部拉电阻。

7.2.3.1.4 环回时钟

验证所需的环回时钟配置。可以使用 OSPI0_LBCLKO (OSPI0 环回时钟输出) 和 OSPI0_DQS (OSPI0 数据选通或环回时钟输入) 进行不同的时钟环回配置。有关以下环回配置，请参阅处理器特定数据表：

- 无环回、内部 PHY 环回和内部焊盘环回

外部电路板级环回

处理器 DQS 或环回时钟与连接存储器器件的 DS 数据选通搭配使用

当所连接器件中有 DS (读取数据选通) 引脚时，请将所连接器件的 DS 引脚连接到处理器的 OSPI0_DQS 引脚。将 OSPI0_LBCLKO 引脚保持未连接状态。

如果当前未使用 DS 引脚，则将处理器的 OSPI0_LBCLKO 输出引脚连接至处理器的 OSPI0_DQS 输入引脚，以便配置外部回送。

如果不使用外部环回，建议将 OSPI0_LBCLKO 和 OSPI0_DQS 引脚保持未连接状态。

备注

为支持传统 x1 命令，处理器 OSPI0 接口的 D0 和 D1 引脚必须连接到 OSPI/QSPI 存储器器件的 D0 和 D1 引脚。不允许数据位交换

7.2.3.2 连接到 2 个器件

OSPI0 接口支持连接 2 个连接器件。

请参阅 EVM 了解实现方式。如需详细了解与 OSPI0 接口相关的应用手册，请参阅处理器特定 ([AM62L](#)) 的产品页面。

7.2.3.3 电源轨的电容器

验证是否为 VDDS1 电源导轨和连接器件 (内核和 IO 电源) 提供了要求的大容量电容器和去耦电容器。

如果没有可用的建议，请遵循处理器特定 EVM 实现。

7.2.3.4 OSPI 或 QSPI 接口实现检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

- 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
- 引脚属性、信号说明和电气规范
- 电气特性、时序参数和任何其他可用信息
- 提供了所连接器件所需的存储器接口配置和建议的连接
- 以接口信号为基准的所连接器件 IO 电源和 IO 组 VDDS1 的 IO 电源连接到同一电源
- 在处理器时钟输出引脚附近提供用于时钟信号的串联电阻器 0Ω 配置
- 为数据和控制信号提供能够悬空的上拉电阻配置。验证电源是否连接到上拉电阻器
- 为时钟输入提供靠近所连接 (存储器) 器件的下拉 $10k\Omega$
- 使用双输入 (RESETSTATz 和处理器 IO) “与运算”逻辑或使用热复位状态输出 RESETSTATz 进行引导时的复位逻辑实现
- 验证处理器和所连接器件之间的复位 IO 级兼容性
- 不建议在复位或电源斜升期间将复位输入上拉至高电平状态
- 基于存储器器件和所选接口 (OSPI 或 QSPI) 的时钟环回配置
- 如果实现了 OSPI 或 QSPI 引导模式，请验证勘误表、所选存储器是否满足 TRM 中描述的引导模式标准 (或 使用 E2E 向 TI 验证)
- 按照建议实现 x1 或 x2 连接器件接口

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 将并联拉电阻器和串联电阻器值的实现方案与 EVM 原理图进行比较
2. 将所连接器件复位逻辑的实现与 EVM 原理图进行比较
3. 将 OSPI0 接口连接到多个连接器件（超过 1 个连接器件）时，请遵循 EVM 或建议的指南
4. 电源轨连接遵循 ROC
5. 基于用例实现外部环回

其他

1. 验证是否遵循了数据表的 **OSPI/QSPI/SPI 电路板设计和布局布线指南** 部分
2. 检查并遵循电气、时序和开关特性

7.2.4 通用存储器控制器 (GPMC)

验证所连接处理器外设的 IO（固定电压或双电压）所参考的 IO 组的 IO 电源是否与所连接器件的 IO 电压电平兼容。建议将所连接器件的 IO 电源和由所连接处理器外设 IO 所参考的 IO 组的 IO 电源连接到同一电源。

有关支持的 GPMC 接口配置，请参阅数据表。

由于具有引脚输出的地址线数量之故，不支持非 Muxed-NOR 接口。**GPMC0_A0-A6** 的说明是 IP 功能说明，而非引脚功能说明。

7.2.4.1 IO 电源

用于 GPMC 接口的处理器 IO 由 VDDSHV0 电源导轨（GPMC IO 组的 IO 电源）供电。

建议将所连接器件的 VDDSHV0 和 IO 电源轨连接到同一电源。

连接器件的 VDD（内核电压）可由独立电源供电。

7.2.4.2 GPMC 接口

验证连接到 GPMC 接口的所连接器件数量。

建议在同步模式下将 GPMC 接口连接到一个器件。使用多个器件或 CSn 时需要拆分板载 GPMC 时钟（和其他接口信号），这会导致信号完整性问题。

在异步模式下连接多个器件时，建议进行详细的时序分析。不建议连接多个器件。在异步模式下连接多个器件时，必须将控制信号路由到多个器件。拆分路由和负载（布线长度和器件数量）问题会影响定制电路板的性能。

7.2.4.3 存储器（连接的器件）复位

如果在使用 GPMC 时使用 NAND 或 NOR 闪存，许多通过 GPMC 连接的存储器会缺少复位引脚。

如果复位引脚可用，请查看复位要求并将复位引脚连接到相关的复位源。

7.2.4.4 信号连接

为 GPMC0_CLK（靠近处理器时钟输出引脚）提供串联电阻器（ 0Ω ）。

建议在 GPMC0_CSn0-3（取决于配置）上使用一个外部上拉电阻，以便在处理器保持复位时或复位后且在软件配置 PADCONFIG 寄存器来启用 TX 缓冲器之前将信号保持在高电平。

7.2.4.4.1 GPMC NAND

NAND 闪存的高电平有效就绪和低电平有效繁忙 (R/B#) 输出为漏极开路，并连接到 GPMC0_WAIT0 和 GPMC0_WAIT1 信号（取决于配置）。建议在靠近所连接器件处提供上拉电阻（通常使用 $4.7k\Omega$ 或 $10k\Omega$ ）。

7.2.4.5 电源轨的电容器

验证是否为 VDDSHV0 电源导轨和连接器件（内核和 IO 电源）提供了要求的大容量电容器和去耦电容器。

如果没有可用的建议，请遵循处理器特定 EVM 实现。

7.2.4.6 GPMC 接口检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引脚连接要求、引脚属性和信号说明
3. 电气特性、时序参数和任何其他可用信息
4. GPMC 接口配置和建议的连接
5. 处理器和所连接器件之间的 IO 级兼容性
6. GPMC 存储器接口配置（NAND 或 NOR 闪存）、使用的接口模式 - 异步或同步时钟模式
7. 允许在异步模式下连接到多个器件，在使用前执行时序和负载计算
8. 处理器 GPMC 时钟输出引脚附近的串联电阻 0Ω
9. 以 GPMC 接口信号为基准的所连接器件 IO 电源和 IO 组 VDDSHV0 的 IO 电源连接到同一电源
10. 验证是否提供了建议或所需的拉电阻
11. 验证是否提供了所需的接口配置和建议的连接
12. 所连接器件与处理器 GPMC 控制器信号的 IO 兼容性
13. 支持的地址和数据范围（如数据表中所述，IO 引脚从器件输出）
14. 所需的 GPMC 接口时序与可行性以及布局效果之间的关系
15. 根据需要添加拉电阻
16. GPMC 存储器 NAND/NOR、地址和数据信号的连接 - 多路复用或多路复用、同步或异步数据位宽度符合 TRM

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 根据连接的存储器提供所需的拉电阻
2. 为任何可以悬空的接口信号提供了拉电阻
3. 电源轨连接遵循 ROC

7.3 外部通信接口（以太网 (CPSW3G0)、USB2.0、UART 和 MCAN)

7.3.1 使用 CPSW3G0 (通用平台 3 端口千兆位以太网交换机) 的以太网接口

备注

以太网接口支持固定 1.8V IO 接口。验证与所连接器件的 IO 电平兼容性。建议使用同一电源为 IO 组的处理器 IO 电源和连接的器件 IO 电源供电。电路板设计人员必须确保设计中施加的电位不超过绝对最大额定值表中定义的值。

CPSW3G0 接口信号以 VDDS0 (GENERAL0 IO 组的 IO 电源) 为基准。VDDS0 的 IO 电平为固定的 1.8V。

CPSW3G0 支持 RGMII (10、100、1000) 和 RMII (10、100) 接口。

验证所选处理器 OPN 的 CPSW3G0 功能的可用性。

验证所连接处理器外设的 IO (固定电压或双电压) 所参考的 IO 组的 IO 电源是否与所连接器件的 IO 电压电平兼容。建议将所连接器件的 IO 电源和由所连接处理器外设 IO 所参考的 IO 组的 IO 电源连接到同一电源。

7.3.1.1 IO 电源

用于以太网接口的处理器 CPSW3G0 IO 由 VDDS0 电源导轨 (GENERAL0 IO 组的 IO 电源) 供电。

建议将所连接器件的 VDDS0 和 IO 电源导轨连接到同一电源 (1.8V)。

连接器件的 VDD (内核电压) 可由独立电源供电。

7.3.1.2 以太网 PHY 复位

建议使用双输入“与运算”逻辑来实现所连接器件的复位。处理器通用输入/输出 (GPIO) 连接到与门输入，在输入端附近提供上拉电阻（以支持引导）和 0Ω 配置，以隔离 GPIO 用于测试或调试。与门的另一个输入是主域热复位状态输出 (RESETSTATz)。

当使用多个 EPHY 时，提供单独复位 EPHY 的配置。

建议根据 EPHY 复位输入引脚配置，在“与运算”逻辑的输出端使用上拉或下拉电阻。在相应时钟有效后，EPHY 需要保持在复位状态，持续指定的最短复位保持时间。

如果不使用“与运算”逻辑且使用处理器主域热复位状态输出 (RESETSTATz) 来复位所连接器件，请将所连接器件的 IO 电压电平与 RESETSTATz IO 电压电平匹配。建议使用电平转换器来匹配 RESETSTATz 和连接的 RESET 输入的 IO 电压电平。

7.3.1.3 以太网 PHY 引脚配置 (strap)

许多 TI EPHY 在复位期间将输出配置为输入，并在释放处理器复位时在配置 (strap) 输入上采集配置（通过电阻进行引脚搭接）信息。在也连接到处理器 IO 的配置 (strap) 输入 (IO) 上需要适当的上拉或下拉。处理器特定 EVM 上使用的 TI EPHY 结合使用了上拉和下拉电阻，从而可以使用每个引脚来配置多种配置模式。在处理器复位期间，IO 缓冲器和内部上拉或下拉电阻处于禁用状态，这样就尽可能减少了 EPHY 向处理器输入缓冲器施加 $1/2\text{ Vs}$ 电势的问题。启用任何相关的处理器输入缓冲器之前，需要将 EPHY 从复位状态配置为正常状态，以驱动有效的逻辑状态。

7.3.1.4 以太网 PHY (和 MAC) 运行和媒体独立接口 (MII) 时钟

验证根据接口用于以太网 PHY 和 MAC 的时钟输入选项。

7.3.1.4.1 晶体

如果使用晶体作为 EPHY 的时钟源，建议将晶体（时钟）规格与处理器晶体（时钟）规格相匹配，以优化性能。

7.3.1.4.2 振荡器

通过使用外部时钟 (LVCMOS) 振荡器作为处理器的时钟源，EPHY 允许使用共享振荡器或单独的振荡器。使用一个振荡器时，请在连接到处理器和 EPHY 之前对时钟输出进行缓冲。

使用一个输出、单缓冲器或者双输出或多输出缓冲器将振荡器的时钟输出连接到处理器和 EPHY。

对于特定用例（使用一个时间敏感网络 (TSN) 的某些工业应用的要求），建议将输入或者两个或更多输出（根据所使用的 EPHY 数量）缓冲器用于处理器和 EPHY。

确认根据建议的指南连接 EPHY 的晶体 XO。

7.3.1.4.3 处理器时钟输出 (CLKOUT0)

为了优化设计，处理器时钟输出 (CLKOUT0) 可用作 EPHY 的时钟输入。时钟输出在内部进行缓冲，适用于点对点时钟拓扑。建议在 CLKOUT0 的源极端安装一个串联电阻，以尽量减少反射。

RGMII EPHY 需要一个与任何其他信号不同步的 25MHz 时钟输入。 25MHz 时钟信号不会有何时序要求，但需要确保 EPHY 不在时钟输入端接收任何非单调转换。

RMII EPHY 时钟选项随 EPHY 控制器或器件配置的不同而变化。

配置为控制器时，大多数 RMII EPHY 需要一个与任何其他信号不同步的 25MHz 输入时钟， 25MHz 时钟信号不会有何时序要求，但务必要确保 EPHY 在其时钟输入端不接收任何非单调转换。

RMII EPHY 为 MAC 提供 50MHz 时钟输出。在 RMII 用例中，相对于 EPHY， 50MHz 数据传输时钟会延迟传递至 MAC。延迟会转换时钟数据时序关系，从而会减小时序裕量。如果延迟过大，逐渐缩小的时序裕度可能会对某些设计造成问题。

配置为器件时，MAC 和 EPHY 使用一个与发送和接收数据同步的 50MHz 公共时钟。 50MHz 时钟在 RMII 规范中定义为供 MAC 和 EPHY 使用的通用数据传输时钟信号，这种情况下，转换预计会同时到达 MAC 和 EPHY 器件引脚。通用时钟可以为发送和接收数据传输提供更好的时序裕量。需要确保 MAC 和 EPHY 不会在时钟输入端接

收任何非单调转换。为了确保时钟信号完整性，建议通过双输出相位对齐缓冲器路由通用时钟信号。建议使用与 $\frac{1}{2}$ 数据信号长度等长的信号布线来连接时钟缓冲器输出，其中一个时钟输出连接到 MAC，另一个连接到 EPHY。

对于 RMII 接口，建议的配置是处理器特定 TRM 中所述的 *RMII 接口典型应用 (外部时钟源)*。如果使用处理器特定 TRM 中所述的 *RMII 接口典型应用 (内部时钟源)* 配置，则必须在电路板级别验证性能。建议提供用于初始性能测试和比较的外部时钟。在处理器和 EPHY 上使用 25MHz 时钟验证了以太网性能 (RGMII)。

可以使用 CLKOUT0 功能为 EPHY 提供 25MHz 或 50MHz 时钟输入。但是，使用 CLKOUT0 信号功能需要软件来配置时钟输出。只要更改配置，作为 EPHY 时钟连接的 CLKOUT0 就可能出现故障。

在相应时钟有效后，EPHY 需要保持在复位状态，持续指定的最短复位保持时间。

未定义处理器时钟输出性能，因为时钟性能受每个定制电路板设计所特有的许多变量的影响。电路板设计人员需要使用实际 PCB 延迟、最小或最大输出延迟特性以及每个器件的最低建立和保持要求来验证所有外设的时序，以确认是否有足够的时序裕量。

7.3.1.5 MAC (数据、控制和时钟) 接口信号连接

建议对以太网 MAC 接口信号使用串联电阻。使用尽可能小的封装 (0402 或更小) 并将串联电阻靠近源极放置。首先，将用于 TDn 信号的串联电阻器 (0Ω 或 22Ω) 放置在处理器引脚附近。对于 RDn 信号，可以使用 EPHY 的内部阻抗控制。如果空间不受限制，建议在 RDn 信号上提供外部串联电阻 (0Ω) 配置。

EPHY 的中断输出可以连接到处理器 EXTINTn (中断) 引脚。建议为 EXTINTn 连接一个靠近处理器的上拉电阻。

7.3.1.6 外部中断 (EXTINTn)

EXTINTn 是一种开漏输出类型缓冲器失效防护 IO。当 PCB 布线连接到焊盘并且外部输入未被主动驱动时，建议连接外部上拉电阻器。开漏输出类型缓冲器 IO 在 IO 上拉至 3.3V 时具有指定的压摆率要求。建议使用 RC 来限制压摆率。

如需更多信息，请参阅常见问题解答：[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM625SIP/AM625-Q1/AM620-Q1/AM62A7/AM62A3/AM62P/AM62P-Q1 定制电路板硬件设计 - EXTINTn 引脚上拉连接](#)

常见问题解答是通用的，也可用于 AM62Lx 处理器系列。

7.3.1.6.1 外部中断 (EXTINTn) 检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引脚属性 (开漏输出 IO 缓冲器) 和信号描述
3. 电气特性 (拉至 3.3V 时的失效防护和压摆率要求) 、时序参数和任何其他可用信息
4. 当连接了信号布线并且未主动驱动时，建议使用外部上拉
5. EXTINTn 是一种开漏输出类型缓冲器失效防护 IO。当连接布线或外部输入时，建议使用外部上拉电阻
6. 开漏输出类型 IO。当拉至 3.3V 电源时，EXTINTn 具有指定的压摆率要求。在输入上添加 RC 来限制压摆率。请参阅 TMDS64EVM

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 使用的上拉电阻值。与 EVM 原理图进行比较
2. 以处理器 VDDSHV1 为基准的上拉电阻 (上拉电阻连接到正确的 IO 电压电平)
3. 压摆率控制的 RC 配置和使用的 RC 值。请参阅 TMDS64EVM

7.3.1.7 MAC (介质访问控制器) 到 MAC 接口

对于需要在处理器之间进行无 EPHY (MAC 至 MAC) 连接的应用 , 建议使用 RGMII 接口 (请与 TI 联系以了解官方是否支持 MAC 至 MAC 接口) , 因为时钟可进行源同步。

当使用 2 个处理器之间的 MAC 至 MAC 接口时 , 验证失效防护运行情况、时钟规格匹配以及 IO 级兼容性。

7.3.1.8 MDIO (管理数据输入/输出) 接口

用于 MDIO 接口的处理器 IO 由 VDDSO 电源导轨 (GENERAL0 IO 组的 IO 电源) 供电。

建议为 MDIO0_MARIO (MDIO 数据) 信号连接外部上拉电阻 (靠近 EPHY) 。

7.3.1.9 包括磁性元件在内的以太网 MDI (介质相关接口)

如果在处理器板上实现了包括磁性元件和 RJ45 连接器在内的 EPHY 和 MDI 接口 , 请遵循处理器特定 EVM 的 MDI 接口连接、 EVM 上使用的建议磁性元件、外部 ESD 保护以及 RJ45 连接器屏蔽层连接至电路接地。

7.3.1.10 电源轨的电容器

验证是否为 VDDSO 电源导轨和连接器件 (内核和 IO 电源) 提供了要求的大容量电容器和去耦电容器。

如果没有可用的建议 , 请遵循处理器特定 EVM 实现。

7.3.1.11 以太网接口检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容 :

1. 上述部分 , 包括相关应用手册和常见问题解答链接。
2. 引脚属性和信号说明。
3. 电气特性、时序参数和任何其他可用信息。
4. MAC 接口配置与建议连接 , 包括串联电阻器 (在处理器 MAC TDn 输出引脚附近的 TDn 信号上 , 以及用于 RDn 信号的所连接器件附近的可选 0Ω 串联电阻器上) 。
5. 处理器 MAC 和 EPHY (所连接器件) 之间具有 IO 级兼容性。建议将所连接器件 IO 电源和以接口信号为基准的 GENERAL0 IO 组 VDDSO 的 IO 电源连接到同一个电源。
6. 处理器和 EPHY 时钟规格匹配。
7. EPHY 和处理器 MAC 的时钟 , 包括根据 EPHY 配置和时钟架构添加缓冲器 (使用通用振荡器和缓冲器或 RMII 接口) 。当时钟输出连接到多个输入时 , 必须使用单独的缓冲器对每个时钟输入进行缓冲。
8. 接口连接、 IO 级兼容性、失效防护操作 (当 MAC 使用不同的电源供电时) 和使用 MAC 至 MAC 接口时的时钟规格匹配。
9. MDIO 接口连接 , 包括在 EPHY 附近添加的 MDIO 数据的上拉电阻。 MDIO 连接到多个器件 , 并在每个 EPHY 附近添加上拉电阻。
10. 当使用 2 个 EPHY 时 , 配置 EPHY 器件地址以通过 MDIO 接口读取内部寄存器。
11. EPHY 复位逻辑的实现。当使用 2 个 EPHY 时 , 建议提供单独复位 EPHY 的配置。

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表 :

1. 提供了靠近处理器输出引脚的处理器 MAC 发送信号 TDn 的串联电阻 , 并使用初始值 (0Ω 或 22Ω) 。
2. 验证 EPHY 复位实现 , 包括 “ 与运算 ” 逻辑、 EPHY 复位输入拉电阻 , 并根据需要与 EVM 进行比较。
3. 使用 2 个 EPHY 且需要 MDIO 接口时 , 验证 EPHY 器件地址配置。
4. 在 EPHY 附近提供 MDIO 数据上拉。
5. 验证 IO 电平兼容性 — 以处理器接口信号为基准的附加器件 IO 组的 IO 电源 (IO 电源导轨) 连接到同一电源。
6. 使用 TI EPHY 时 , 将用于所有 EPHY 电源轨的大容量电容器和去耦电容器与 EVM 原理图进行比较。
7. 为 EPHY 复位 “ 与运算 ” 逻辑的处理器 GPIO 输入提供上拉电阻。
8. MDIO 时钟上的上拉电阻是可选项 (EPHY 可能具有内部下拉电阻 ; 请在数据表中验证) 。

9. 电源轨连接遵循 ROC。
10. 当连接了多个 EPHY 时，提供单独复位 EPHY 的配置。根据需要在 EPHY 复位输入端添加拉电阻。

其他

1. 使用 TI EPHY 时，请按照以下步骤操作：
 - 获得对 EPHY 业务部门或产品线实施情况的审查
 - 验证双电源配置和三电源配置的电源序列要求
 - 根据 EPHY 数据表验证 R_{BIA}S 电阻器容差
 - 选择具有集成磁性元件的 RJ45 连接器，请遵循 EVM
 - 为 MDI 信号提供外部 ESD 保护
 - 将 RJ45 连接器屏蔽层连接到电路接地
 - 提供了建议的大容量电容器和去耦电容器（根据需要参阅 EVM）
2. 使用一个输出、单缓冲器器件或者双输出或多输出缓冲器将振荡器的时钟输出连接到处理器和 EPHY。对于特定用例（使用时间敏感网络（TSN）的某些工业应用的要求），建议将输入和两个或更多输出（根据所使用的 EPHY 数量）缓冲器用于处理器和 EPHY。
3. 当 EPHY 配置为 RMII 从器件（外设）时，建议使用具有通用输入的双输出相位对齐缓冲器。
4. 如果空间不受限制，则考虑在 EPHY 附近的 RD_n 信号上添加 0Ω 串联电阻器。
5. “与运算”逻辑还会执行 IO 电平转换。在优化复位“与运算”逻辑之前，请验证复位 IO 电平兼容性。IO 电平不匹配会导致电源泄漏并影响处理器运行。
6. 根据数据表验证建议，或考虑所连接器件的 EVM 实施，包括端接和外部 ESD 保护。

7.3.2 通用串行总线 (USB2.0)

处理器提供 2 个可配置为主机、器件或双角色器件 (DRD) 的 USB2.0 接口。

建议按照处理器特定数据表的 **USB 设计指南**一节连接 USB_n_VBUS ($n = 0-1$)。处理器特定数据表的 **建议运行条件**一节中定义了 USB_n_VBUS 引脚的电源电压范围。当 VBUS 电源电压电平为 5V 时，所施加的标称输入电压等于电阻分压器输出。

USB_n_ID 功能由任一处理器 GPIO 支持。

备注

USB_n_VBUS 为失效防护输入。失效防护输入仅在 VBUS 电源通过建议的 **USB VBUS 检测分压器/钳位** 电路连接时才有效。

7.3.2.1 使用 USB_n ($n = 0-1$)

建议将 USB 电源 VDDA_CORE_USB (USB0 和 USB1 内核电源)、VDDA_1P8_USB (USB0 和 USB1 1.8V 模拟电源) 和 VDDA_3P3_USB (USB0 和 USB1 3.3V 模拟电源) 连接到器件特定数据表中推荐的电源轨。

直接连接 USB_n_DM ($n = 0-1$) 和 USB_n_DP ($n = 0-1$) 信号（无需任何串联电阻器或滤波电容器）。使用不包含任何残渣或测试点的布线对 USB_n 信号进行布线。

在 USB_n_RCALIB ($n=0-1$)（靠近处理器 RCALIB 引脚）与 VSS 之间连接一个电阻器。有关建议电阻值和容差，请参阅处理器特定数据表。

7.3.2.1.1 USB 主机接口

建议提供一个电源开关来控制外部连接器件的 VBUS 电源，并防止电源开关输入电源过载。

电源开关输出连接到 USB Type-A 连接器。建议将电容器 (> 120 μF) 连接到靠近连接器的 VBUS 电源。

带内部下拉电阻的 USB_n_DRVVBUS ($n = 0-1$) 信号用于启用 VBUS 电源开关。建议在电源开关使能 (EN) 引脚附近使用外部下拉电阻。USB_n_VBUS 的连接 (VBUS 电源输入，包括分压器、钳位) 是可选的。

如果使用的电源开关具有 OC (过流) 指示输出，则上拉 OC 指示输出并连接到处理器 IO (输入)。

7.3.2.1.2 USB 器件接口

VBUS 电源由外部主机供电。器件运行的 USB 标准建议将 $< 10 \mu F$ 的电容器连接到靠近 USB B 型连接器的 VBUS。

在连接到 **USBn_VBUS** 引脚之前，请按照处理器特定数据表的 **USB VBUS 设计指南**一节调节 USB VBUS 电压（USB 接口连接器附近的电源）。

根据用例，如果完全确定电路板不会遇到 $> 5.5V$ （板载供电）的 VBUS 信号电势，则可以删除齐纳二极管。

7.3.2.1.3 USB 双角色器件接口

如果定制电路板设计中使用了 USB Micro-AB 连接器，则来自该连接器的 **USBn_ID** 信号可路由到处理器 GPIO 引脚。**USBn_ID** 可以连接到任何可用的 GPIO 引脚。该 GPIO 引脚在电路板器件树文件中指定，包括 GPIO 引脚的引脚多路复用 (pinmux) 设置。

备注

不支持完全兼容的 USB On-The-Go (OTG) 特性。ID 引脚未进行外部键合。

7.3.2.1.4 USB Type-C®

如果定制电路板设计使用 USB Type-C® 连接器，则不要求 **USBn_ID** 信号连接。DRD 模式开关由 USB Type-C 配套器件控制。

DRP (双角色端口) 需要一个控制器，主要用于根据协商的角色切换电源。在器件不是由 USB Type-C 连接器供电的 USB Type-C 实现方案 (仅限器件模式、USB2.0) 中，无需 USB Type-C 控制器。

- 连接器上的 CC 引脚需要通过 $5.1k\Omega$ 电阻独立接地。
- USB DP 和 USB DM 连接器引脚在 PCB 上短接 (DM=B7:A7 , DP=B6:A6)。无论电缆方向如何，短接都能实现 USB2.0 连接。应使产生的残桩尽可能短。

有关 **USBn_VBUS** 输入调节建议的更多详细信息，请参阅处理器特定数据表的 **USB VBUS 设计指南**一节。

AM62Lx EVM USB0 接口设计可用作实现 USB Type-C 接口的参考。

7.3.2.2 不使用 **USBn (n = 0-1)**

当不使用 USB0 和/或 USB1 时，接口信号和 USB 电源有特定的连接要求。

有关连接接口信号和 USB 电源引脚的信息，请参阅处理器特定数据表的 **引脚连接要求**一节。

建议通过单独的 0Ω 电阻将 USB 电源 (**VDDA_CORE_USB**、**VDDA_1P8_USB** 和 **VDDA_3P3_USB**) 连接到 VSS。

如果使用 USB0 或 USB1 进行未来扩展，请使用尽可能短的布线来连接信号 (**USBn_DM**、**USBn_DP**、**USBn_RCALIB** 和 **USBn_VBUS**)，并连接至测试点或连接器。此外，建议提供连接所需的 USB 电源的配置。

7.3.2.3 其他信息

将 **USBn_DM** 和 **USBn_DP** 信号直接从处理器连接到 USB 集线器上游端口。然后，集线器根据需要将 **USBn** 信号分配到下行端口。由于每个集线器的实施要求不同，建议遵循集线器制造商的建议。

有关 USB2.0 接口的更多信息，请参阅以下常见问题解答：[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM625SIP/AM625-Q1/AM620-Q1 定制电路板硬件设计 - USB2.0 接口](#)

常见问题解答是通用的，也可用于 AM62Lx 处理器系列。

7.3.2.4 USB 接口检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接。
2. 引脚连接要求、引脚属性和信号说明。

3. 引用了电气特性、时序参数和任何其他可用信息的特定标准。
4. 所需的 USB 接口配置（主机或器件）和建议的连接。
5. 基于 USB 接口配置的 USB VBUS 设计指南。在主机配置下，USBn_VBUS 连接是可选的。不建议也不允许将 5V 电源从 USB 连接器直接连接到 USBn_VBUS 引脚。不建议或不允许更改数据表中 VBUS 的建议分压器值。仅当实现了建议的分频器值时，IO 的 VBUS 失效防护功能才有效。
6. 连接建议的 IO 校准电阻器。
7. 连接建议的 USB 电源，包括滤波。
8. USB 信号直接连接。
9. EMI 控制可使用共模扼流圈。添加共模扼流圈会降低信号振幅并降低性能。添加使用 0Ω 电阻器绕过 CMC 的配置。
10. 差分信号和差分阻抗值的标记。
11. 当 USB 接口配置为主机时，实现 USB 电源开关。
12. 使用 DRVVBUS 进行 USB 电源开关使能控制（复位期间启用内部下拉）。
13. 将电源开关 OC 输出连接到处理器 IO。
14. 将 USB 信号连接到 USB 连接器。
15. 在 USB 连接器的 USB VBUS 引脚上提供建议的电容器。
16. 为 USB 接口提供所需的外部 ESD 保护。
17. 如果实现了 USB 引导，请验证勘误表、支持的接口配置、USB 端口和连接。

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. USB 接口连接符合所需的 USB 接口配置（主机或器件）。将接口连接与 EVM 进行比较。
2. 外部 ESD 保护和 CMC 实现，可使用 0Ω 电阻器进行旁通。
3. VBUS 分压器值（请参阅数据表）和容差（1%）。请遵循数据表中的建议。只要保持值、容差和比率，就允许使用多个电阻器。
4. 使用的 VBUS 电容器值与要求（请参阅 EVM）。
5. 电源开关使能连接（如果使用处理器 USBn_DRVVBUS，则不建议也不允许使用上拉电阻，因为 DRVVBUS 启用了内部下拉电阻）。
6. 将电源开关 OC 输出连接到处理器 IO 和 IO 电平兼容性。
7. 电源轨连接遵循 ROC。

其他

1. 如果使用 TI 器件实现 Type-C USB 接口，请获取有关通过相关业务部门或产品线实现的报告。
2. 滤波电源（铁氧体和电容器）用于 VDDA_CORE_USB 和 VDDA_1P8_USB。VDDA_3P3_USB 可以连接到 3V3 SYS 电压。由于滤波器正在持续优化，因此请参阅具体和最新的 EVM 来实现。
3. 验证 USB 接口的失效防护运行情况。在电源斜升之前施加外部接口信号会导致馈电并影响定制电路板功能。
4. 在 USB 数据线上使用 CMC 时，请验证连接（包括极性）。反转极性会使数据信号短路。
5. DNI USBn_DRVVBUS 上拉和下拉电阻，用于实现从深度睡眠状态唤醒。

7.3.3 通用异步收发器 (UART)

备注

以下外设实现了 IOSET：UART、MCAN、MCSPI、MCASP、I2C。确保在定制设计中使用正确的 IOSET。

时序闭合基于 IOSET。

验证所连接处理器外设的 IO（固定电压或双电压）所参考的 IO 组的 IO 电源是否与所连接器件的 IO 电压电平兼容。建议将所连接器件的 IO 电源和由所连接处理器参考的 IO 组的 IO 电源相连接。外设 IO 连接至少同一电源。

验证 UART 接口（外部通信接口或调试）和配置（2 线或 4 线带流量控制）的应用要求。有关支持的 UART 实例数，请参阅处理器特定数据表。

使用外部收发器时，使外部接口信号 IO 电平与 IO 组电压电平的双电压 IO 电源匹配。建议使用同一电源为收发器的 IO 电源和 IO 组 VDDSHVx、VDDSx 或 VDDS_WKUP 的处理器 IO 电源供电。根据需要验证失效防护运行情况，以及上拉电阻电压电平和连接的电源。

建议在接口信号上靠近源极的位置配置串联电阻，用于隔离或调试。

建议在处理器 UART 接收输入端（UARTn_RXD ($n = 0-6$) 和 WKUP_UART0_RXD）使用上拉电阻。验证外部接口信号上拉电阻的可用性，并相应地配置拉电阻。

如果处理器的接口信号直接连接到外部输入，建议使用外部 ESD 保护。

UART 接口经常连接错误。按如下方式连接信号：

- TX 到 RX
- RX 到 TX

如果使用了其他接口信号，请验证连接。

当调试接口 UART 信号直接连接到外部接口时，注意失效防护运行情况和 IO 电平。提供外部 ESD 保护配置。

7.3.3.1 通用异步接收器/发送器 (UART) 检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引脚属性和信号说明
3. 电气特性、时序参数和任何其他可用信息
4. 在源极附近为所有接口信号添加串联电阻，以更大限度地减少反射或隔离，从而进行测试
5. 为任何处理器或所连接器件 IO 添加了可悬空的并联拉电阻
6. 接口信号极性和连接
7. 当接口信号直接连接到外部输入时，可提供外部 ESD 保护
8. 所需速度、已编程波特率与支持的波特率之间的关系，以及时钟分频器不匹配导致的所需与计算误差之间的关系

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 上拉使用的电阻值（ $10\text{k}\Omega$ 或类似）并与 EVM 原理图进行比较。
2. 使用的串联电阻值（ 22Ω ）和放置位置（靠近源极）。
3. 以相应 UART 实例和信号的处理器 VDDSHVx、VDDSx 或 VDDS_WKUP 为基准的上拉电阻。
4. 处理器 VDDSHVx、VDDSx 或 VDDS_WKUP 和所连接器件 IO 电源来自同一电源。
5. 处理器 IO 不具有失效防护功能。不建议也不允许在处理器电源斜升之前施加输入。
6. 电源轨连接遵循 ROC。

其他

1. 验证连接到外部接口信号时的失效防护操作。在处理器电源斜升之前施加外部输入信号会导致馈电并影响定制电路板功能。
2. 根据数据表验证是否已考虑为附加器件实施 EVM（包括端接和外部 ESD 保护）。

7.3.4 模块化控制器局域网 (MCAN)

备注

以下外设实现了 IOSET : UART、MCAN、MCSPI、MCASP、I2C。确保在定制设计中使用正确的 IOSET。

时序闭合基于 IOSET。

验证所连接处理器外设的 IO (固定电压或双电压) 所参考的 IO 组的 IO 电源是否与所连接器件的 IO 电压电平兼容。建议将所连接器件的 IO 电源和由所连接处理器外设 IO 所参考的 IO 组的 IO 电源连接到同一电源。

有关支持的 MCAN 实例数，请参阅处理器特定数据表。处理器的 MCAN 接口包括外部 MCAN 收发器。

使用外部收发器时，使外部接口信号 IO 电平与 IO 组电压电平的双电压 IO 电源匹配。

提供 MCAN 收发器所需的端接。

建议在接口信号上 (靠近源极的位置) 配置串联电阻，用于隔离或调试。

7.3.4.1 模块化控制器局域网检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引脚属性和信号说明
3. 电气特性、时序参数和任何其他可用信息
4. 为所有接口信号添加串联电阻，以更大限度地减少反射或隔离，从而进行测试
5. 为任何处理器或所连接器件 IO 添加了可悬空的并联拉电阻

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 使用的串联电阻值 (0Ω) 和放置位置 (靠近源极)
2. 以相应 CAN 实例和引脚的处理器 VDDSHVx 为基准的上拉封装
3. 处理器 VDDSHVx 和所连接器件 IO 电源来自同一电源
4. 处理器 IO 不具有失效防护功能。在处理器电源斜升之前，不能施加任何输入
5. 电源轨连接遵循 ROC

其他

1. 验证连接到外部接口信号时的失效防护操作。在处理器电源斜升之前施加外部输入信号会导致馈电并影响定制电路板功能。
2. 根据数据表验证是否已考虑为附加器件实施 EVM (包括端接和外部 ESD 保护)。

7.4 板载同步通信接口 (MCSPI、MCASP 和 I2C)

7.4.1 多通道串行外设接口 (MCSPI) 和多通道音频串行端口 (MCASP)

备注

以下外设实现了 IOSET : UART、MCAN、MCSPI、MCASP、I2C。确保在定制设计中使用正确的 IOSET。

时序闭合基于 IOSET。

验证所连接处理器外设的 IO (固定电压或双电压) 所参考的 IO 组的 IO 电源是否与所连接器件的 IO 电压电平兼容。建议将所连接器件的 IO 电源和由所连接处理器外设 IO 所参考的 IO 组的 IO 电源连接到同一电源。

为 SPI 时钟输出 SPI0..3_CLK (MCSPI 0..3) (靠近处理器时钟输出引脚) 提供串联电阻 (22Ω)。

为发送位时钟输出 MCASP0..2_ACLKX (靠近处理器时钟输出引脚) 和发送帧同步信号 MCASP0..2_AFSX (靠近处理器) 提供串联电阻 (22Ω)。

为接收时钟 (接收位时钟) 输出 MCASP0..2_ACLKR 和接收帧同步信号 MCASP0..2_AFSR (靠近所连接器件) 提供串联电阻 (22Ω)。

复位期间处理器 IO 缓冲器关闭。验证是否为 SPI 芯片选择信号 SPI0..3_CS0..3 (MCSPI 0..3) 提供了外部并联拉电阻 (靠近所连接器件) 。将拉电阻器添加到处理器和可悬空的所连接器件输入。

7.4.1.1 MCSPI 检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引脚属性和信号说明
3. 电气特性、时序参数和任何其他可用信息
4. 接口配置和建议的连接 (包括 IOSET)
5. 添加到靠近处理器时钟输出引脚的时钟输出的串联电阻器 (22Ω)
6. 为任何处理器或所连接的可悬空的 IO 添加了并行下拉 (所连接器件时钟输入的下拉电阻)
7. 本文分析 (模拟) 了在连接到多个所连接器件时与性能和信号完整性相关的问题
8. 为所有接口信号添加串联电阻，以更大限度地减少反射或隔离，从而进行测试
9. SPI 数据 D0 和 SPI 数据 D1 位 (数据方向) 的配置

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 使用的上拉电阻值 ($10k\Omega$ 或类似器件)
2. 使用的串联电阻器的电阻值 (22Ω) 与放置位置 (靠近处理器时钟输出引脚)
3. 以相应 MCSPI 实例和引脚的处理器 VDDSHVx 或 VDDSx 为基准的上拉电阻
4. 处理器 VDDSHVx 或 VDDSx 和所连接器件 IO 电源来自同一电源
5. 电源轨连接遵循 ROC

其他

1. 验证连接外部接口连接器 (载波或附加板载) 时的失效防护操作。在电源斜升之前施加外部输入会导致馈电并影响定制电路板功能
2. 根据数据表验证是否已考虑为所连接器件实施 EVM (包括端接)

7.4.1.2 MCASP 检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引脚属性和信号说明
3. 电气特性、时序参数和任何其他可用信息
4. MCASP 接口配置和建议的连接 (包括 IOSET)
5. 添加到靠近处理器时钟输出引脚的时钟输出 (发送位时钟、帧同步) 的串联电阻器 22Ω
6. 为任何处理器或所连接的可悬空的 IO 添加了并行下拉 (时钟输出的下拉电阻)

7. 本文分析（模拟）了在连接到多个所连接器件时与性能和信号完整性相关的问题
8. 为所有接口信号添加串联电阻，以更大限度地减少反射或隔离，从而进行测试

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 使用的上拉电阻值（ $10\text{k}\Omega$ 或类似）并与 EVM 原理图进行比较
2. 使用的串联电阻值（ 22Ω ）和放置位置（靠近处理器引脚）
3. 以相应 MCASP 实例和引脚的处理器 VDDSHVx 或 VDDSw 为基准的上拉电阻
4. 处理器 VDDSHVx 或 VDDSw 和所连接器件 IO 电源来自同一电源
5. 电源轨连接遵循 ROC

其他

1. 验证连接到外部信号时的失效防护运行情况。在电源斜升之前施加外部输入会导致馈电并影响定制电路板功能
2. 验证是否已根据数据表或 EVM 实现的建议对附加器件（包括端接和外部 ESD 保护）进行了考虑
3. 可以将两个器件连接到 MCASP。在对位时钟进行布线（发送位时钟和接收位时钟）时，建议遵循良好或建议的布局实践。使用 IBIS 模型执行仿真。

7.4.2 内部集成电路 (I2C)

备注

以下外设实现了 IOSET：UART、MCAN、MCSPI、MCASP、I2C。确保在定制设计中使用正确的 IOSET。

时序闭合基于 IOSET。

验证所连接处理器外设的 IO（固定电压或双电压）所参考的 IO 组的 IO 电源是否与所连接器件的 IO 电压电平兼容。建议将所连接器件的 IO 电源和由所连接处理器外设 IO 所参考的 IO 组的 IO 电源连接到同一电源。

验证应用是否需要完全符合 I2C 总线规范的 I2C 接口。I2C2（仅当使用具有 *I2C OD FS* 缓冲器类型的所选器件封装引脚时。例如 ANB 封装的 B8、D8）是真正的开漏输出型缓冲器，具有失效防护且完全符合 I2C 规范。I2C 可以支持 3.4Mbps I2C 运行（当 IO 缓冲器（接口）在 1.8V 下运行时）。

备注

对于具有开漏输出类型缓冲器（I2C2）的 I2C 接口，若使用 IO，建议使用外部上拉。

请参阅处理器特定数据表的引脚连接要求一节。建议使用上拉电阻（ $4.7\text{k}\Omega$ ，测试后调节）。

当开漏输出型缓冲器 I2C 接口被拉至 3.3V 电源时，IO 具有指定的压摆率要求。可使用 RC 来限制压摆率。有关 RC 实现，请参阅 EVM 原理图了解实现方式。

有关更多信息，请参阅 [将电源轨连接到上拉电阻](#) 一节。

如果需要额外的 I2C 接口，请使用 I2C0、I2C1、I2C3、WKUP_I2C0 和 I2C2 接口（使用具有 *I2C OD FS* 缓冲类型的封装引脚时除外）。

如果需要额外的 I2C 接口，请使用 I2C0-3 接口（使用具有 *I2C OD FS* 缓冲类型的封装引脚时除外）和 WKPU_I2C0 仿真开漏输出型 I2C 接口。仿真开漏输出 I2C 接口不完全符合 I2C 规范，尤其是下降沿的速度很快（< 2ns）。

连接到仿真开漏输出型 I2C 接口端口的所有器件都需要在下降时间更短的情况下正常运行。仿真开漏输出型 I2C 接口端口支持 100kHz 和 400kHz 运行频率。为 I2C 接口配置 IO 时，建议对 I2C 信号使用上拉电阻。使用尽可能短的残桩连接上拉电阻。

使用串联电阻器来控制下降沿压率。该值取决于定制电路板设计并建议在测试中最终确定。

如需更多信息，请参阅常见问题解答：[【常见问题解答】AM62L：定制电路板硬件设计—I2C 接口](#)

如果计划使用 TI 提供的软件，请将推荐的处理器 I2C 接口连接到 PMIC，因为 WKUP_I2C0 是用于 PMIC 控制的 I2C 接口。

备注

当使用 I2C2 和 I2C3 接口时，请参阅处理器特定数据表的时序和开关特性、外设、I2C 一节中的 I2C3 注释（可以多路复用到多个引脚）。

备注

定制电路板设计期间，请参阅处理器特定数据表的时序和开关特性 - I2C 部分的例外情况。请注意数据表中模拟 I2C 接口的例外情况。添加低通滤波器以减少下降时间或接口速度，从而匹配时序。

7.4.2.1 I2C (开漏输出类型缓冲器) 接口检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接。
2. 引脚连接要求、引脚属性和信号说明。
3. 电气特性（拉至 3.3V 时的失效防护和转换率要求）、时序参数和任何其他可用信息（包括例外情况）。
4. 增加了用于在拉至 3.3V 时控制转换率的漏极开路 IO 输入端 RC。
5. 附加器件地址引脚，通过电阻器 ($>1\text{k}\Omega$) 连接到 IO 电源。
6. 验证目标 I2C 接口时钟速率。I2C 总线的运行速度只能与总线上最慢外设的运行速度一致。如果需要更快的运行速度，请将慢速器件移至另一个 I2C 端口。
7. 验证使用的任何 I2C 接口上是否没有 I2C 地址冲突。处理器上有多个 I2C 端口，因此如果发现冲突，请将冲突器件移至另一条 I2C 总线。如果无法实现，请使用 I2C 总线开关。
8. 请勿在 I2C 线路上放置多组上拉电阻，这可能会导致负载过大和运行错误。选择与所使用的总线速度相称的上拉值。
9. 确保为 IO 组的处理器 I2C IO 电源供电的电源轨与上拉电阻器和所连接 I2C 器件使用的电源电压相匹配。恰当的上拉可以防止器件损坏或由于电压不匹配而导致的错误操作。

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. I2C2（仅当使用选定器件封装的引脚与“I2C OD FS”缓冲类型时。示例：ANB 封装的 B8、D8）控制器具有专用的符合 I2C 标准的开漏输出型缓冲器。
2. 验证使用的上拉电阻值。与 EVM 原理图进行比较或根据负载进行计算。
3. 连接的 I2C 上拉电源幅度遵循所有失效防护 IO 引脚要求下的稳态最大电压。电源阈值取决于连接到 IO 组 IO 电源的电源电压。
4. 配置 RC 来限制压摆率和 RC 值。
5. 处理器 VDDSHVx 或 VDDSx 和所连接器件 IO 来自同一电源。
6. 电源轨连接遵循 ROC。

其他

1. 根据数据表验证是否已考虑为所连接器件实施 EVM。
2. 在设计阶段，请查看数据表的 时序和开关特性的 I2C 例外情况 部分。

7.4.2.2 I₂C (仿真开漏输出类型缓冲器) 接口检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引脚属性和信号说明
3. I₂C 接口配置和建议的连接（包括 IOSET）
4. 电气特性、时序参数和任何其他可用信息（包括例外情况）
5. 附加器件地址引脚，通过电阻器 ($>1\text{k}\Omega$) 连接到 IO 电源
6. 当 IO 配置为 I₂C 接口时，建议使用上拉电阻
7. 请注意处理器特定数据表的时序和开关特性一节中的 I₂C 例外情况。提供串联电阻器配置以控制下降时间

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 验证使用的上拉电阻值
2. 以处理器 VDDSHVx 或 VDDSx 为基准的上拉电阻（I₂C 上拉电阻连接到正确的电压）
3. 添加用于下降时间控制的串联电阻器
4. 失效防护接口（仿真 IO 不具有失效防护功能，在处理器电源电压斜升之前不能施加任何输入）
5. 处理器 VDDSHVx 或 VDDSx 和所连接器件 IO 电源来自同一电源
6. 电源轨连接遵循 ROC

其他

1. 验证连接到外部接口信号时的失效防护操作。在电源斜升之前施加外部输入会导致馈电并影响定制电路板功能
2. 在设计阶段，请查看数据表的时序和开关特性的 I₂C 例外情况部分
3. I₂C 控制器与标准 LVC MOS IO 进行多路复用，以仿真漏极开路

7.5 用户接口 (DPI、DSI)、GPIO 和硬件诊断

7.5.1 显示子系统

备注

AM62Lx 处理器系列为 DPI 和 DSI 接口提供单独的引脚排列。

该处理器系列支持在给定的时间将 MIPI DSI (4 通道 DPHY) 或 DPI (24 位 RGB LVC MOS) 接口连接到外部显示器。

请参阅处理器特定 TRM 的显示子系统和外设一节。

7.5.1.1 显示并行接口 (DPI)

验证所连接处理器外设的 IO (固定电压或双电压) 所参考的 IO 组的 IO 电源是否与所连接器件的 IO 电压电平兼容。建议将所连接器件的 IO 电源和由所连接处理器外设 IO 所参考的 IO 组的 IO 电源连接到同一电源。

7.5.1.1.1 AM62Lx

请参阅常见问题解答：[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM625SIP/AM625-Q1 定制电路板硬件设计 - 显示并行接口 \(DPI\) 24 位 RGB](#)

常见问题解答是通用的，也可用于 AM62Lx 处理器系列。

7.5.1.1.1.1 IO 电源

处理器 DPI 接口由 VDDSHV0 电源导轨 (GPMC IO 组的 IO 电源) 供电。

7.5.1.1.1.2 DPI (连接器件) 复位

建议使用双输入“与运算”逻辑来实现所连接器件的复位。处理器通用输入/输出 (GPIO) 连接到与门输入，在输入端附近提供上拉电阻（以支持引导）和 0Ω 配置，以隔离 GPIO 用于测试或调试。与门的另一个输入是主域热复位状态输出 (RESETSTATz) 信号。

如果不使用“与运算”逻辑且使用处理器主域热复位状态输出 (RESETSTATz) 来复位所连接器件，请将所连接器件的 IO 电压电平与 RESETSTATz IO 电压电平匹配。建议使用电平转换器来匹配 IO 电压电平。

7.5.1.1.1.3 连接

验证显示 (RGB) 连接。

接口支持包括 12、16、18 和 24 位 RGB 有源矩阵显示。当仅将 16 位数据连接到 18 位面板 (BGR565 到 BGR666) 时，请将 D0-D4 连接到 LCD 上的 B1-B5，将 D5-D10 连接到 LCD 上的 G0-G5，并将 D11-D15 连接到 LCD 上的 R1-R5。在 18 位面板上，将 B0 连接到 B5，将 R0 连接到 R5。

7.5.1.1.1.4 信号连接

为 VOUT0_PCLK (像素时钟输出，靠近处理器时钟输出引脚) 提供连接串联电阻器 (0Ω) 的配置。如果空间不受限制，建议为所有其他控制和数据引脚添加串联电阻 (0Ω)。

7.5.1.1.1.5 电源轨的电容器

验证是否为 VDDSHV0 电源导轨和连接器件提供了所需的大容量电容器和去耦电容器。

如果没有可用的建议，请遵循处理器特定 EVM 实现。

7.5.1.1.1.6 DPI (VOUT0) 检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引脚连接要求、引脚属性和信号说明
3. 电气特性、时序参数和任何其他可用信息
4. 在靠近处理器时钟输出引脚的 DPI (VOUT0_PCLK) 时钟输出处添加 0Ω 的串联电阻器
5. 用于控制和数据接口信号的可选串联电阻

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 连接接口信号，包括处理器与连接器件 RGB 和控制信号的 DPI 引脚映射
2. 电源轨连接遵循 ROC
3. 比较使用的 DPI IO 电源的去耦电容器与相关 EVM

其他

1. 是否需要外部 ESD 保护取决于用例

7.5.1.2 显示串行接口 (DSI)

7.5.1.2.1 AM62Lx

7.5.1.2.1.1 使用 DSITX0

处理器 DSITX0 接口由 DSITX0 内核电源 VDDA_CORE_DSI、VDDA_CORE_DSI_CLK 和 DSITX0 1.8V 模拟电源 VDDA_1P8_DSI 供电。

在 DSIO_TXR CALIB 引脚 (靠近处理器) 和 VSS 之间连接一个电阻器。有关建议电阻值和容差 , 请参阅处理器特定数据表。

7.5.1.2.1.1.1 DSITX0 检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容 :

1. 上述部分 , 包括相关应用手册和常见问题解答链接
2. 引脚连接要求、引脚属性和信号说明
3. 电气特性、时序参数和任何其他可用信息
4. 连接建议的 IO 校准电阻器
5. DSIO 接口信号与连接器件的连接 , 包括极性
6. 差分信号和差分阻抗值的标记
7. 配置所需端接
8. 不使用时 , 根据引脚连接要求连接建议的电源和信号

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表 :

1. 使用 DSIO 接口时 , 比较用于 DSIO 模拟和内核电源的铁氧体和电容器
2. 未使用 DSIO 接口时 , 使用可选铁氧体、大容量电容器和 IO 校准电阻器验证 DSIO 模拟和内核电源。但是 , 需要边界扫描功能
3. 验证无边界扫描用例的引脚连接要求
4. 比较电源和信号与相关 EVM 的连接
5. 电源轨连接遵循 ROC

其他

1. 是否需要外部 ESD 保护取决于用例

7.5.1.2.1.2 未使用 DSITX0

不使用时 , DSITX0 对接口信号和电源有特定的连接要求。

有关连接接口信号、电源 (内核和模拟) 的信息 , 请参阅处理器特定数据表的 引脚连接要求 一节。

使用边界扫描功能时 , DSITX0 电源 (VDDA_CORE_DSI 、 VDDA_CORE_DSI_CLK 和 VDDA_1P8_DSI) 需要连接到建议的电源导轨。建议在电源引脚上使用去耦电容器。大容量电容器和铁氧体是可选项。

当不使用边界扫描功能时 , 通过单独的 0Ω 电阻器将 DSITX0 电源 (VDDA_CORE_DSI 、 VDDA_CORE_DSI_CLK 和 VDDA_1P8_DSI) 连接到 VSS 。不建议组装去耦电容器、大容量电容器和铁氧体。

7.5.2 通用输入和输出 (GPIO)

备注

LVC MOS IO 可以以 IO 组的固定 1.8V 或固定 1.8V/3.3V IO 电源为基准。验证与所连接器件的 IO 电平兼容性。建议使用同一电源为 IO 组的处理器 IO 电源和连接的器件 IO 电源供电。电路板设计人员必须确保设计中施加的电位不超过 绝对最大额定值 表中定义的值。

验证所连接处理器外设的 IO (固定电压或双电压) 所参考的 IO 组的 IO 电源是否与所连接器件的 IO 电压电平兼容。建议将所连接器件的 IO 电源和由所连接处理器外设 IO 所参考的 IO 组的 IO 电源连接到同一电源。

请参阅常见问题解答 : [\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 - 数据表引脚属性及引脚连接相关问题](#)

常见问题解答是通用的 , 也可用于 AM62Lx 处理器系列。

7.5.2.1 处理器 GPIO 上 CLKOUT 的可用性

WKUP_OSC0_XO 的缓冲输出可在 WKUP_CLKOUT0 上配置。

7.5.2.2 连接和外部缓冲

建议添加一个串联电阻（其值取决于用例）来限制电流。当需要更高（高于数据表规定值）的电流源时，从外部缓冲 GPIO 输出。

通用处理器 LVC MOS IO 接口指南：

1. 大多数处理器 IO 都没有失效防护功能。在电源斜升之前，不能施加任何输入。
2. 处理器 LVC MOS IO 指定了转换率要求 (<1000ns)，建议不要应用慢速斜升输入或在输入端直接连接电容器。
3. 不建议在输出端连接一个 > 22pF 的电容器负载。DNI 电容器或根据用例执行仿真。
4. 复位期间处理器 IO 缓冲器关闭。建议在由处理器 IO 驱动且可悬空的所连接器件附近放置拉电阻。
5. 对于连接了布线的任何处理器 IO 焊盘，建议使用并联拉电阻。当添加拉电阻是不可行时，请布线远离噪声信号。
6. 验证处理器与连接设备的 IO 之间的 IO 兼容性和失效防护操作。

7.5.2.3 其他信息

除非另有说明，否则未使用的接口上的引脚或焊盘通常可以保留为无连接状态。许多 IO 都有一个焊盘配置寄存器可用于控制 IO 的输入功能（每个 conf_<module>_<pin> 寄存器中的 RXENABLE 字段）。更多详细信息，请参阅处理器特定 TRM 的控制模块一章。在初始化期间，软件可尽快禁用设计中未连接的 IO 接收缓冲器（即 RXENABLE=0）。当相关引脚悬空时，软件不意外启用 IO 接收器（通过设置 RXENABLE 位）。

备注

如需了解配置某些未使用的引脚的具体指导信息，请参阅处理器特定数据表的引脚连接要求一节。

备注

如需了解有关配置 IO 的具体指导信息，请参阅处理器特定 TRM 的焊盘配置寄存器一章。

有关处理器未使用的外设和 IO 的更多信息，请参阅常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM62A/AM62P 定制电路板硬件设计的设计建议/常见错误 - SOC 未使用的外设和 IO。

有关使用的引脚、未使用的引脚和外设处理的更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM62x、AM64x、AM243x，定制电路板硬件设计 - 如何处理已使用/未使用的引脚/外设？（例如 GPIO、SERDES、USB、CSI、MMC（eMMC、SD 卡）、CSI、OLDI、DSI、CAP_VDDSn……）。

常见问题解答是通用的，也可用于 AM62Lx 处理器系列。

7.5.2.4 GPIO 检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接。
2. 引脚连接要求和引脚属性。
3. 电气特性以及任何其他可用信息。
4. 施加到处理器 LVC MOS 输入的输入信号符合压摆率要求。在输入端直接连接一个电容器会增加信号压摆，因此不建议这样做。
5. 不允许将电容负载直接连接到处理器输出以控制或启用所连接器件（建议在使用 > 22pF 的电容负载（占位器件）时进行仿真）。
6. 以 VDDSHVx、VDDSx 或 VDDSWKUP 为基准的所有 IO 引脚连接单个电压电平。每个 IO 都有一个用于为 IO 单元（VDDSHVx、VDDSx 或 VDDSWKUP）供电的相关电源电压。如果 VDDSHVx、VDDSx 或

VDDSWKUP 由 3.3V (1.8V) 电源供电，则所有以 VDDSHVx、VDDSx 或 VDDSWKUP 导轨为基准的 IO 都在 3.3V (1.8V) 电平下运行。

7. 在 VDDSHVx、VDDSx 或 VDDSWKUP 的电源斜升之前，没有向处理器 IO 施加输入电压（不包括失效防护 IO）。大多数处理器 IO 都没有失效防护功能。当 IO 组（VDDSHVx、VDDSx 或 VDDSWKUP）的相应 IO 电源关闭时，不建议也不允许向 IO 施加电压。失效防护 IO 包括 PORz、I2C2（仅当使用具有 I2C OD FS 缓冲器类型的所选器件封装引脚时）。例如，使用建议的 VBUS 分频器时，可以使用 B8、D8（ANB 封装）、EXTINTn 和 USBn_VBUS ($n = 0-1$)。
8. IO 接口的一个常见用例是驱动 LED 进行指示。设计人员可以检查拉电流和灌电流以及对电压电平的影响，并相应地调整 LED 电流。
9. 不建议直接将多个 IO 短接在一起。
10. 基于所需 IO 方向的焊盘配置。
11. 不建议或不允许将具有交替功能的处理器 IO 直接连接到电源或 VSS，包括引导模式输入。电路板设计人员可能遇到固件错误，并且错误配置用于输入（而是将输出驱动为逻辑高电平）的 LVCMOS GPIO。

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 为任何处理器或所连接器件 IO 添加了可悬空的拉电阻。
2. 上拉电阻连接到以 IO 作为基准的同一 IO 组 IO 电源 VDDSHVx、VDDSx 或 VDDSWKUP。
3. 连接到处理器 IO 的所有上拉电阻器的电源电压与施加到相应 IO 组 IO 电源（VDDSHVx、VDDSx 或 VDDSWKUP）的电压相匹配。将信号拉至不同的 IO 电压可能会导致电压泄漏。
4. 针对来自附加电路板或载板或通过外部连接器的外部施加输入的 IO 电平兼容性。
5. 电源轨连接遵循 ROC。

其他信息

1. 有关通用处理器 LVCMOS IO 接口指南，请参阅 [节 7.5.2.2](#)。
 - 大多数处理器 IO 都没有失效防护功能。不建议也不允许在电源斜升之前施加输入。
 - 处理器 LVCMOS IO 指定了压摆率要求，建议不要应用慢速斜升输入或在输入端直接连接电容器。
 - 不建议在输出端连接一个大于 22pF（占位符）的电容器负载。DNI 电容器或根据用例执行仿真。
 - 复位期间处理器 IO 缓冲器关闭。建议在由处理器 IO 驱动且可悬空的所连接器件附近放置拉电阻。
2. 对于连接了布线的任何处理器 IO 焊盘，建议使用并联拉电阻。当添加拉电阻是不可行时，请布线远离噪声信号。复位期间处理器 IO 缓冲器关闭。建议在所连接器件附近使用上拉电阻，以保持连接器件的 IO 输入处于一个已知状态，避免这些输入悬空。是否使用拉电阻取决于所连接器件。
3. 处理器 IO 与通过 IO 连接的附加器件之间具有 IO 兼容性和失效防护操作。
4. 连接到外部信号时进行失效防护操作。在电源斜坡之前施加外部输入会导致馈电并影响处理器性能。
5. 处理器输出的电容器负载（当连接大于 22pF（占位值）的电容器时，设计人员需要进行仿真），输入信号的压摆（LVCMOS 输入压摆率为 1000ns 或更小）。
6. IO 灌电流或拉电流遵循数据表中的建议。
7. 当 IO 直接连接到外部接口信号时，可提供外部 ESD 保护。

7.5.3 板载硬件诊断

7.5.3.1 内部温度监测

温度监测器放置在处理器的预期热点附近，用于读取芯片上的温度传感器数据并在 Linux 中执行热管理。请参阅 [E2E 主题](#)。

处理器上的电压和热管理器（VTM）模块通过提供对片上温度传感器的控制来支持处理器的电压和热管理。

该处理器支持 WKUP 域中的一个 VTM 模块，即 WKUP_VTM0。温度传感器 0 的模拟电源由 VDDA_PLL0（PLL 模拟电源）提供。

如需更多信息，请参阅常见问题解答：[\[常见问题解答\] AM625 / AM623 / AM62A / AM62P / AM64x / AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 - VTM](#)

7.6 模数转换器 (ADC)

7.6.1 使用 ADC0

建议将 ADC0 模拟电源 VDDA_ADC0 连接到处理器特定数据表中建议的电源导轨。

备注

ADC0 输入不具有失效防护功能。不建议也不允许在处理器 ADC 电源斜升之前向任何 ADC0 输入施加电压（超过绝对最大额定值）。施加的输入（基于输入电平）可能导致处理器电源导轨上出现残余电压，从而可能导致电路板启动问题。请参阅处理器特定数据表的绝对最大额定值表。如果需要监控处理器电源斜升之前可用的电源轨，建议通过一个开关将这些输入连接到 ADC0。该开关既可由处理器 GPIO 控制，也可由来自任何电源（包括 PMIC）的电源正常信号控制。

7.6.2 未使用 ADC0

当未使用整个 ADC0 时，对输入和电源导轨有特定的端接要求。当未使用任何 ADC0 输入时，对未使用的输入有特定的端接要求。

如需连接 ADC0 输入、模拟电源引脚，请参阅处理器特定数据表的引脚连接要求一节。

建议通过单独的 0Ω 电阻将 ADC0 输入和处理器模拟电源引脚连接到 VSS。该配置为了将来的扩展或增强而准备，是可选操作。

7.6.3 ADC0 检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 查看选择支持 ADC0 功能的处理器器件型号。
2. 验证 ADC0 模拟电源的连接。
3. ADC0 模拟电源的滤波和去耦电容。
4. 验证 ADC0 输入的连接范围（请参考数据表中推荐的 ADC0 输入范围）和失效防护运行情况。
5. 如果不使用部分或完整的 ADC0，请参阅引脚连接要求。

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 验证 ADC0 模拟电源是否遵循建议的运行条件。
2. 验证所需滤波器和去耦电容器的连接（遵循 EVM 实现）。
3. 验证模拟输入的连接和输入范围。
4. 当未使用部分或完整 ADC0 时，请验证 ADC0 输入的连接。

其他

1. ADC0 输入不具有失效防护功能。仅在 ADC0 电源斜升后施加输入。当 ADC0 输入在 ADC0 电源斜升之前可用时，通过一个由处理器电源或处理器 IO 控制的开关连接 ADC0 输入，以验证失效防护是否运行。

7.7 验证电路板级设计问题

7.7.1 使用 PinMux 工具的处理器引脚配置

建议使用 TI [SysConfig-PinMux](#) 工具验证所有处理器外设和 IO 配置，以确保配置了有效的 IOSET。

有关更多信息，请参阅 SysConfig-PinMux 工具提供的 PinmuxConfigSummary.csv 文件。

7.7.2 原理图配置

验证为替代功能或测试提供的电路选项（这些选项对于电路板正常运行是可选的或可能影响定制电路板性能）是否标记为 DNI。

7.7.3 将电源轨连接到上拉电阻

将信号 (IO) 上拉电阻连接到不同的 IO 电源轨可能会导致处理器 IO 电源轨之间发生泄漏，影响定制电路板性能或处理器可靠性。每个信号都有一个关联的 IO 组 IO 电源（例如，VDDSHVx、VDDSx 或 VDDS_WKUP）。有关更多信息，请参阅处理器特定数据表中的引脚属性表。

例如，要在任何多路复用模式（GPIO0_0）中上拉 SPI0_CLK 信号，请将所连接的信号电源导轨上拉至 VDDS1。

7.7.4 外设（子系统）时钟输出

对于任何具有时钟输出的处理器外设，请配置相应 CTRLMMR_PADCONFIGx 寄存器的 RXACTIVE 位。该位配置是时钟输出正常工作的必需条件。

7.7.5 通用板启动和调试

在启动电路板之前，请验证以下事项：

- 使用的处理器和附加器件符合设计要求
- 已检查电路板的元件组装（DNI（请勿安装））并检查电路板的组装（元件焊接）
- 在施加电路板电源和处理器电源斜升之前，没有外部输入连接到处理器 IO 输入

请参阅常见问题解答：[\[常见问题解答\] Sitara 器件 \(AM64x、AM243x、AM62x、AM62Ax、AM62Px\) 的电路板启动提示](#)

常见问题解答是通用的，也可用于 AM62Lx 处理器系列。

7.7.5.1 电路板启动、测试或调试的时钟输出

处理器上提供以下时钟输出，仅用于测试和调试：

WKUP_SYSCLKOUT0

WKUP_PLL0_HSDIV0_CLKOUT (PER_SYSCLK0) 除以 4 后作为 WKUP_SYSCLKOUT0 从器件发出。该时钟输出仅用于测试和调试目的。

WKUP_OBSCLK0

当 WKUP_OBSCLK_OUTMUX 用于选择 WKUP_HFOSC0 的直接输出时，输出只能用作功能时钟源。

当选择任何其他时钟源时，输出仅可用于测试和调试目的。

SYSCLKOUT0

MAIN_PLL0_HSDIV0_CLKOUT (MAIN_SYSCLK0) 除以 4 后作为 SYSCLKOUT0 从器件发出。该时钟输出仅用于测试和调试目的。

OBSCLK_n [n = 0-1]

当 OBSCLK0_CTRL 用于选择 WKUP_HFOSC0 的直接输出时，输出只能用作功能时钟源。

当选择任何其他时钟源时，输出仅可用于测试和调试目的。

如果未使用名称为 OBSCLK_n [n = 0-1]、WKUP_SYSCLKOUT0、SYSCLKOUT0 的处理器引脚，则提供一个测试点用于测试或调试。建议在这些焊盘上添加拉电阻。

如果使用了时钟输出引脚，可在布线上插入一个测试点，并可提供用于将这些信号与所连接器件进行隔离的配置，从而进行测试或调试。

系统时钟输出引脚（WKUP_SYSCLKOUT0 和 SYSCLKOUT0）通过硬接线连接到专用时钟资源。

7.7.5.2 其他信息

建议为 PORz 提供测试点，以便在不使用时进行测试或调试。

对于具有警报输出、未使用过流指示输出或 PG (电源正常) 输出的其他板载器件 (直流/直流转换器、LDO 或传感器)，提供上拉和测试点用于测试或后续增强。

7.7.5.3 通用板启动和调试检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

1. 添加相关配置，以将可用于调试的 IO 与替代功能隔离
2. 添加相关配置，以便在初始电路板构建期间连接 UART 接口进行调试
3. 添加 JTAG 连接器或测试点配置，以便连接 JTAG 接口，包括外部 ESD 保护。按引脚连接要求放置靠近处理器 JTAG 接口引脚的上拉电阻

原理图审阅

定制原理图设计请遵循以下列表：

1. 如果外部接口信号直接连接到处理器 UART 信号，则为用于调试的 UART 接口提供所需的上拉电阻和串联电阻
2. 当外部接口信号直接连接到处理器 UART 信号时提供外部 ESD 保护

其他

1. 处理器 UART 和大多数 IO 信号都没有失效防护功能。建议仅在处理器电源斜升后应用外部输入
2. 建议在处理器电路板断电时断开外部接口信号

请参阅常见问题解答：[\[常见问题解答\] SK-AM62：不同 UART 的用途](#)

8 定制电路板原理图设计的自我审查

按照用户指南中提供的设计指南，并参考 EVM 原理图及其他可用资料完成原理图设计后，电路板设计人员可以使用每个设计指南部分末尾提供的检查清单进行自我审查。

示例：

处理器内核和外设内核电源检查清单

通用板启动和调试检查清单

常见问题解答列出了对定制电路板原理图进行自我审查时可以遵循的配套资料和步骤：

[\[常见问题解答\] AM62L : 设计建议/定制电路板硬件设计 — 定制电路板原理图自检](#)

常见问题解答列出了在查看客户原理图时发现的常见错误。建议阅读该列表并进行所需的更新：

[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 在客户原理图审查期间观察到的错误列表列](#)

常见问题解答是通用的，也可用于 AM62Lx 处理器系列。

9 布局注释（已添加到原理图中）

建议为处理器外设添加必要的设计注释。例如，USB2.0 接口、以太网接口、显示接口 (DSI0)、eMMC、OSPI、SD 和其他可用的处理器外设。添加的注释可能包括电路板引导模式配置、串联和并联电阻的放置、去耦和大容量电容器的放置。

考虑将所需或适用的设计说明添加到处理器连接的器件和板载器件。

标记所有差分信号和关键信号并指定目标阻抗（根据需要）。请参见以下示例：

- 有关 DDR4 和 LPDDR4 信号的建议目标阻抗，请参阅 [AM62x DDR 电路板设计和布局布线指南](#)。另请参阅 [AM62Ax/AM62Px DDR 电路板设计和布局布线指南](#)。
- USB2.0 数据线的差分阻抗应在 90Ω 标称值的额定容差范围内。
- DSI0 信号的差分阻抗应在 100Ω 标称值的额定容差范围内。

请参阅以下常见问题解答：

[\[常见问题解答\] AM625 : 针对特定外设的 PCB 模式建议](#)

[\[常见问题解答\] AM625 : MMC0 PCB 连接要求](#)

[AM6442 : MMCSD0 \(eMMC\) 和 MMCSD1 \(SD 卡\) 的 PCB 布局指南](#)

常见问题解答是通用的，也可用于 AM62Lx 处理器系列。

9.1 布局检查清单

一般

检查并验证定制原理图设计的以下内容：

- 上述部分，包括相关应用手册和常见问题解答链接
- 是设计为符合处理器特定数据表时序和开关特性部分时序条件表中定义的 PCB 布线延迟要求的定制电路板
- 处理器特定数据表的应用、实施和布局部分，并遵循了相关部分

10 定制电路板设计仿真

存储器 (DDR4/LPDDR4) 的基线驱动阻抗和 ODT 设置源自对 EVM 执行的信号完整性 (SI) 仿真。

由于配置值会有不同，建议对定制设计进行仿真。

请参阅常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM625SIP/AM625-Q1/AM620-Q1/AM62A7/AM62A3/AM62P/AM62P-Q1/
AM6442/AM2432 定制电路板硬件设计 - IO 缓冲器的 S 参数和 IBIS 模型

[常见问题解答] 将 DDR IBIS 模型用于 AM64x、AM62x、AM62Ax、AM62Px

常见问题解答是通用的，也可用于 AM62Lx 处理器系列。

要了解高速 LPDDR4 接口的电路板提取、仿真和分析方法，请参阅 [AM62x DDRA 电路板设计和布局布线指南](#) 应用手册的 [LPDDR4 电路板设计仿真](#)一章。

使用 SysConfig 上的 [DDR 寄存器配置工具](#) 可调节驱动强度。

如需更多信息，请参阅常见问题解答：

[常见问题解答] AM62A7 或 AM62A3 定制电路板硬件设计 - 处理器 DDR 子系统和器件寄存器配置

[常见问题解答] AM62A3-Q1 : AM62A3-Q1 PDN Power SI 仿真问题

常见问题解答是通用的，也可用于 AM62Lx 处理器系列。

11 其他参考内容

其他参考资料包含针对特定处理器的常见问题解答和定制电路板设计硬件设计注意事项文档。连接器件（包括 PMIC 和 EPHY）的原理图。

11.1 有关 AM6xx 处理器系列的常见问题解答

以下常见问题解答汇总了在原理图设计和原理图审阅期间可以参考的主要配套资料：

[常见问题解答] AM64x、AM243x、AM62x、AM62Ax、AM62Px 定制电路板硬件设计 - 原理图设计和原理图审阅期间用于参考的配套资料

备注

使用 EVM PDF 原理图进行定制电路板原理图审阅时，请点击常见问题解答链接，了解更多信息。

11.2 常见问题解答 - 处理器产品系列和 Sitara 处理器系列

根据与电路板设计人员的交互、多个电路板设计人员的询问以及从电路板设计人员的询问中学习，创建了常见问题解答，用于回答一些常见设计问题或提供设计指南，以便在定制电路板设计期间为电路板设计人员提供支持。请参阅下面的常见问题解答列表。客户可在定制电路板设计期间使用该列表以及其他可用设计配套资料（包括 定制电路板设计硬件设计注意事项 和 原理图设计指南和原理图审阅检查清单）：

AM62Lx 处理器系列：

[常见问题解答] AM62L : 定制电路板硬件设计 - 与处理器配套资料、功能、外设、接口和 EVM 相关的常见问题解答

AM62Ax 处理器系列：

[常见问题解答] AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1 定制电路板硬件设计 - 与处理器配套资料、功能、外设、接口和入门套件相关的常见问题解答

常见问题解答包含与 AM62D-Q1 处理器系列相关的常见问题解答。

AM62Px 处理器系列：

[常见问题解答] AM62P、AM62P-Q1 定制电路板硬件设计 - 与处理器配套资料、功能、外设、接口和入门套件相关的常见问题解答

AM62x 处理器系列：

[常见问题解答] AM625、AM623、AM625SIP、AM625-Q1、AM620-Q1 定制电路板硬件设计 - 与处理器配套资料、功能、外设、接口和入门套件相关的常见问题解答

Sitara 处理器系列：

[常见问题解答] 定制电路板硬件设计 - 所有 Sitara 处理器 (AM62x、AM64x、AM243x、AM335x) 系列的主要 (完整) 常见问题解答列表

请参阅下面的常见问题解答链接，其中列出了所有可用的常见问题解答，包括与软件相关的常见问题解答：

[常见问题解答] AM6x：有关 AM62x、AM64x、AM24x、AM3x、AM4x Sitara 器件的最新常见问题解答

11.3 处理器连接器件

[以太网 PHY PCB 设计布局检查清单](#)

备注

验证 [TI.com](#) 上所连接器件的器件特定原理图审阅检查清单的可用性，并使用可用检查清单验证自定义电路板原理图实现。

12 总结

本使用指南作为设计指南提供给电路板设计人员在定制电路板原理图设计和审阅过程中使用。本使用指南中提供的建议有助于设计人员简化电路板设计、减少原理图错误、缩短电路板启动时间、缩短电路板调试时间，以及更大程度地减少日后重新设计电路板的工作。

13 术语

ADC	模数转换器
BOM	物料清单
CAN	控制器局域网
CPPI	通信端口编程接口
CPSW3G	通用平台 3 端口千兆位以太网交换机
DFU	器件固件升级
DNI	请勿安装
DPI	显示并行接口
DRD	双角色设备
E2E	工程师对工程师
ECC	错误校正码
EMC	电磁兼容性
EMI	电磁干扰
eMMC	嵌入式多媒体卡
EMU	仿真控制
EOS	电过应力
ESD	静电放电
ESL	有效串联电感
ESR	有效串联电阻
常见问题解答	常见问题解答
FET	场效应晶体管
GPIO	通用输入/输出
GPMC	通用存储器控制器
HS-RTDX	高速实时数据交换

I₂C	内部集成电路
IBIS	输入/输出缓冲器信息规范
IEP	工业以太网外设
JTAG	联合测试行动组
LDO	低压降
LVCMOS	低压互补金属氧化物半导体
MAC	介质访问控制器
MCASP	多通道音频串行端口
MCSPI	多通道串行外设接口
MDI	媒体相关接口
MDIO	管理数据输入/输出
MMC	多媒体卡
MMCSD	多媒体卡/安全数字
ODT	片上端接
OPN	可订购器件型号
OSPI	八线串行外设接口
PCB	印刷电路板
PDN	配电网络
PET	功耗估算工具
PMIC	电源管理集成电路
POR	上电复位
QSPI	四线串行外设接口
RGMII	简化千兆位媒体独立接口
RMII	简化媒体独立接口
ROC	处理器特定数据表建议的运行条件
SD	安全数字
SDIO	安全数字输入输出
SPI	串行外设接口
TCK	测试时钟输入
TDI	测试数据输入
TDO	测试数据输出
TEN	测试使能
TMS	测试模式选择输入
TRC_DATA_n	跟踪数据 n
TRM	技术参考手册
TRST_n	复位
UART	通用异步收发器
WKUP	唤醒
XDS	扩展开发系统
ZQ	器件校准基准

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

版权所有 © 2025 , 德州仪器 (TI) 公司